

CONTRIBUTION



เครื่องวัดแบบรูปการແຜกระจายคลื่นของสายอากาศ

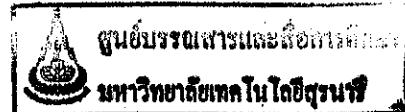
โดย

นางสาวเก้าอี้ทราย คำพิคุล B4606765

นายศรันย์ คัมภีร์ภัทร B4608998

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวกรรมโภคภัณฑ์ สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีการศึกษา 2549



โครงการ	เครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ	
โดย	นางสาวแก้วทรา คำพิฤต	B4606765
	นายศรันย์ กัมกีรภัทร	B4608998
อาจารย์ที่ปรึกษา	พศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์	
สาขาวิชา	วิศวกรรมโทรคมนาคม	
ภาคการศึกษาที่	3/ 2549	

บทคัดย่อ

การที่จะเลือกใช้สายอากาศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานแต่ละด้าน จึงควรรู้ถึงคุณสมบัติของสายอากาศแบบนี้ว่ามีแบบรูปการกระจายคลื่นของสายอากาศเป็นแบบใด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่างๆ และเพื่อความสะดวกในการวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศว่ามีลักษณะของแบบรูปเป็นอย่างไร โครงการนี้จึงได้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ ซึ่งได้มีการออกแบบและสร้างภาคควบคุมการหมุนของสายอากาศและโปรแกรมแสดงผลการวัด โดยขั้นตอนนี้จะได้ในรูปของกราฟฟิกแบบวงกลมและแบบตั้งฉากตามมาตรฐาน และได้ทำการออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz ที่มีการแพร่มาจากสายอากาศภาคสั่ง แล้วแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อทำการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา พศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดเริ่มแรกของเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ เพื่อให้เป็นวงจรภาครับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากสายอากาศภาคสั่ง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแนวคิด การคุ้มครองสิทธิ์ในสังคมตามงาน ซึ่งแนะนำพกพ่อง ตลอดจนช่วยฝึกฝนและให้การสนับสนุนขณะผู้จัดทำให้มีความสามารถในการทำโครงงานจนเสร็จผลงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับได้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรสาขาสาขาวิศวกรรมโทรคมทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอด พี่นักศึกษาปริญญาโทและเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเพื่อนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มามาโดยตลอด

คณะผู้จัดทำได้ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้กล่าวไปแล้วไว้ ณ ที่นี่ สำหรับส่วนตื้อของโครงงานชิ้นนี้ ขออุทิศให้แก่อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่คณะผู้จัดทำ

ภาณุพันธุ์ คำพิจุล

ศรีนันท์ คันธีรภัทร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตการทํางาน	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎี	3
2.1 วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์	3
2.2 วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz (Amplifier)	6
2.3 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low Pass Filter)	7
2.4 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส (Rectifier)	8
2.5 สรุป	10
บทที่ 3 การออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz	11
3.1 กล่าวนำ	11
3.2 วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์	11
3.3 วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz (Amplifier)	13
3.4 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low Pass Filter)	17
3.5 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส (Rectifier)	20
3.6 สรุปเพื่อการออกแบบและการสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การทดสอบเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ	25
4.1 กล่าวนำ	25
4.2 ขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาค่าลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ภาครับ	26
4.3 วัดค่าลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	28
4.4 สรุปการทดสอบเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ	39
บทที่ 5 วิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ	40
5.1 กล่าวนำ	40
5.2 ปัญหาที่พบในระหว่างการทำโครงการและวิธีแก้ปัญหา	40
5.3 ข้อเสนอแนะ	41
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อไป	41
5.5 บทสรุป	41
บรรณานุกรม	43
ภาคผนวก ก	44
โปรแกรม CodeVisionAVR C Compiler Evaluation	44
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 6	48
ภาคผนวก ข	65
ตารางแสดงผลค่าลังงานวัดค่าลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งในระนาบ E และระนาบ H	66
ภาคผนวก ค	86
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำโครงการ	86

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
รูปในการปฏิบัติโครงการ	89
Data Sheet	91
Amplifier HMC414MS8G	92
Surface Mount RF Schottky Barrier Diodes HSMS-282x Series	100
High-speed diodes 1N4148	113
Dual Operational Amplifier LM358	121
6-Pin DIP Optoisolators Transistor Output	133
N-Channel Enhancement Mode IRFZ44N TrenchMOS TM Transistor	139
คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128	147
 ประวัติผู้เขียน	 164

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราขยายของ Amplifier ที่ค่า Power Level ต่างๆ	16
ตารางที่ 3.2 แสดงอัตราขยายของ Amplifier 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน	16
ตารางที่ 3.3 แสดงค่าระดับแรงดันที่ค่า Power Level ต่างๆ	19
ตารางที่ 3.4 แสดงค่าระดับแรงดันเอาท์พุตที่ค่า Power Level ต่างๆ	22
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าแรงดันที่ภาครับรับได้เมื่อสายอากาศไม่มีหมุน	27
ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของปั๊มห้าที่พับ และวิธีแก้ปั๊มห้าของโครงงาน	40

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงผัง ไดอะแกรมของโครงงาน	3
รูปที่ 2.2 นาฬอเรอร์แบบมีสาย 6 เส้น	3
รูปที่ 2.3 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างสเต็ปมอเตอร์	4
รูปที่ 2.4 สเต็ปมอเตอร์ ชนิดมีสาย 6 เส้น	4
รูปที่ 2.5 การสั่งงานควบคุมการหมุนของ สเต็ปมอเตอร์ แบบ Half Step	5
รูปที่ 2.6 วงจรขับ สเต็ปมอเตอร์	6
รูปที่ 2.7 วงจรภายใน MMIC เมอร์ HMC414MS8G	6
รูปที่ 2.8 แสดงวงจร Envelope Detector	7
รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์และชื่อขาใช้งานพื้นฐานของอป.แอมป์	8
รูปที่ 2.10 Non-Inverting Op-amp	8
รูปที่ 2.11 วงจรบริดจ์ rectifier ไฟอ่อร์ (Bridge Rectifier)	9
รูปที่ 2.12 รูปคลื่นวงจรบริดจ์ rectifier ไฟอ่อร์	9
รูปที่ 3.1 (ก) วงจรขับมอเตอร์	11
รูปที่ 3.1(ข) ชุดวงจรขับมอเตอร์	11
รูปที่ 3.2 Microcontroller และชุดวงจรขับมอเตอร์	12
รูปที่ 3.3 สายอากาศที่ควบคุมการหมุนด้วยสเต็ปมอเตอร์	12
รูปที่ 3.4 (ก) วงจรของตัว Amplifier	13
รูปที่ 3.4 (ข) ลายวงจรที่ใช้ในการกัดแผ่น Print	14
รูปที่ 3.5 แสดง Transmission Line บนแผ่น Print	14
รูปที่ 3.6 วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz	15
รูปที่ 3.7 ภาพแสดงอัตราขยายของ Amplifier โดยใช้เครื่อง Spectrum Analysis	15
รูปที่ 3.8 กราฟแสดงอัตราขยายของ Amplifier ที่ค่า Power Level ต่างๆ	17
รูปที่ 3.9 (ก) วงจร Envelope Detector	17
รูปที่ 3.9 (ข) ลายวงจรที่ใช้ในการกัดแผ่น Print ของวงจร Envelope Detector	18
รูปที่ 3.10 วงจร Envelope Detector	18
รูปที่ 3.11 กราฟแสดงการทดสอบวงจร Envelope Detector	18
รูปที่ 3.12 (ก) วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส	20

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.12 (ข) ลายวงจรที่ใช้ในการกัดแผ่น Print ของวงจร	20
รูปที่ 3.13 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส	21
รูปที่ 3.14 วงจร Envelope Detector วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส	21
รูปที่ 3.15 กราฟแสดงการทดสอบวงจร Envelope Detector	23
รูปที่ 3.16 วงจรย่อต่างๆ ถูกบรรจุลงในกล่องชุดอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ	24
รูปที่ 3.17 กล่องชุดอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ	24
รูปที่ 4.1 แสดงระบบโดยรวมของระบบห้องทดลอง	25
รูปที่ 4.2 แสดงค่าแรงดันที่ภาครับรับได้เมื่อสายอากาศไม่หมุน	28
รูปที่ 4.3 แสดงเม็ดโปรแกรมภาษา C	29
รูปที่ 4.4 ทำการ Compile	29
รูปที่ 4.5 Setup ค่าต่างๆ	30
รูปที่ 4.6 เม็ดไฟล์ที่ได้จากการ Compile	30
รูปที่ 4.7 ทำการโหลดโปรแกรมภาษา C	31
รูปที่ 4.8 เปิดโปรแกรม Visual Basic 6	31
รูปที่ 4.9 รันโปรแกรม	32
รูปที่ 4.10 หน้าต่างโปรแกรมหลังจากที่รันโปรแกรม	32
รูปที่ 4.11 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ Polar Plot	33
รูปที่ 4.12 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ Rectangular	33
รูปที่ 4.13 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ Table	34
รูปที่ 4.14 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นแบบ Polar Plot ที่ทำการ Normalize	34
รูปที่ 4.15 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นในระนาบ E ครั้งที่ 1	35
รูปที่ 4.16 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นในระนาบ E ครั้งที่ 2	36
รูปที่ 4.17 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นในระนาบ H ครั้งที่ 1	37
รูปที่ 4.18 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นในระนาบ H ครั้งที่ 2	38

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ในอดีตการสื่อสารแบบไร้สายยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในย่านความถี่สูงหายากและมีราคาแพงค่อนข้างมากซึ่งบังคับต้องซื้อจากต่างประเทศ อุปกรณ์มีขนาดเล็กมาก และไม่มีโปรแกรมช่วยในการออกแบบที่ดี

ปัจจุบันพบว่าเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสื่อสารวิทยุไร้สาย ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และคอมพิวเตอร์ไร้สาย เป็นต้น จึงทำให้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในย่านความถี่สูงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ก้าวไปไกลขึ้น ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในย่านความถี่สูงหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก ข้อมูลและโปรแกรมในการออกแบบสามารถหาได้ง่ายจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น และยังสามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องวัดแบบรูปการແຜ່ງกระจายคลื่นของสายอากาศ ได้ทำการออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่แพร่ออกมานาจากสายอากาศภาคสั่ง ที่ย่านความถี่ 2.45 GHz แล้วคืนอุดมสุก เตตสัญญาณข่าวสารที่เป็นรูปคลื่นขยายตัวที่ความถี่ 1 kHz เพื่อนำมาวิเคราะห์ในรูปของค่าแรงดัน และทำการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แสดงผลแบบรูปการແຜ່ງกระจายคลื่นของสายอากาศ ได้ทั้งแบบตาราง แบบวงกลม และแบบตั้งฉากตามมาตรฐาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz เพื่อใช้เป็นวงจรภาครับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากสายอากาศภาคส่งได้
- 1.2.2 เพื่อศึกษาออกแบบวงจรคืนอูเดเตอร์ในการแยกสัญญาณคลื่นรูปضايان์ขนาดความถี่ 1 kHz เพื่อนำไปวิเคราะห์ในรูปของแรงดัน
- 1.2.3 เพื่อศึกษาออกแบบวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอล
- 1.2.4 เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ทำการประมวลผลและแสดงผลได้ตามที่กำหนด

1.3 ขอบเขตการทำงาน

- 1.3.1 ออกแบบและสร้างเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ ให้เชื่อมต่อ กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- 1.3.2 ออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz พร้อมวงจรประกอบอื่นๆ
- 1.3.3 สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรับค่าของแรงดันที่ได้จากการส่งของสายอากาศ ภาคส่งนาฬิกาแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศที่วัดได้ทางคอมพิวเตอร์ เมื่อสายอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางทุกๆ 0.9° จนครบ 360°

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

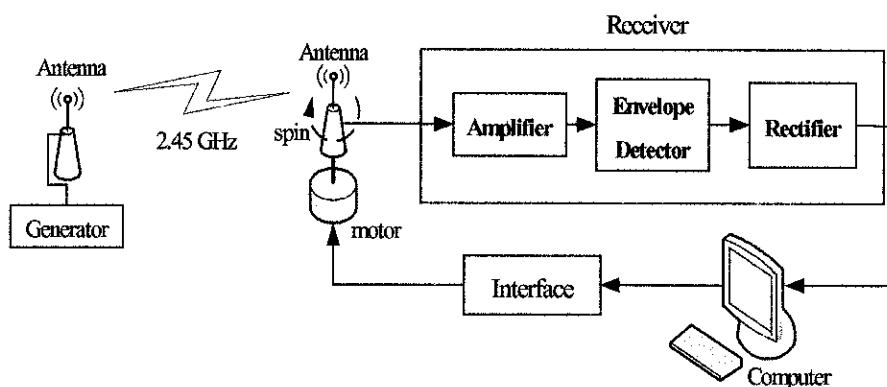
- 1.4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ
- 1.4.2 วางแผนโครงการในการสร้างเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ
- 1.4.3 เรียนโครงการและนำเสนอโครงการกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- 1.4.4 ทำการออกแบบวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุ
- 1.4.5 ทำการออกแบบวงจรการแปลงสัญญาณ Analog ไปเป็นสัญญาณ Digital
- 1.4.6 ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ
- 1.4.7 นำเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศมาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 1.4.8 ทดสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์
- 1.4.9 สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน
- 1.4.10 นำเสนอโครงการ

บทที่ 2

ทฤษฎี

เครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระชาຍคลื่นของสายอากาศ ได้ทำการออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่เพรื่อออกแบบจากสายอากาศภาคสั้น ที่ย่านความถี่ 2.45 GHz โดยวงจรภาครับมีองค์ประกอบที่สำคัญดังรูปที่ 2.1 และมีรายละเอียดดังนี้

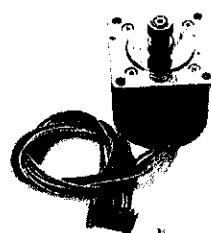
- วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์
- วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz (Amplifier)
- วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low Pass Filter)
- วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส (Rectifier)



รูปที่ 2.1 แสดงแผนผังไดอะแกรมของโครงงาน

2.1 วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์[1]

สเต็ปมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ขับเครื่องด้วยพลัสด์ ลักษณะการขับเคลื่อน จะหมุนรอบแกนได้ 360° มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง แต่มีลักษณะเป็นสเต็ป โดยแต่ละสเต็ปจะขับเคลื่อนได้ 1° , 1.5° , 1.8° หรือ 2° แล้วแต่ละโครงสร้างของมอเตอร์ ลักษณะที่นำมอเตอร์ไปใช้จะเป็นงานที่ต้องการตำแหน่งแม่นยำ โครงสร้างของสเต็ปมอเตอร์เป็นดังรูปที่ 2.2



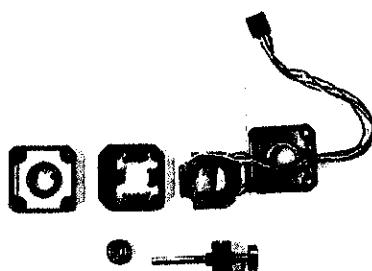
รูปที่ 2.2 มอเตอร์แบบมีสาย 6 เส้น

2.1.2 ความรู้เบื้องต้นและหลักการทำงานของสเตปมอเตอร์

สเตปมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่มีลักษณะคือ เมื่อเราป้อนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ ทำให้หมุนเพียงเล็กน้อยตามเดินรอบวงและหยุด ซึ่งต่างจากมอเตอร์ทั่วไปที่จะหมุนทันทีและตลอดเวลาเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า ข้อดีของสเตปมอเตอร์คือสามารถกำหนดตำแหน่งของ การหมุนได้ด้วยตัวเลข (เป็นองศาหรือระยะทาง) อย่างละเอียด โดยใช้สัญญาณที่สร้างจากคอมพิวเตอร์หรือในโครค่อนโตรลเลอร์

2.1.3 โครงสร้างภายในของสเตปมอเตอร์

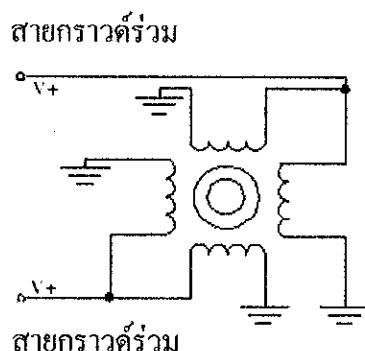
โครงสร้างของขั้วแม่เหล็กบน Stator ทำมาจากแผ่นเหล็กวงแหวนที่มีช่องอากาศ ประกอบกันเป็นชั้นๆ โดยที่แต่ละชั้นจะมีคลาดพันสามอยู่ เมื่อมีการป้อนกระแสผ่าน คลาดพัน ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ถ้าเพิ่มจำนวนของขั้วแม่เหล็ก มากขึ้นจะเพิ่มจำนวนของ Step ต่อว่างรอบมากขึ้นแสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างสเตปมอเตอร์

2.1.4 การตรวจสอบหาสาย กราวด์ร่วม และสาย กราวด์ ของ สเตปมอเตอร์ แบบ PM

ชนิดที่เป็นกราวด์ร่วมภายนอก สเตปมอเตอร์ แบบนี้มีสายอยู่ 6 เส้น คือ สายที่เป็น สายกราวด์ร่วม 2 เส้น และสายที่เป็นกราวด์ 4 เส้น ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 สเตปมอเตอร์ ชนิดมีสาย 6 เส้น

สาย 1 เส้น จะ Drive กราวด์ 2 เส้น ในการเช็คให้ใช้มิเตอร์วัดสายที่เป็น ก่อน โดยการตั้ง range ของมิเตอร์ที่ R*1 จับที่สายที่จะวัด ถ้าหากวัดสายกราวด์ร่วม เทียบกับสายกราวด์ได้ถูกต้องค่าความด้านทานที่อ่านได้จะน้อย แต่ถ้าวัดผิดสาย คือวัดสายกราวด์เทียบ กับกราวด์ค่าความด้านทานที่อ่านได้จะสูงกว่าแต่ถ้าวัดสายกราวด์ร่วม เทียบกับสายกราวด์ ที่ไม่ใช่คู่กันแล้ว เนื่องมิเตอร์ก็จะไม่ระดิก เมื่อเราทราบว่าสายเส้นใดเป็นสายกราวด์ร่วม แล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าสายกราวด์เส้นใดเป็นเฟสที่ 1 เฟสที่ 2 เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ใน การเรียงเฟสนั้นให้ใช้มิเตอร์วัดโดยนำ V+ เข้าที่สายกราวด์ร่วม วัดเทียบกับสายกราวด์เส้นใด ก็ได้ 1 เส้น จะทำให้แกนrotateลื่นไปข้างหน้า 1 สเต็ป เมื่อเปลี่ยนสายกราวด์เส้นแรก เป็นเส้นที่ 2 ถ้ามอเตอร์ไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแสดงว่าการเรียงเฟสไม่ถูกต้องก็ให้วัดเทียบ กับสายกราวด์เส้นใหม่ต่อไป หากสเต็ปมอเตอร์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามกัน วัดที่สายกราวด์เส้นต่อไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้ทราบว่าสายเส้นใดเป็นเฟสแรก สายเส้นใดเป็นเฟสที่ 2 เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4

2.1.5 การสั่งงานควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์แบบ Half Step [2]

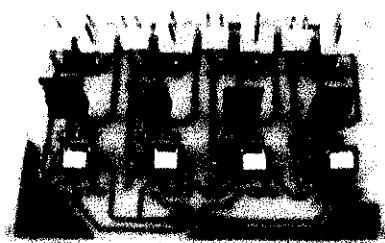
เป็นรูปแบบผสมผสานของการกระตุนระหว่างแบบ Wave กับแบบ 2 Phase เพื่อ ให้ได้จำนวนรอบของสเต็ปมากขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งจะทำการกระตุนชุดคลอดเรียงกันไป เรื่อยๆ เป็นลำดับ แสดงดังรูปที่ 2.5 ข้อดีคือการกระตุนแบบนี้จะให้แรงบิดที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงสเต็ปที่มีระยะสั้นลง และอีกประการหนึ่งคือแต่ละสเต็ปจะเกิดแรงดึงจาก ชุดคลอด 2 ชุดที่ถูกกระตุนพร้อมกัน เป็นผลให้ค่าตำแหน่งความถูกต้องมากขึ้นไปด้วย ส่วนข้อเสียคือ ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นเป็น 2 เท่าของแบบ Wave

Step	เฟส 1	เฟส 2	เฟส 3	เฟส 4
Step 1	ON	ON	OFF	OFF
Step 2	ON	ON	OFF	OFF
Step 3	OFF	ON	OFF	OFF
Step 4	OFF	ON	ON	OFF
Step 5	OFF	OFF	ON	OFF
Step 6	OFF	OFF	ON	ON
Step 7	OFF	OFF	OFF	ON
Step 8	ON	OFF	OFF	ON
Step 9	ข้อนอกสัม Step ที่ 1			

รูปที่ 2.5 การสั่งงานควบคุมการหมุนของ สเต็ปมอเตอร์ แบบ Half Step

2.1.6 วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ (Drive Circuit) [3]

Drive Circuit คือ วงจรขับมอเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่รับเอาคำสั่งจาก Motion Controller ที่เป็นสัญญาณอนาล็อกกระแสต่ำมาเพิ่มกระแสให้สูงขึ้นเพื่อขับมอเตอร์ ดังรูปที่ 2.6 โดยคุณสมบัติต่างๆ ของวงจรขับมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของมอเตอร์ที่ใช้



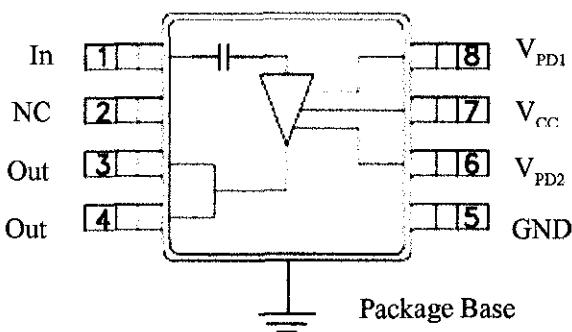
รูปที่ 2.6 วงจรขับสเต็ปมอเตอร์

2.2 วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz (Amplifier) [4, 5]

วงจรขยายสัญญาณ (Amplifier) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่แพร่ออกมานาฬิกาอากาศภาคสั่งให้มีค่าสูงมากเพียงพอที่จะใช้งานสำหรับวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่อ

ในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz จะใช้ MMIC เบอร์ HMC414MS8G ที่มีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณที่ช่วงความถี่ 2.2 GHz ถึง 2.8 GHz และมีอัตราขยายเฉลี่ย 20 dB ที่ความถี่ 2.45 GHz ซึ่งมีวงจรภายในดังรูปที่ 2.7

Functional Diagram



รูปที่ 2.7 วงจรภายใน MMIC เบอร์ HMC414MS8G

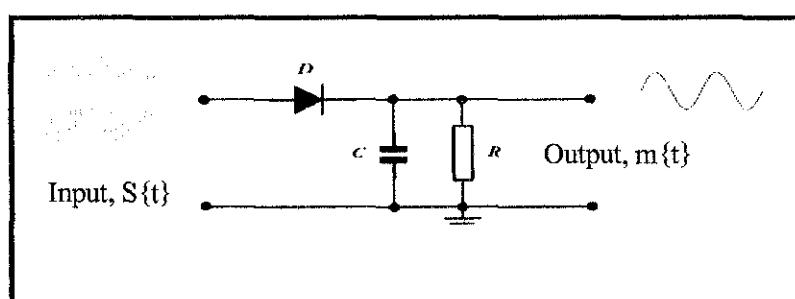
2.3 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low Pass Filter) [6, 7]

เป็นวงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าที่ยอมให้ความถี่ตั้งแต่ 0 Hz ถึงความถี่ f_c (ความถี่ Cutoff คือความถี่ที่ฟิลเตอร์ยอมให้กำลังของสัญญาณผ่านได้ครึ่งหนึ่งของกำลังที่ยอมให้ผ่านได้สูงสุด (Passband Power)) ซึ่งยอมรับกันว่าสัญญาณยังคง "ผ่านได้" ซึ่งถ้าเลยจากจุดนี้ไปก็ว่าผ่านไม่ได้ (แล้ว) ผ่านไปยังข้างเอวที่พุ่งของวงจรได้ ส่วนความถี่ที่สูงกว่า f_c ความถี่จะไม่ผ่านไปยังข้างเอวที่พุ่งของวงจร

2.3.1 วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าแบบพาสซีฟ (Passive Filter)

วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าแบบพาสซีฟจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทางพาสซีฟ (Passive Device) เป็นหลักได้แก่ ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวน้ำ (บางครั้งอาจจะมีตัวต้านทานประกอบร่วมอยู่ด้วย) ข้อดีของวงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าแบบพาสซีฟคือ สามารถตอบสนองความถี่ได้สูงมาก และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ ทั้งสิ้น ในความเป็นจริงแล้ว สัญญาณที่ออกมากจากเอวที่พุ่งของวงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าแบบพาสซีฟจะเกิดการสูญเสียขึ้น เนื่องจากค่าอิมพีเดนซ์ของวงจรและเมื่อพิจารณาถึงการส่งผ่านของแคนความถี่จะบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า เป็นวงจรที่มีการส่งผ่านไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ โดยเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแต่สิ่งที่จะตามมาคือการออกแบบที่ซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

ในการทำโครงการได้ใช้วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าความถี่ต่ำผ่านที่เป็นแบบวงจร Envelope Detector



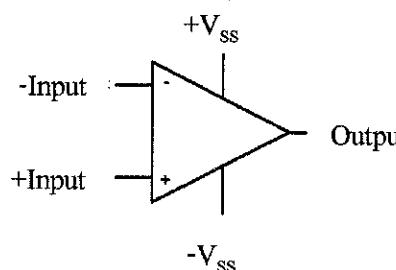
รูปที่ 2.8 แสดงวงจร Envelope Detector

2.4 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส (Rectifier)

2.4.1 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp [8, 9]

อปเปอเรนปีเป็นไอซีแบบหนึ่งของครรภุล ไอซีแบบลินิเนียร์ที่ทำหน้าที่ได้สารพัดประโยชน์ แต่โดยพื้นฐานแล้วอปเปอเรนปีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยายสัญญาณ อปเปอเรนปีจะขยายความแตกต่างระหว่างแรงเคลื่อนหรือสัญญาณ (AC หรือ DC) ที่ป้อนเข้าที่อินพุตทั้งสอง แรงเคลื่อนหรือสัญญาณที่ต้องการจะขยายสามารถป้อนเข้าทางอินพุตโดยอินพุตนั่นหรือทั้งสองอินพุตก็ได้ สัญลักษณ์และชื่อขาใช้งานพื้นฐานของอปเปอเรนปีแสดงดังรูปที่ 2.9 โดยประกอบด้วย

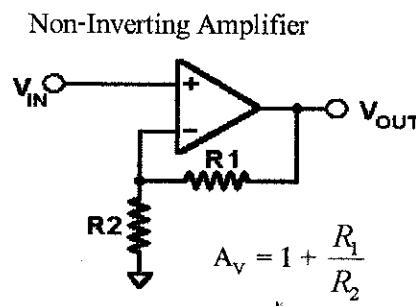
- ขั้วอินพุตบวก (Non-inverting)
- ขั้วอินพุตลบ (Inverting)
- ขั้วเอาท์พุต (Output)
- ขั้วแรงดันไฟเดี่ยง บวก และลบ ซึ่งปกติไม่ได้แสดงในสัญลักษณ์



รูปที่ 2.9 สัญลักษณ์และชื่อขาใช้งานพื้นฐานของอปเปอเรนปี

2.4.2 วงจรขยายแบบไม่กลับขั้วสัญญาณ (Non-Inverting Amplifier) [10]

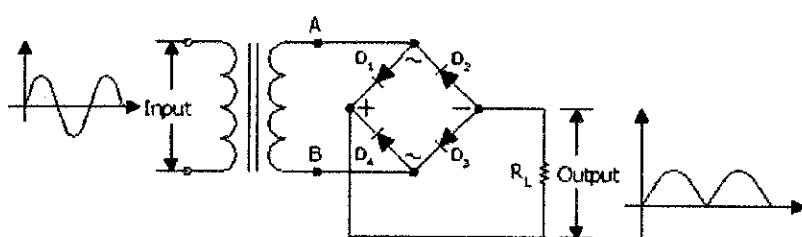
อัตราขยายของวงจร ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต่อภายนอก R_1 และ R_2 และสัญญาณเอาท์พุตไม่กลับเฟสเมื่อเทียบกับสัญญาณอินพุต แสดงรูปที่ 2.10



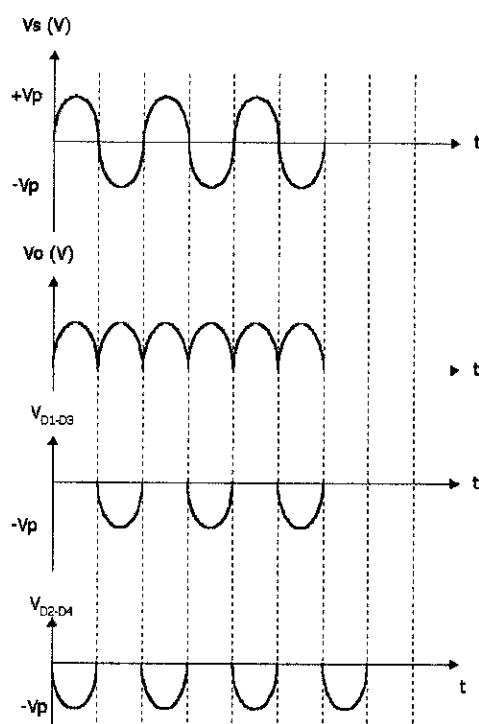
รูปที่ 2.10 Non-Inverting Op-amp

2.4.3 วงจรเรียงกระแส (Rectifier) [11, 12]

วงจรเรียงกระแสเป็นวงจรที่ทำการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า 2 ทิศทาง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง นั่นคือ ทำให้การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในทิศทางเดียว สำหรับวงจรบริจจ์เรคติไฟเออร์ (Bridge Rectifier) ดังรูปที่ 2.11 โดยการทำงานของวงจรเมื่อได้รับสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้ามาอยู่ในช่วงครึ่งคลื่นบวก การทำงานของวงจร โดยสัญญาณแรงดันไฟบวกที่ป้อนเข้ามาส่วนบนของวงจรบริจจะส่งผลทำให้ได้ออคูปู่ในสภาวะ ON จึงทำให้อิเล็กตรอนจากส่วนล่างของวงจรบริจซึ่งเป็นแรงดันไฟลบไหลผ่านโหลด



รูปที่ 2.11 วงจรบริจจ์เรคติไฟเออร์ (Bridge Rectifier)



รูปที่ 2.12 รูปคลื่นวงจรบริจจ์เรคติไฟเออร์

จากรูปที่ 2.12 เมื่อมีสัญญาณไฟซิกบวกเข้ามาที่จุด A จะทำให้ที่ D_2 และ D_4 ได้รับในแอกซตรัค กระแสไฟจะไหลผ่าน D_2 โหลด และ D_4 ครบวงจรที่จุด B ในขณะเดียวกันที่ D_1 และ D_3 จะได้รับในแอกซตรัค ทำให้ได้โอดไม่นำกระแส และเมื่อที่จุด B มีสัญญาณไฟซิกบวกเข้ามา กระแสจะไหลผ่าน D_3 โหลด R_L และ D_1 ครบวงจรที่จุด A แต่ในขณะเดียวกันที่ D_2 และ D_4 จะไม่นำกระแส วงจรบริคส์จะให้สัญญาณเอาท์พุทเหมือนกับวงจรฟูลเวฟ

2.5 สรุป

เครื่องวัดแบบบูรณาการแผ่นกระดาษคลื่นของสายอากาศที่ความถี่ 2.45 GHz โดยวงจรภาครับมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์ วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำที่เป็น Envelope Detector วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแสแบบวงจรบริคส์เรคติไฟเออร์

บทที่ 3

การออกแบบและสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz

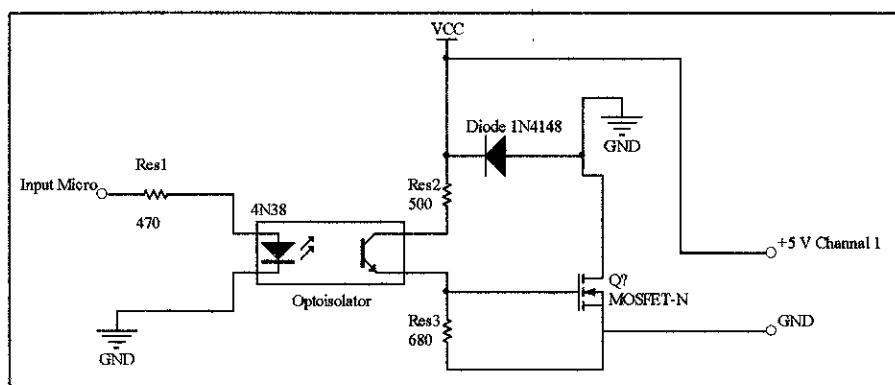
3.1 กล่าวนำ

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบและการสร้างวงจรรับคลื่นสัญญาณความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz โดยจะพิจารณาแยกที่ล่วงจะเรแล้วทำการทดสอบการใช้งาน ได้จริงของวงจรนั้นๆ ก่อนที่จะนำมาประกอบกันเป็นวงจรรับคลื่น

3.2 วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเตปมอเตอร์

วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเตปมอเตอร์ ประกอบด้วย สายอากาศ สเตปมอเตอร์ และ Microcontroller

3.2.1 วงจรขับสเตปมอเตอร์



(ก)



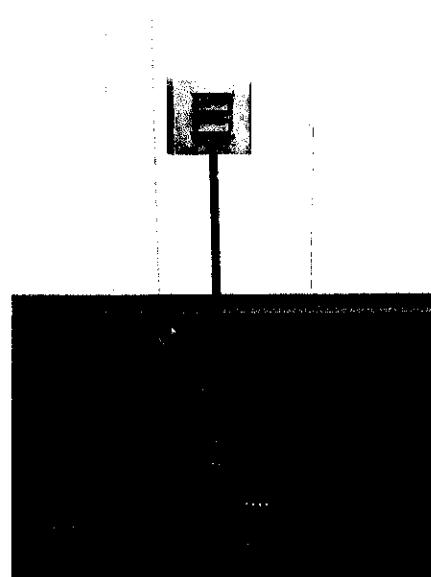
(ก)

รูปที่ 3.1 (ก) วงจรขับมอเตอร์

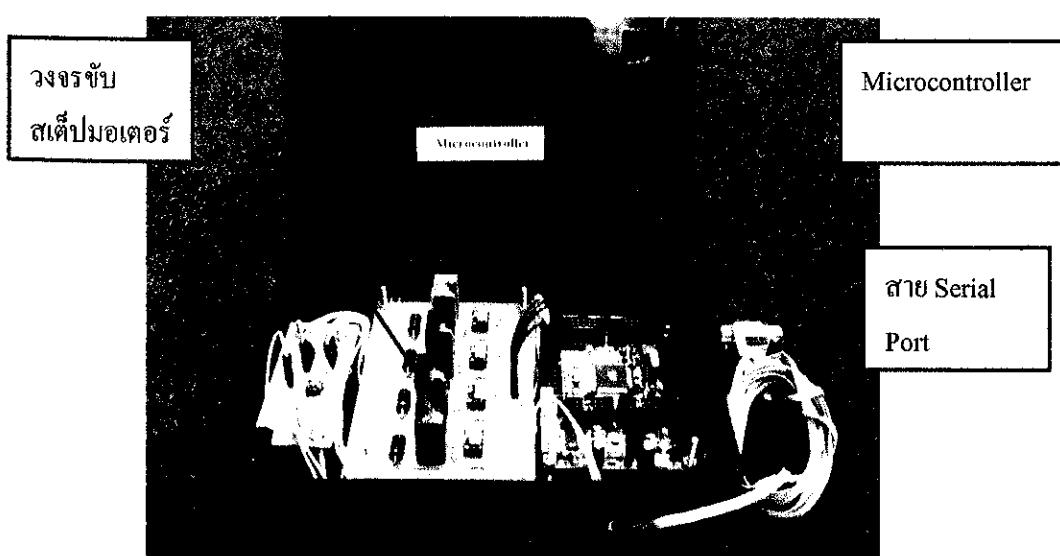
(ก) ชุดวงจรขับมอเตอร์

3.2.2 สายอากาศภาครับและสเต็ปมอเตอร์

ในส่วนของสายอากาศภาครับนี้จะใช้สายอากาศรูปตัว H ที่มีอยู่แล้วหมุนด้วยสเต็ปมอเตอร์ ($1.8^\circ/\text{Step}$) ดังรูปที่ 3.2 ซึ่งถูกควบคุมการหมุนจาก Microcontroller (AVR ATmega 128) ที่บรรจุลงในกล่องเดียวกับวงจรขับสเต็ปมอเตอร์ ดังรูปที่ 3.3 โดยใช้โปรแกรมภาษา C ในการเขียนเพื่อควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ให้หมุนที่ละครึ่งสเต็ป จะได้ครึ่งละ 0.9° และใช้โปรแกรม Visual Basic ใน การเขียนเพื่อรับค่ากำลังงานของstaname แม่เหล็กไฟฟ้าที่สายอากาศรับได้ทุกๆ 0.9° และนำมาแสดงเป็นแบบรูปการແՈกระบายคลื่นของสายอากาศ



รูปที่ 3.2 สายอากาศที่ควบคุมการหมุนด้วยสเต็ปมอเตอร์



รูปที่ 3.3 Microcontroller และชุดวงจรขับมอเตอร์

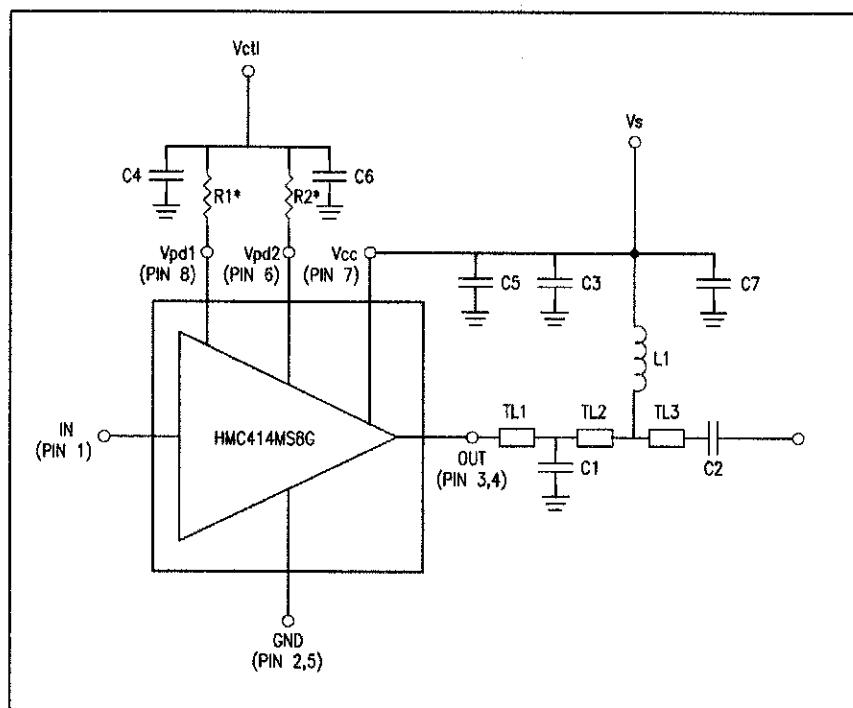
การทดสอบการหมุนของสเตปมอเตอร์ว่าหมุนที่ละครึ่งสเตปจะได้ครึ่งละ 0.9° จริงหรือไม่นั้น ทำได้โดยการเขียนโปรแกรมภาษา C ให้สเตปมอเตอร์หมุนไป 400 สเตป ถ้าสเตปมอเตอร์หมุนครบหนึ่งรอบแล้วกลับมาที่ตำแหน่งเดิม แสดงว่าสเตปมอเตอร์หมุนที่ละครึ่งสเตปจะได้ 0.9° เนื่องจาก $0.9^\circ/\text{step} \times 400 \text{ step} = 360^\circ$

3.3 วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz (Amplifier)

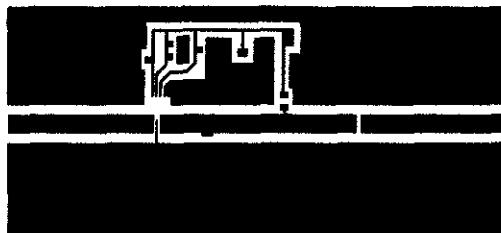
ในการออกแบบและสร้างวงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz จะใช้ MMIC เบอร์ HMC414MS8G ที่มีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณที่ช่วงความถี่ 2.2 GHz ถึง 2.8 GHz และมีอัตราขยายเพลี้ยง 20 dB ที่ความถี่ 2.45 GHz โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.3.1 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณบนแผ่น Print

โดยแปลงวงรังรูปที่ 3.4 (ก) ไปออกแบบโดยใช้โปรแกรม Altium Designer 6.6 ดังรูปที่ 3.4 (ข)



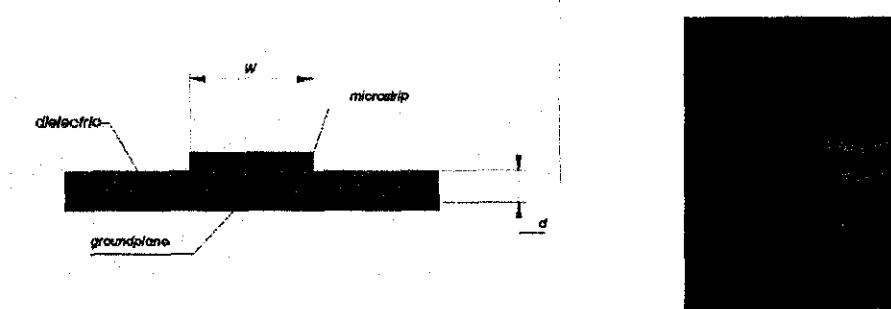
(ก)



(ก)

รูปที่ 3.4 (ก) วงจรของตัว Amplifier

(ข) ลายวงจรที่ใช้ในการกัดแผ่น Print

การออกแบบ Transmission Line บนแผ่น Print ($Z_0 = 50\Omega$) ที่ความถี่ 2.45 GHz

รูปที่ 3.5 แสดง Transmission Line บนแผ่น Print

พิจารณาจากรูปที่ 3.5

หา w จาก

$$\frac{w}{d} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2}$$

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right)$$

$$\epsilon_r = 4.5$$

แทน A ในสมการ

$$A = \frac{50}{60} \sqrt{\frac{4.5 + 1}{2}} + \frac{4.5 - 1}{4.5 + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{4.5} \right)$$

$$= (1.65)(0.83) + (0.63)(0.254)$$

$$= 1.4 + 0.16$$

$$= 1.56$$

$$\frac{w}{d} = \frac{8e^{1.56}}{e^{2 \times 1.56} - 2} = \frac{38.07}{20.64} = 1.84$$

$$d = 1.2 \text{ mm}$$

$$w = 1.84 \times 1.2 = 2.208 \text{ mm}$$

เมื่อ w คือ ความกว้างของ Transmission Line

D คือ ความหนาของ Dielectric

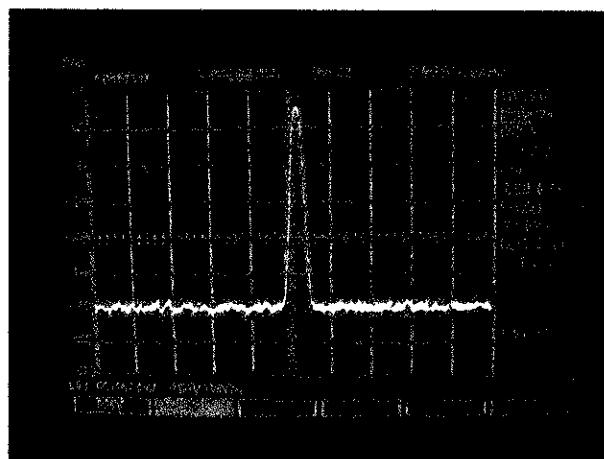
3.3.2 เมื่อได้สายวิธีที่จะต่อ Print แล้วก็ทำการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะได้วงจรดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 วงจรขยายสัญญาณที่มีความถี่ 2.45 GHz

3.3.3 ทำการทดสอบเพื่อหาอัตราขยาย

โดยใช้เครื่อง Spectrum Analysis จากการทดสอบที่ความถี่ 2.45 GHz ตั้ง Power Level 0 dBm การสูญเสียภายในสาย 2.2 dB อ่านค่าได้ 15 dB ดังแสดงในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ภาพแสดงอัตราขยายของ Amplifier โดยใช้เครื่อง Spectrum Analysis

ดังนี้ Amplifier มีอัตราขยาย 17.2 dB เมื่อเทียบกับอินพุตที่ป้อนเข้ามา โดยสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$\begin{aligned}
 G(\text{dB}) &= P_2(\text{dBm}) - P_1(\text{dBm}) - \text{Loss}(\text{dB}) \\
 &= 15 \text{ dBm} - 0 \text{ dBm} - (-2.2 \text{ dB}) \\
 &= 17.2 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

เมื่อ P_2 คือ Power ที่เอาท์พุต
 P_1 คือ Power ที่อินพุต
Loss คือ การสูญเสียภายในสาย

3.3.5 พิจารณาอัตราขยายของ Amplifier 1 ตัว

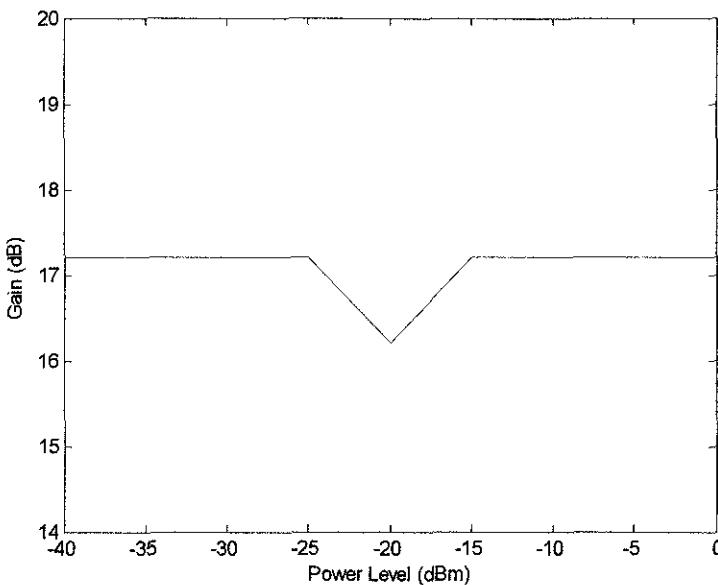
ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราขยายของ Amplifier ที่ค่า Power Level ต่างๆ

Power Level (dBm)	Transmission Line Loss (dB)	ค่าที่อ่านได้ (dB)	อัตราขยาย (dB)
-40	2.2	-25	17.2
-35	2.2	-20	17.2
-30	2.2	-15	17.2
-25	2.2	-10	17.2
-20	2.2	-6	16.2
-15	2.2	0	17.2
-10	2.2	5	17.2
-5	2.2	10	17.2
0	2.2	15	17.2

3.3.6 นำ Amplifier 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 3.2 แสดงอัตราขยายของ Amplifier 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน

Power Level (dBm)	Transmission Line Loss (dB)	ค่าที่อ่านได้ (dB)	อัตราขยาย (dB)
-40	2.2	-9	33.2
-35	2.2	-4	33.2
-32	2.2	0	34.2
-30	2.2	2	34.2
-25	2.2	7	34.2
-20	2.2	11	33.2
0	2.2	16	18.2



รูปที่ 3.8 กราฟแสดงอัตราขยายของ Amplifier ที่ค่า Power Level ต่างๆ

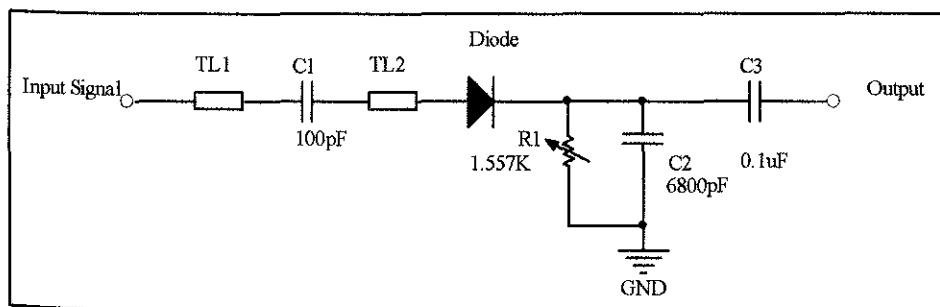
จากตารางที่ 3.1 และกราฟรูปที่ 3.8 เมื่อป้อนสัญญาณข่าวสารความถี่ 1 kHz ที่มีอัตราความถี่ 2.45 GHz แบบ AM พบว่า Amplifier มีอัตราขยายที่เป็นเชิงเส้น และเมื่อนำ Amplifier สองตัวมาต่ออนุกรมกันจะทำให้ได้อัตราขยายที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและมีอัตราขยายที่เป็นเชิงเส้นด้วยเข่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.2

3.4 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low Pass Filter)

ในการออกแบบวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำจะออกแบบโดยใช้วงจรที่เป็น Envelope Detector มีขั้นตอนการออกแบบและสร้างวงจรดังนี้

3.4.1 ออกแบบวงจร Envelope Detector บนแผ่น Print

โดยแปลงวงจรดังรูปที่ 3.9 (ก) ไปออกแบบโดยใช้โปรแกรม Altium Designer 6.6 ดังรูปที่ 3.9 (ข)



(n)



(ก)

รูปที่ 3.9 (ก) วงจร Envelope Detector

(ข) ลายวงจรที่ใช้ในการกัดแพ่น Print ของวงจร Envelope Detector

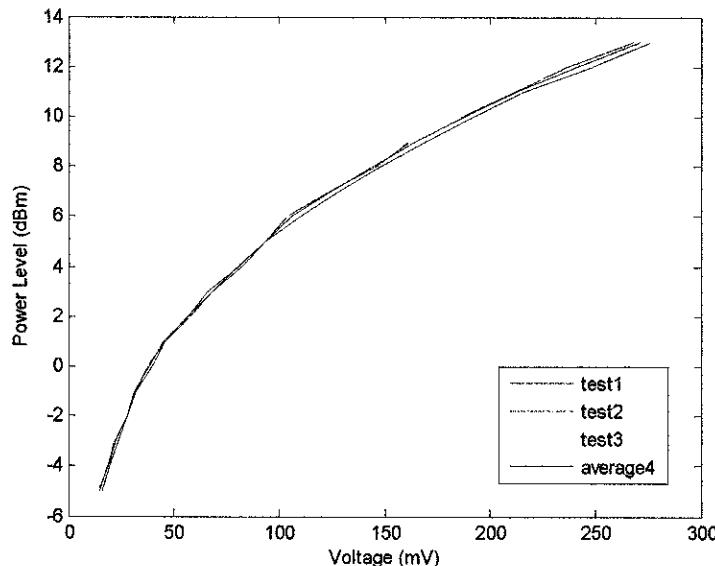
3.4.2 เมื่อได้ลายวงจรบนแพ่น Print แล้วก็ทำการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะได้วงจรดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 วงจร Envelope Detector

3.4.3 ทำการทดสอบวงจร Envelope Detector

ได้ผลค้างรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 กราฟแสดงการทดสอบวงจร Envelope Detector

ตารางที่ 3.3 แสดงค่าระดับแรงดันที่ค่า Power Level ต่างๆ

Power Level (dBm)	วัดครั้งที่ 1 (mV)	วัดครั้งที่ 2 (mV)	วัดครั้งที่ 3 (mV)	ค่าเฉลี่ย (mV)
-5	16	16	14	14.67
-4	20	20	18	19.33
-3	24	22	22	22.67
-2	28	28	28	28
-1	32	32	31	31.67
0	40	38	38	38.67
1	46	46	44	45.33
2	58	56	58	57.33
3	68	68	62	66
4	80	82	80	80.67
5	94	94	92	93.33
6	110	104	104	106
7	128	124	122	124.67
8	148	146	140	144.67
9	170	162	162	164.67
10	192	186	186	188
11	216	212	210	212.67
12	248	236	238	240.67
13	276	268	270	271.33

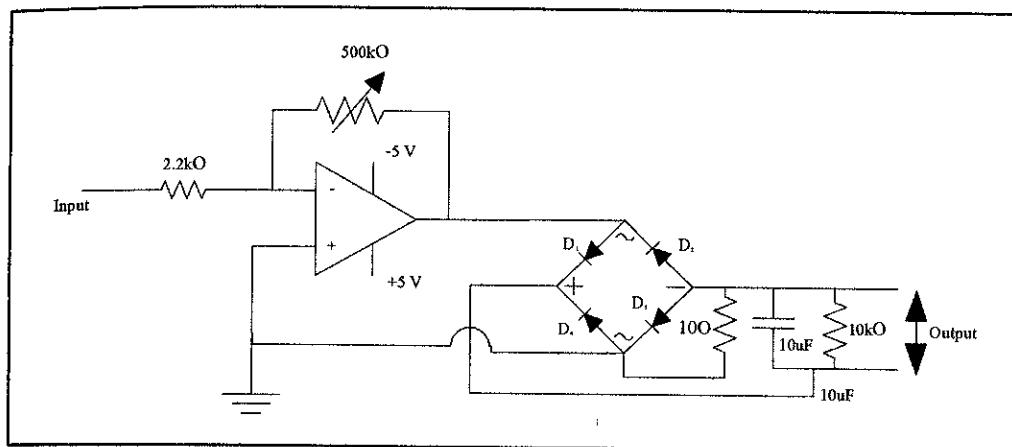
จากตารางที่ 3.3 และกราฟรูปที่ 3.11 แสดงให้เห็นว่า เมื่อ Power Level เพิ่มขึ้น ระดับแรงดันที่เอาท์พุตของวงจรก็เพิ่มขึ้นด้วย และจากการทดสอบเมื่อนีสัญญาณข่าวสารความถี่ 1 kHz มอคูลามากับสัญญาณ파ห�ความถี่ 2.45 GHz แบบ AM เช่นมา วงจรจะทำการลดสัญญาณข่าวสารที่ความถี่ 1 kHz ออกมากได้

3.5 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส (Rectifier)

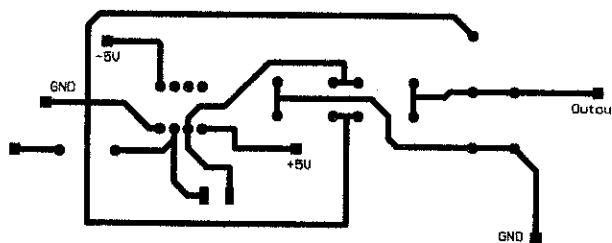
ในการออกแบบและสร้างวงจร มีวิธีดังนี้

3.5.1 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส บนแผ่น Print

โดยแปลงวงจรดังรูปที่ 3.12 (ก) ไปออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Altium Designer 6.6 ดังรูปที่ 3.12 (ข)



(ก)

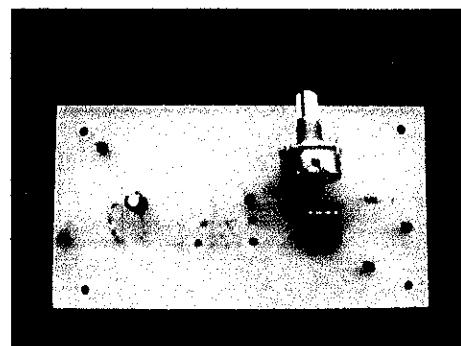


(ข)

รูปที่ 3.12 (ก) วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส

(ข) ลายวงจรที่ใช้ในการกัดแพ่น Print ของวงจร

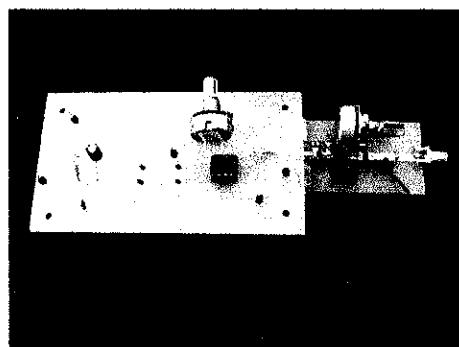
3.5.2 เมื่อได้ลายวงจรบนแผ่น Print แล้วก็ทำการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะได้รูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส

3.5.3 นำวงจร Envelope Detector วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส
นำมาต่อ กัน

จะได้รูปที่ 3.14

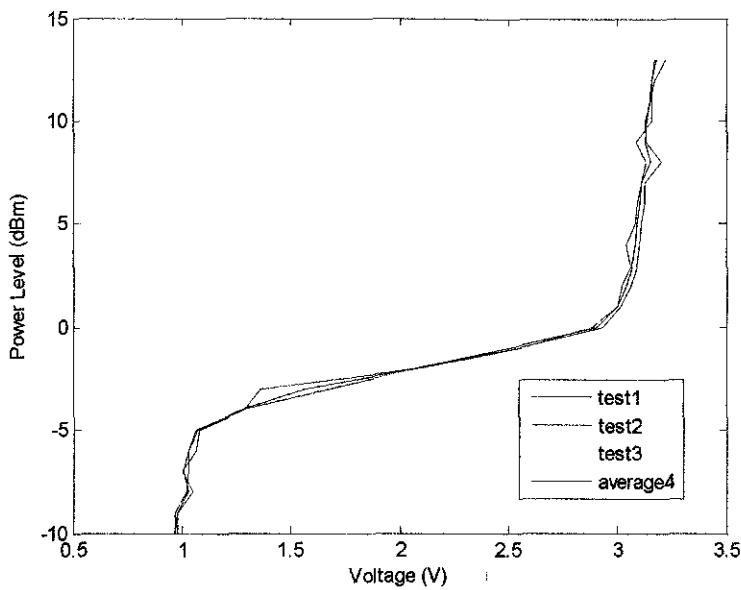


รูปที่ 3.14 วงจร Envelope Detector วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส

3.5.4 ทำการทดสอบวงจร Envelope Detector วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และ วงจรเรียงกระแส ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 3.4 แสดงค่าระดับแรงดันเอาท์พุตที่ค่า Power Level ต่างๆ

Power Level (dBm)	วัสดุครั้งที่ 1 (V)	วัสดุครั้งที่ 2 (V)	วัสดุครั้งที่ 3 (V)	ค่าเฉลี่ย (V)
-10	0.98	0.97	0.96	0.97
-9	0.98	0.97	0.98	0.98
-8	1.05	1.02	1.01	1.03
-7	1.00	1.03	1.00	1.01
-6	1.06	1.03	1.00	1.03
-5	1.08	1.07	1.03	1.06
-4	1.30	1.29	1.27	1.29
-3	1.67	1.36	1.66	1.56
-2	2.07	2.09	2.07	2.08
-1	2.57	2.58	2.45	2.53
0	2.93	2.88	2.89	2.90
1	3.01	3.00	2.98	3.00
2	3.06	3.02	3.03	3.04
3	3.09	3.06	3.06	3.07
4	3.10	3.04	3.10	3.08
5	3.11	3.08	3.07	3.09
6	3.12	3.09	3.11	3.10
7	3.12	3.11	3.12	3.11
8	3.20	3.13	3.13	3.15
9	3.13	3.08	3.14	3.12
10	3.13	3.16	3.14	3.14
11	3.15	3.16	3.15	3.15
12	3.17	3.16	3.15	3.16
13	3.22	3.17	3.16	3.18

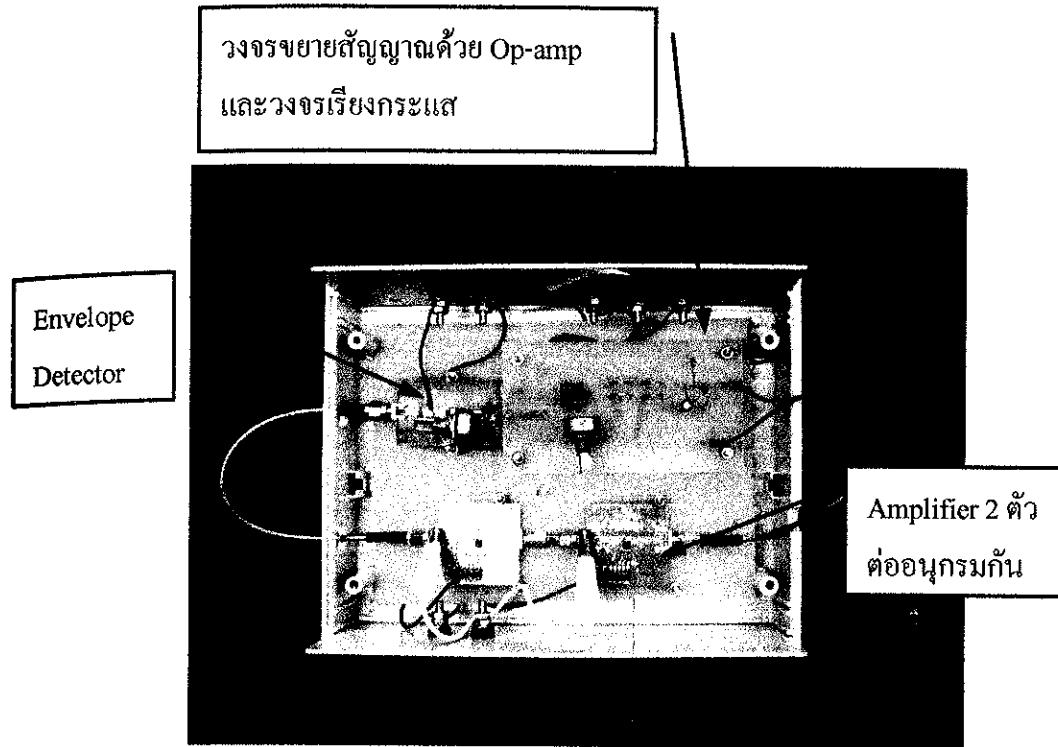


รูปที่ 3.15 กราฟแสดงการทดสอบวงจร Envelope Detector

จากตารางที่ 3.4 และกราฟรูปที่ 3.15 แสดงการทดสอบวงจร Envelope Detector วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส ที่นำมาต่อเรียงกัน เมื่อทำการป้อน สัญญาณข่าวสารความถี่ 1 kHz มอคุเลตมา กับสัญญาณพากห์ความถี่ 2.45 GHz แบบ AM เข้ามา พบร่วงดับแรงดันที่เอาท์พุตจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่ม Power Level ของเครื่องส่ง

3.6 สรุปเรื่องการออกแบบและการสร้างวงจรรับคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz

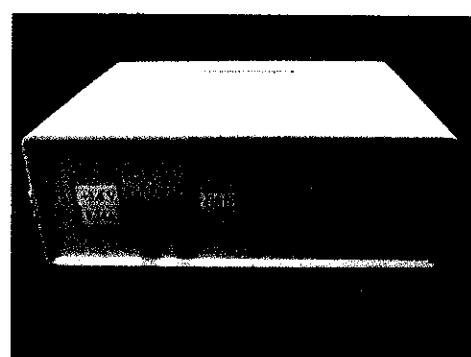
เมื่อทำการทดสอบวงจรย่อยแต่ละวงจรที่เป็นองค์ประกอบของวงจรรับคลื่นสัญญาณ ความถี่วิทยุที่ความถี่ 2.45 GHz แล้ว จากนั้นได้นำวงจรย่อยต่างๆ มาต่อกัน แล้วบรรจุลงในกล่องดัง รูปที่ 3.16 แสดงวงจรภายในกล่อง และรูปที่ 3.17 แสดงกล่องภายนอกที่ปิดฝาแล้ว เพื่อความเป็น ระเบียบและไม่ซับซ้อนในการต่อระบบรวมทั้งหมด และได้ทำการทดสอบวงจรโดยรวมอีกครั้ง พบร่วงดับแรงดันที่เอาท์พุตสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ เนื่องจากเอาท์พุตที่ได้ในแต่ละวงจรนั้น ให้ผลเป็นไปตามที่ต้องการ



รูปที่ 3.16 วงจรย่อยต่างๆ ถูกบรรจุลงในกล่องชุดอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ



ด้านหน้า



ด้านหลัง

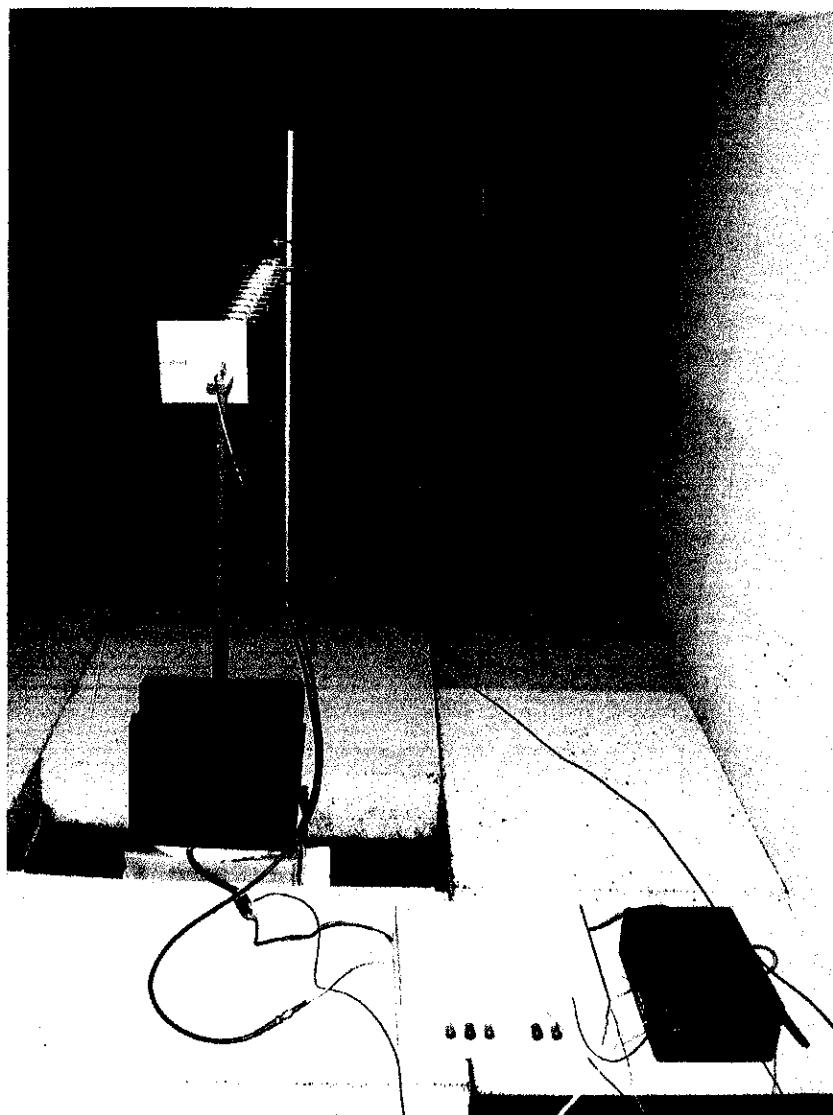
รูปที่ 3.17 กล่องชุดอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ

บทที่ 4

การทดสอบเครื่องวัดแบบรูปการแพ้กระจายคลื่นของสายอากาศ

4.1 กล่าวนำ

เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการนำงงานทั้งหมดที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น มาประกอบเข้าเป็น เครื่องรับสัญญาณคลื่นที่ความถี่ 2.45 GHz และเพื่อให้สามารถพิจารณาด้วย Serial Port เพื่อ ทำการวัดแบบรูปการแพ้กระจายคลื่นของสายอากาศตั้งแต่ 0° - 360° โดยมีการเชื่อมต่อวงจร และอุปกรณ์ต่างๆ ดังรูป



รูปที่ 4.1 แสดงระบบโดยรวมของระบบทั้งหมด

4.2 ขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของสนาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ภาครับ

เป็นการทดสอบที่ระบบเพื่อหาประสิทธิภาพของสนาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ภาครับสามารถรับได้มากที่สุด โดยจะทดสอบระบบรวมทั้งหมด แต่ไม่หมุนสายอากาศ แล้วทำการปรับลดระดับ Power Level ที่ภาคตั้งแต่ง มีขั้นตอนดังต่อไป

4.2.1 ต่อชุดอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ประกอบด้วยสายอากาศภาครับและภาคตั้ง Microcontroller และชุดอุปกรณ์ภาครับ

4.2.3 ป้อนสัญญาณเข้าสู่ภาคตั้งความถี่ 1 kHz มองคูเลตกับสัญญาณพากะที่ความถี่ 2.45 GHz

ให้ที่สายอากาศภาคตั้ง โดยให้ Power ของเครื่องส่งอยู่ที่ระดับสูงสุดคือที่ 13 dBm

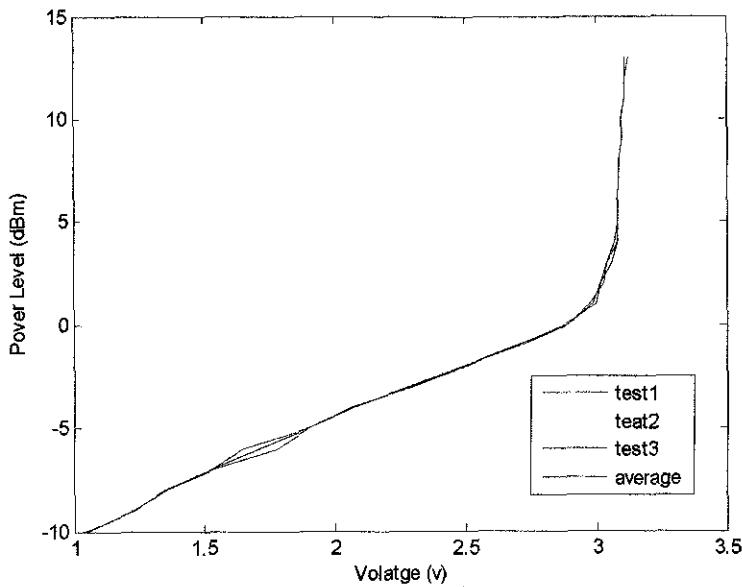
4.2.4 ทำการปรับลดระดับ Power ของเครื่องส่ง

โดยลดลงที่ละ 1 dBm ไปเรื่อยๆ จนภาครับไม่สามารถติดสัญญาณเข้าสู่ภาคตั้งออกมายได้

ได้ผลการทดสอบตามตารางที่ 4.1 และกราฟดังรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าแรงดันที่ภาครับรับได้เมื่อสายอากาศไม่หมุน

Power Level (dBm)	วัสดุครั้งที่ 1 (V)	วัสดุครั้งที่ 2 (V)	วัสดุครั้งที่ 3 (V)	ค่าเฉลี่ย (V)
-10	1.04	1.05	1.05	1.05
-9	1.23	1.21	1.22	1.22
-8	1.35	1.36	1.36	1.36
-7	1.53	1.53	1.54	1.53
-6	1.65	1.70	1.78	1.71
-5	1.90	1.89	1.90	1.90
-4	2.07	2.08	2.08	2.08
-3	2.30	2.28	2.29	2.28
-2	2.50	2.48	2.51	2.50
-1	2.72	2.70	2.71	2.71
0	2.89	2.90	2.88	2.89
1	2.98	2.99	3.00	2.99
2	3.03	3.02	3.02	3.02
3	3.04	3.05	3.06	3.04
4	3.08	3.07	3.08	3.07
5	3.08	3.08	3.08	3.08
6	3.08	3.08	3.08	3.08
7	3.09	3.09	3.09	3.09
8	3.09	3.09	3.09	3.09
9	3.10	3.10	3.10	3.10
10	3.10	3.10	3.10	3.10
11	3.11	3.10	3.11	3.11
12	3.11	3.11	3.11	3.11
13	3.11	3.11	3.12	3.11



รูปที่ 4.2 แสดงค่าแรงดันที่ภาครับรับได้เมื่อสายอากาศไม่หมุน

จากตารางที่ 4.1 และกราฟรูปที่ 4.2 เมื่อทดสอบระบบรวมทั้งหมด แต่ไม่หมุนสายอากาศ แล้วทำการปรับระดับ Power ที่ภาคส่งแทน จะเห็นได้ว่าที่ระดับ Power สูงสุด คือ 13 dBm ที่ภาครับจะมีกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามากที่สุด ดังนั้นในการทดสอบระบบรวมทั้งหมดเมื่อหมุนสายอากาศจะทำการปรับระดับ Power ของเครื่องส่งให้อยู่ที่ 13 dBm

4.3 วัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นการทดสอบระบบรวมทั้งหมดและให้สายอากาศในภาครับหมุน 360° เพื่อวัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งในระนาบ E และระนาบ H ที่ระยะห่างระหว่างสายอากาศภาครับและภาคส่ง 1 เมตร แล้วนำค่าที่ได้ไปประมวลผลต่อในคอมพิวเตอร์เพื่อวัดแบบรูปการແกรายชา不克ลีนของสายอากาศ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.3.1 ต่อชุดอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ประกอบด้วยสายอากาศภาครับและภาคส่ง Microcontroller และชุดอุปกรณ์ภาครับ

4.3.2 ป้อนสัญญาณเข้าวัสดุที่ความถี่ 1 kHz มอคุเลตกับสัญญาณพาหะที่ความถี่ 2.45 GHz ให้ที่สายอากาศภาคส่ง โดยใช้ Power ของเครื่องส่งอยู่ที่ระดับสูงสุดคือที่ 13 dBm

4.3.3 เปิดโปรแกรมภาษา C

เปิดโปรแกรมดังรูปที่ 4.3 เพื่อใช้ในการควบคุมการหมุนของสเตปมอเตอร์ แล้วทำการ Compile ตามรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.3 แสดงเปิดโปรแกรมภาษา C

The screenshot shows the CodeWarrior AVR IDE interface. The left pane displays the project navigation and code editor for a file named 'CodeWarriorAVR.c'. The right pane shows the compiler output for the ATmega128 ECU project. The compiler window title is 'ATmega128 ECU' and it includes tabs for 'Standard Input/Output Functions' and 'ADC Used Internal Reference'. The output pane displays the following compiler messages:

```
ATmega128 ECU
Standard Input/Output Functions
ADC Used Internal Reference

Read ADC Results

// ADC Result

1 i Information
2 Compiler
3
4
5
6
7
8 unsigned int
9 void __io_step();
10 void delay_ms();
11
12 void send_ir();
13 char wait_ir();
14
15 unsigned int
16
17 DBRA = 0x7F;
18
19 UCSR0B=0x00;
20 UCSR0B=0x01;
21 UCSR0H=0x00;
22 UBRR0H=0x00;
23 UBRR0L=0x00;
24
25 ADEN=1;ADC_W;
26 ADCSRA=0x07;
27 SPI0CSR=0x00;
28
29 PORTA = 0x00;
30 delay();
31
32 while (1);

279 line(s) compiled
No errors
No warnings

Bit variables size 0 byte(s)
Data Stack size 1024 to 457h
Data Stack size 1024 bytes
Estimated Data Stack usage 32 byte(s)

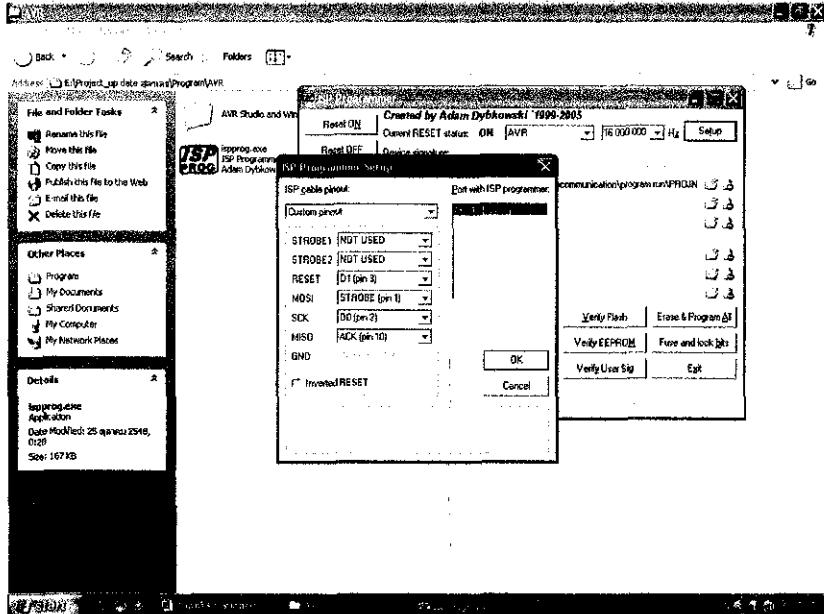
Global variables size 0 byte(s)
Hardware Stack size 500h to 10Fh
Hardware Stack size 3002 byte(s)
Heap size 0 byte(s)

EEPROM usage 0 byte(s) [0.0% of EEPROM]
```

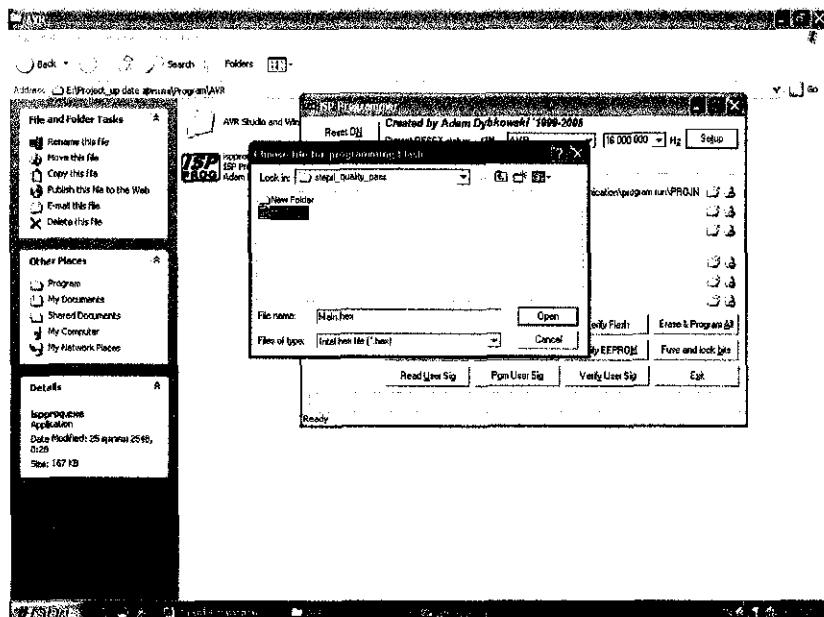
รูปที่ 4.4 ทำการ Compile

4.3.4 ทำการโหลดโปรแกรมภาษา C ลงในบอร์ด Microcontroller

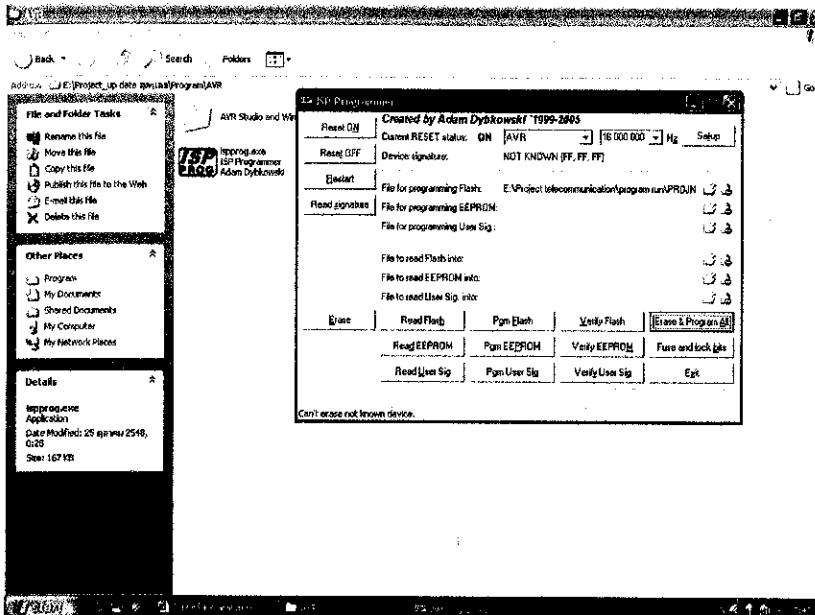
โดยใช้ **JSP PROG** และต้อง Setup ค่าต่างๆ ก่อนดังรูปที่ 4.5 และ รูปที่ 4.6 แล้วจึง
โหลดโปรแกรม ดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.5 Setup ค่าต่างๆ



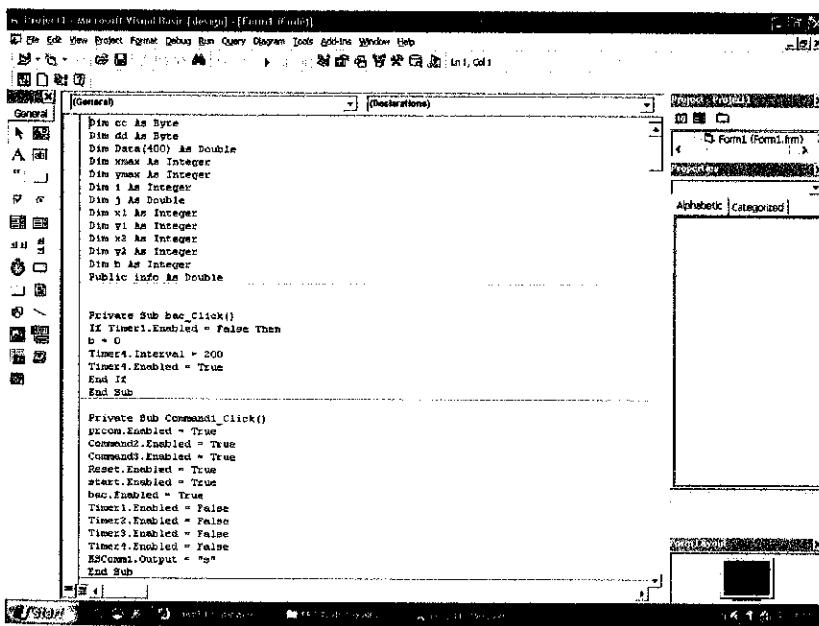
รูปที่ 4.6 เปิดไฟล์ที่ได้จากการ Compile



รูปที่ 4.7 ทำการโหลดโปรแกรมภาษา C

4.3.5 เปิดโปรแกรม Visual Basic 6

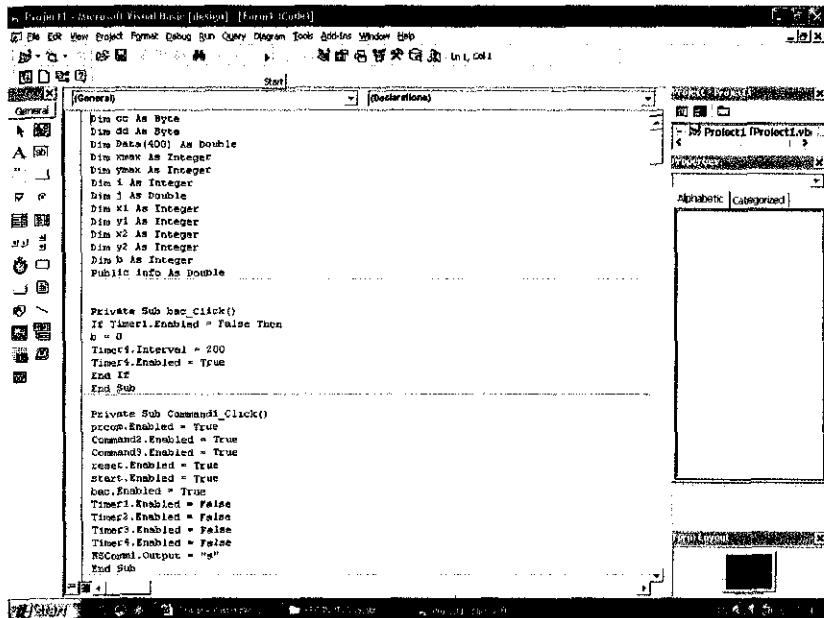
โดยคลิกที่ จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 4.8 เพื่อใช้ในการเขียนต่อ กับ Microcontroller เพื่อทำการรับค่ากำลังงานของสถานะแม่เหล็กไฟฟ้า



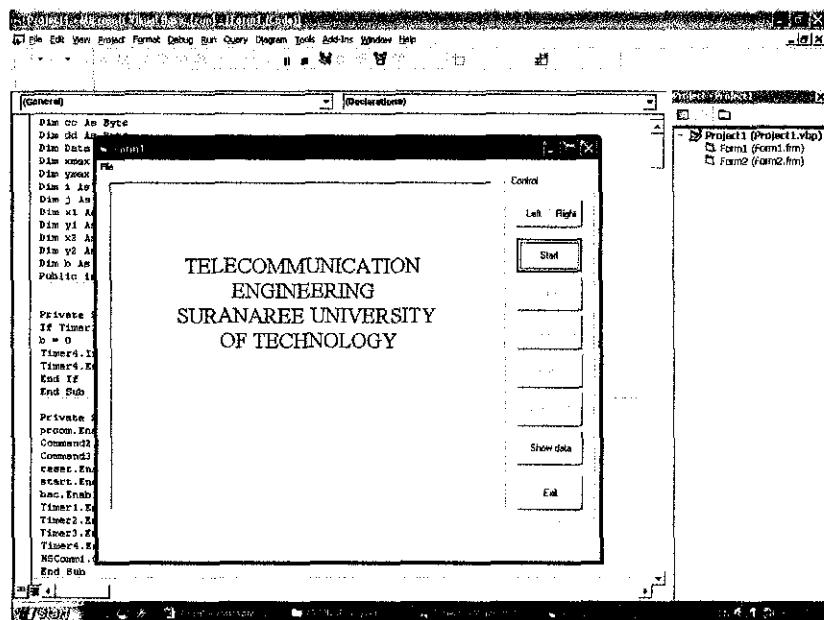
รูปที่ 4.8 เปิดโปรแกรม Visual Basic 6

4.3.6 ทำการรันโปรแกรม

รันโปรแกรมดังรูปที่ 4.9 แล้วจะได้หน้าต่างดังรูปที่ 4.10



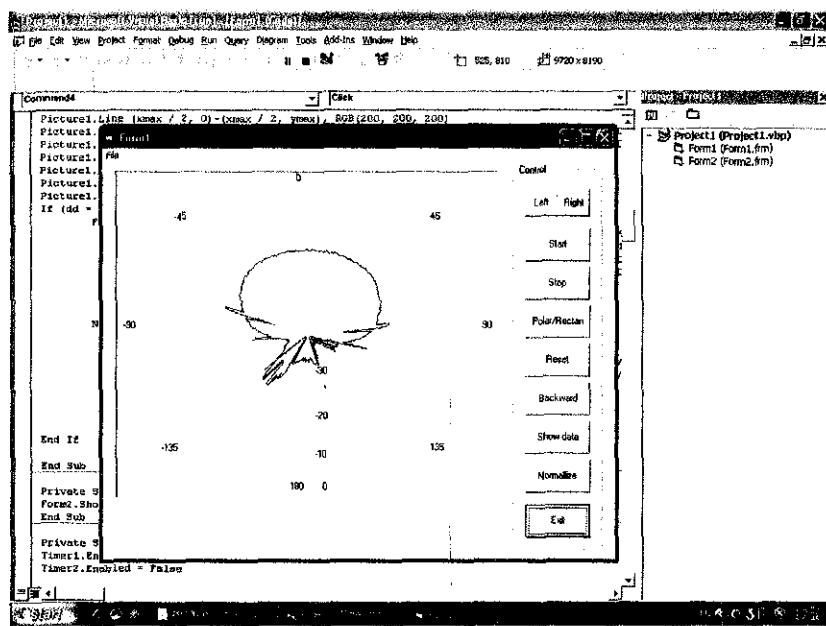
รูปที่ 4.9 รันโปรแกรม



รูปที่ 4.10 หน้าต่างโปรแกรมหลังจากที่รันโปรแกรม

4.3.7 ทำการวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ

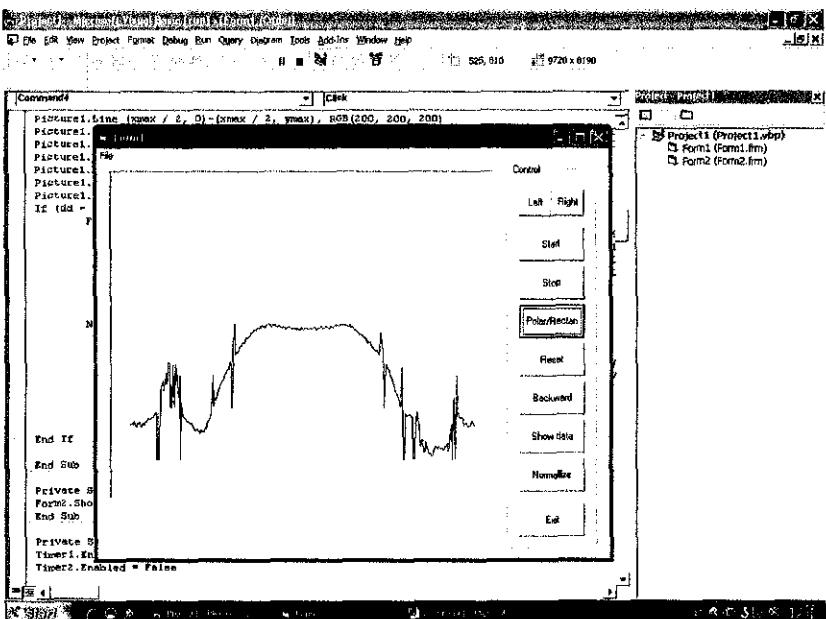
โดยกด Start จากนั้นโปรแกรมจะทำการวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ สายอากาศ ดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ Polar Plot

4.3.8 คุกราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นแบบ Rectangular

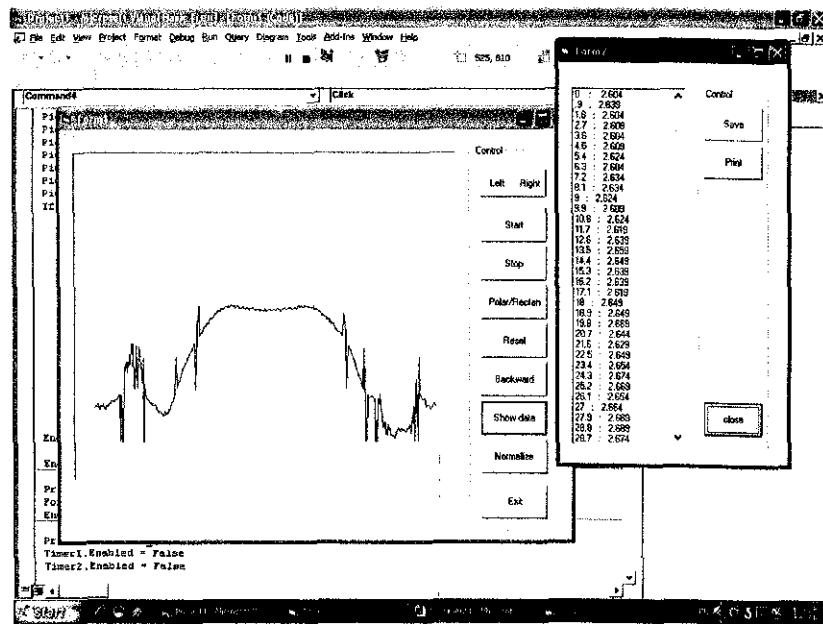
โดยการกดที่ Polar/Rectan หนึ่งครั้ง จะได้หน้าต่างโปรแกรม ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ Rectangular

4.3.9 คุกราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นแบบ Table

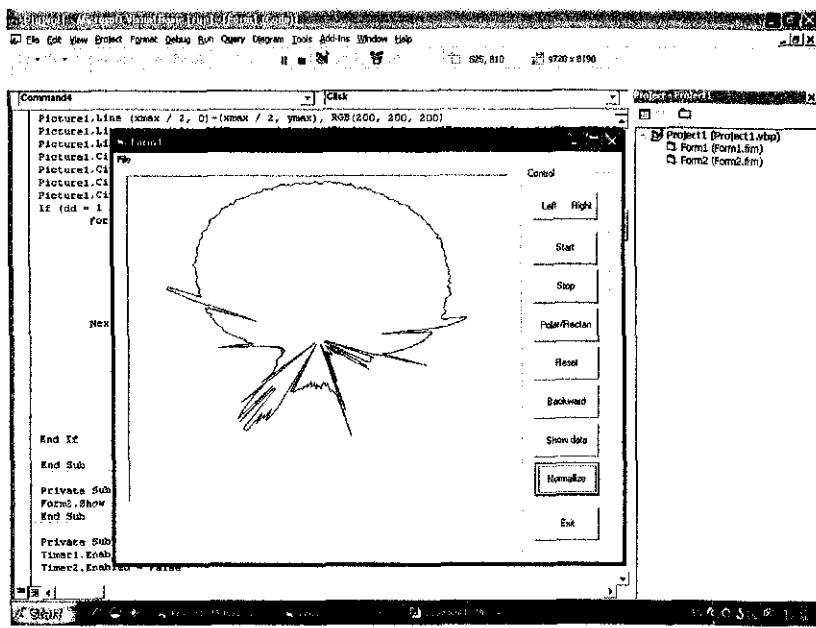
ได้โดยการกดที่ Show data แล้วจะขึ้นหน้าต่างที่แสดงค่าเป็นตาราง ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นจะเป็นแบบ Table

4.3.10 คุกราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นแบบ Polar Plot ที่ทำการ Normalize

โปรแกรมสามารถที่จะแสดงค่าที่เป็น Normalize ได้โดยการกดที่ Normalize จะได้กราฟแสดงดังรูปที่ 4.14

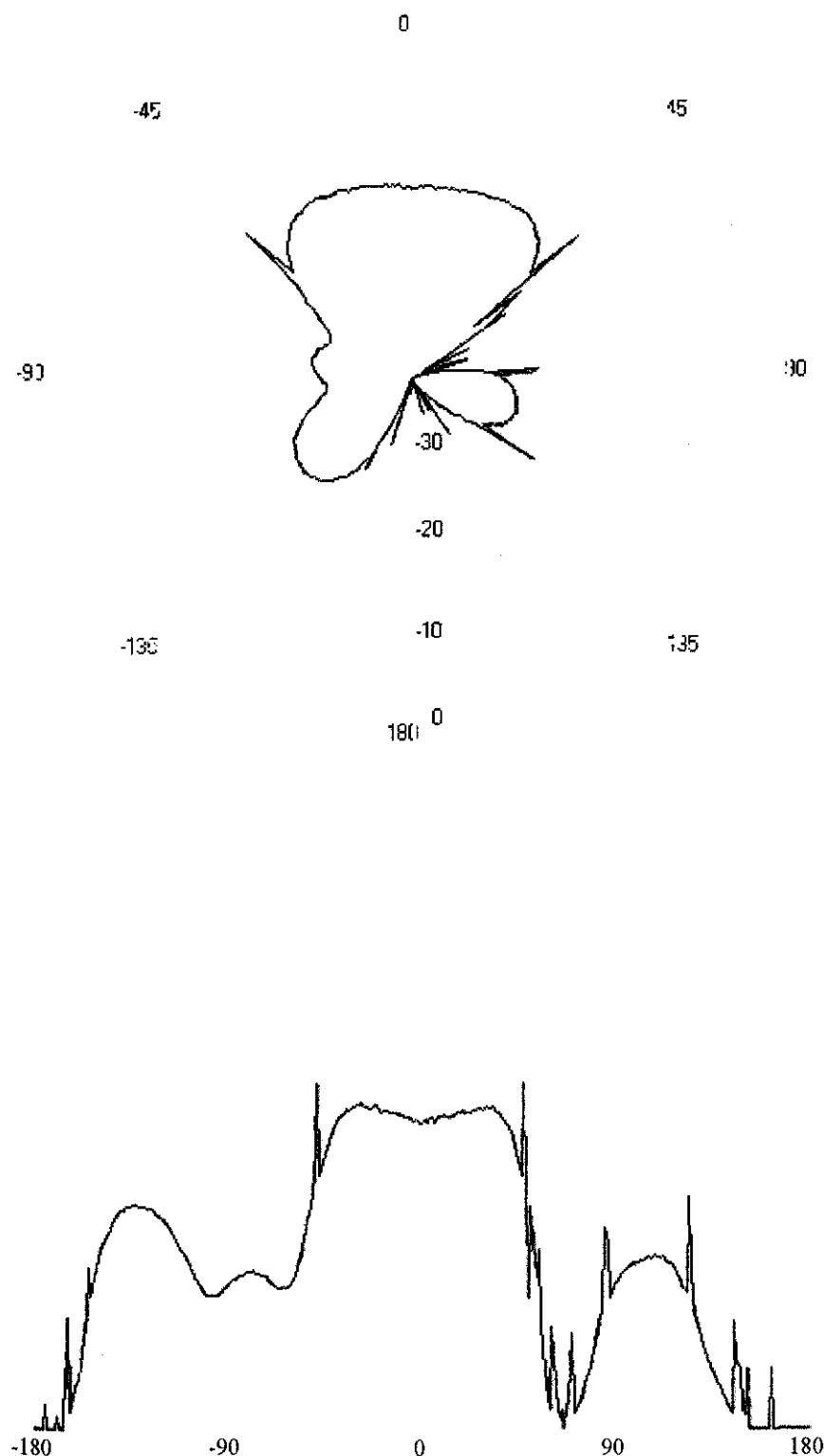


รูปที่ 4.14 กราฟแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นแบบ Polar Plot ที่ทำการ Normalize

4.3.11 วัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะ E

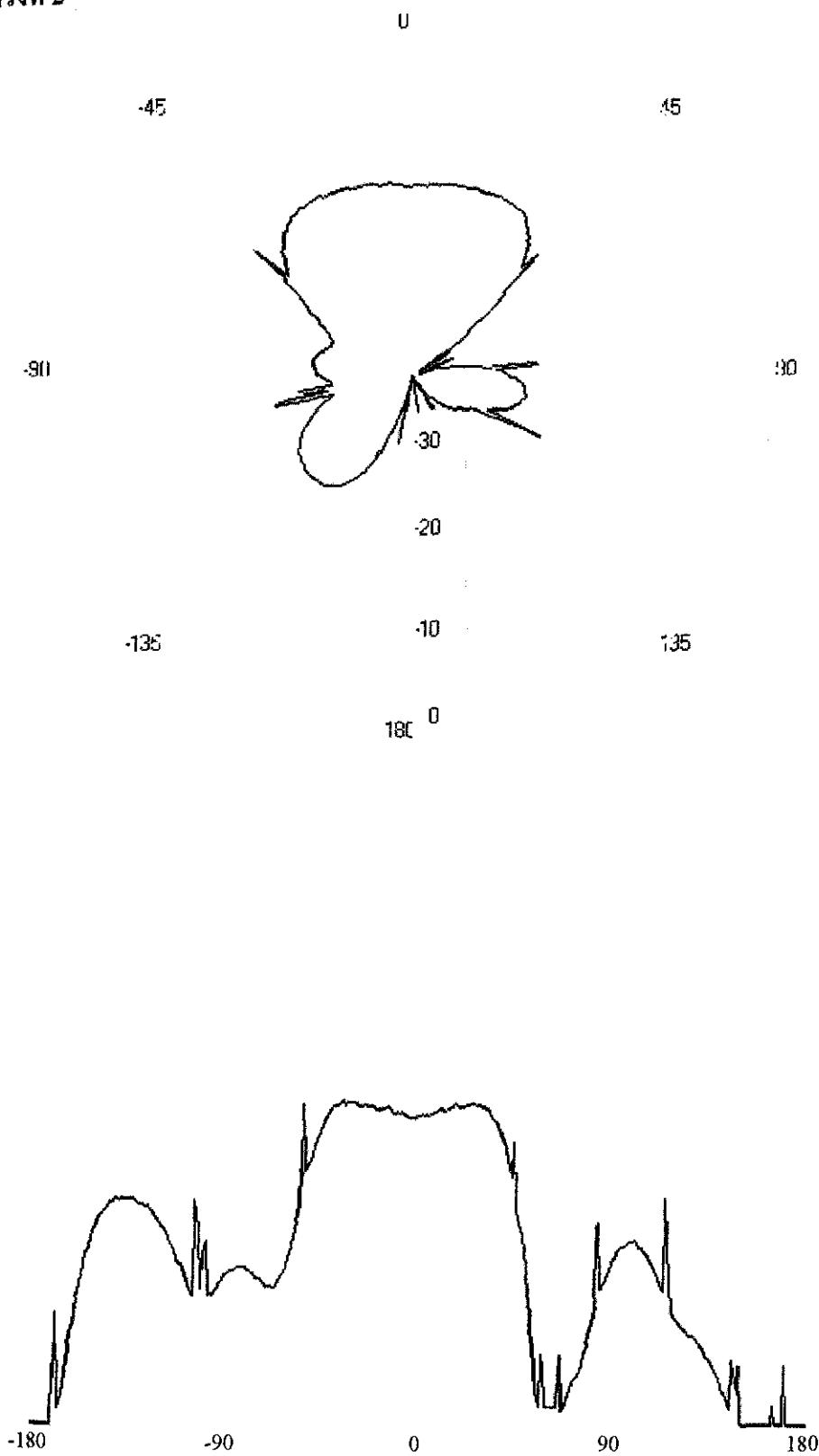
ที่ระยะห่างระหว่างสายอากาศรับและภาคสั้น 1 เมตร “ได้ผลดังนี้”

ครั้งที่ 1



รูปที่ 4.15 แสดงแบบรูปการแพรกระจายคลื่นในระยะ E ครั้งที่ 1

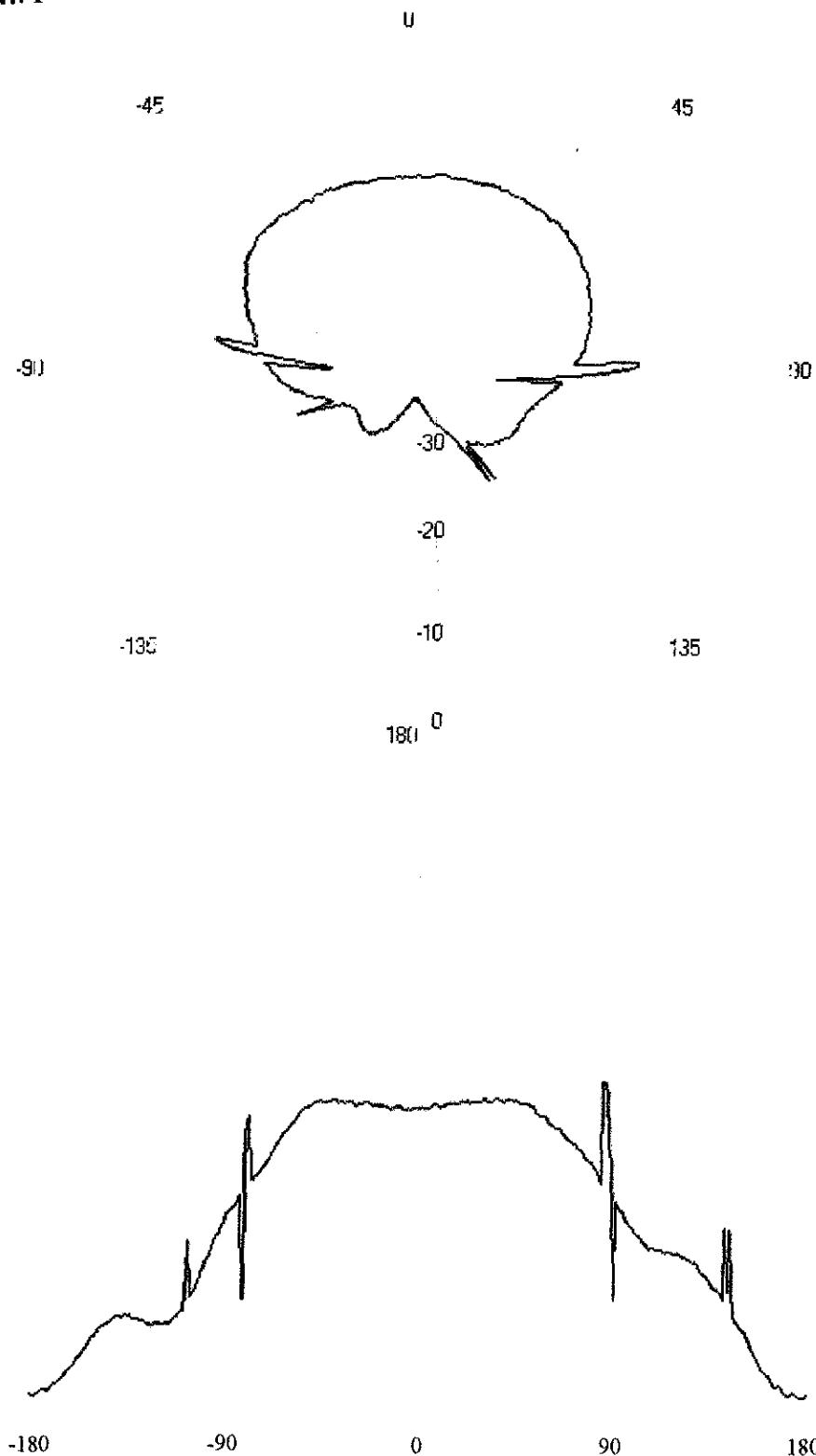
ครั้งที่ 2



รูปที่ 4.16 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นในระบบ E ครั้งที่ 2

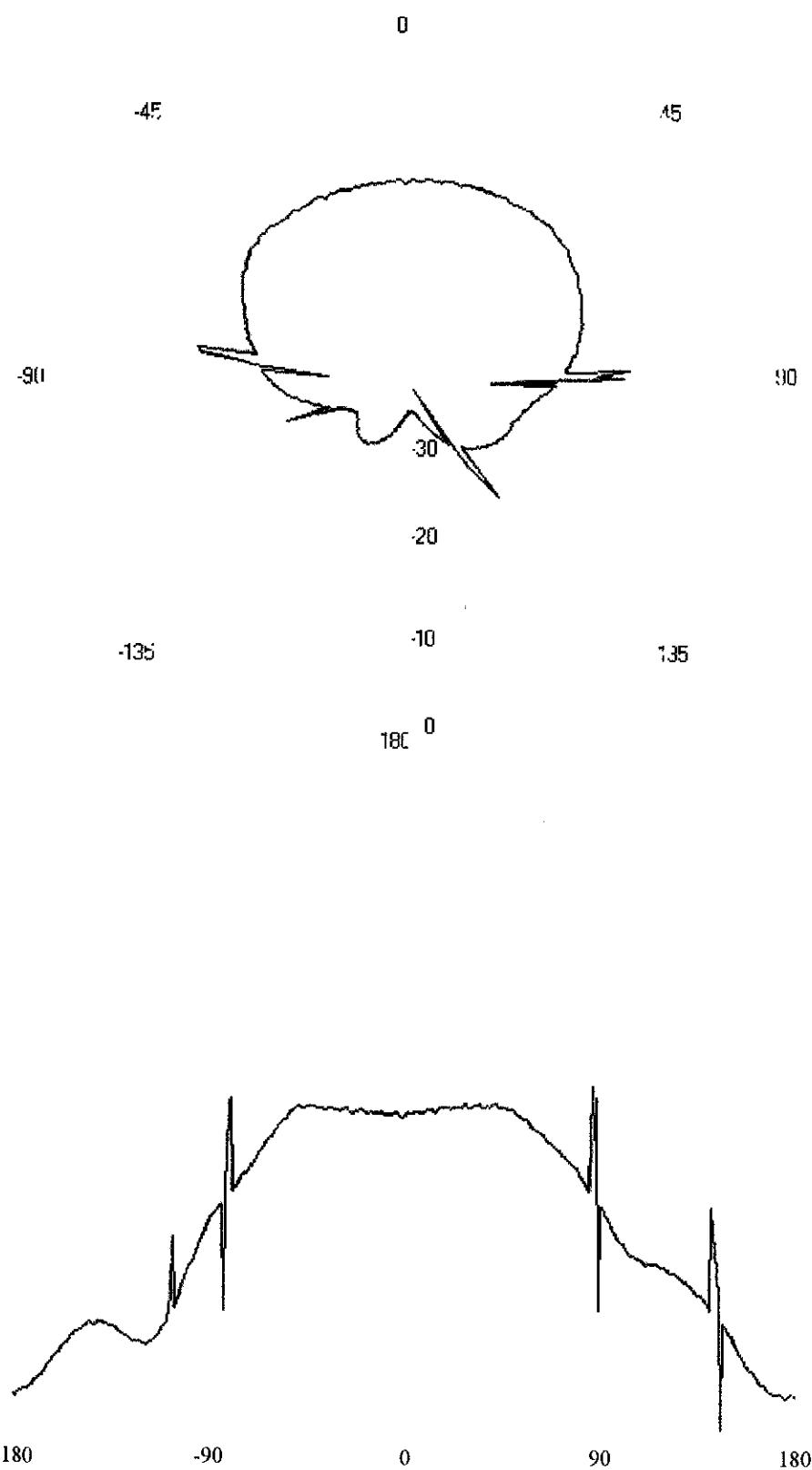
4.3.12 วัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระนาบ H

ที่ระยะห่างระหว่างสายอากาศภาครับและภาคสั่ง 1 เมตร ได้ผลดังนี้
ครั้งที่ 1



รูปที่ 4.17 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นในระนาบ H ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2



รูปที่ 4.18 แสดงแบบรูปการแผ่กระชาຍคลื่นในระนาบ H ครั้งที่ 2

4.4 สรุปการทดสอบเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ

เครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศที่ออกแบบและสร้างขึ้มนี้ สามารถรักษาแบบรูปการแผ่กระจายคลื่น แล้วแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ได้ 4 แบบ คือ Polar Plot, Rectangular Plot, Table และ Polar Plot ที่ Normalize แล้ว จากการทดสอบได้ทำการวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศช้าๆ รอบ ในระนาบ E และระนาบ H พนว่าแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นที่ได้ในแต่ละครั้งมีแบบรูปที่คล้ายคลึงกันทั้งในสองระนาบ แสดงว่าเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศนี้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ สามารถนำมาใช้งานในการวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศได้

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

5.1 กล่าวว่า

ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบรวมของเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศที่ความถี่ 2.45 GHz โดยได้อธิบายถึงปัญหาที่พบในระหว่างการทำโครงการ วิธีแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป และบทสรุปของโครงการที่จัดทำขึ้น

5.2 ปัญหาที่พบในระหว่างการทำโครงการและวิธีแก้ปัญหา

ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของปัญหาที่พบ และวิธีแก้ปัญหาของโครงการ

ปัญหาที่พบ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
1. MMIC เมอร์ HMC414MS8G ที่เป็น Amplifier พังป่าย	<u>สาเหตุ</u> เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการบัดกรี <u>แนวทางแก้ไข</u> ใช้ที่เป้าลมร้อนในการบัดกรีแทน การใช้หัวแร้ง
2. ลายวงจรที่กัดบนแผ่น Print มีขนาดเล็กมาก	<u>สาเหตุ</u> เนื่องจากความถี่ที่ใช้งานอยู่ในย่าน 2.45 GHz ดังนั้น Transmission Line จึงมีขนาดเล็ก <u>แนวทางแก้ไข</u> ในการออกแบบลายวงจรบนแผ่น Print จะใช้โปรแกรม Altium Designer ที่สามารถทำให้ Transmission Line ที่ได้มีขนาดเล็กและคงตามที่ต้องการ
3. สัญญาณที่รับได้ที่ภาครับมี Power ก่อนข้างต่ำ	<u>สาเหตุ</u> เมื่อongจากเกิดการสูญเสียภายในวงจร สายส่ง และอากาศ <u>แนวทางแก้ไข</u> ใช้ Amplifier 2 ตัว มาต่ออนุกรมกัน เพื่อให้ได้อัตราขยายเพิ่มขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ลายวงจรบนแผ่น Print ที่ออกแบบเสร็จแล้วควรที่จะใช้เครื่อง Network วัดเพื่อจะถูกว่าอินพุตและเอาท์พุต Matching ที่ 50Ω หรือไม่

5.3.2 เนื่องจาก MMIC และ IC มีขนาดเล็ก ควรที่จะระมัดระวังในการบัดกรี เพราะเวลาบัดกรีของ MMIC หรือ IC อาจติดกันทำให้เกิดการ Short Circuit ได้ และควรระวังเรื่องความร้อนในการบัดกรีด้วย เช่น ไม่ควรจิ่งๆ IC เป็นเวลานานๆ อาจทำให้ IC พังได้

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อไป

5.4.1 เพิ่มชุดวงจรขยายสัญญาณที่ภาคส่งและภาครับให้มากขึ้น เพื่อทำให้สัญญาณมีความแรงมากขึ้น สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ระยะทางที่ไกลขึ้น

5.4.2 ปรับปรุงสเต็ปมอเตอร์ให้หมุนอย่างราบรื่น ซึ่งจะทำให้ผลในการวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศมีความเที่ยงตรงและแม่นยำยิ่งขึ้น

5.4.3 ปรับปรุง และ พัฒนาเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้ในทุกๆ ย่านความถี่

5.5 บทสรุป

ระบบรวมของเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นของสายอากาศที่ความถี่ 2.45 GHz ประกอบไปด้วย

- วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์
- วงจรขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz (Amplifier)
- วงกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low Pass Filter)
- วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส (Rectifier)

ก่อนที่จะทำการต่อชุดอุปกรณ์และวงจรต่างๆ ในระบบ จะทำการทดสอบชุดอุปกรณ์และวงจรทั้งต้น ซึ่งได้ผลตามบทที่ 3 อธิบายได้ดังต่อไปนี้

5.5.1 วงจรควบคุมการหมุนของสายอากาศด้วยสเต็ปมอเตอร์

สเต็ปมอเตอร์ที่ถูกควบคุมด้วย Microcontroller จะหมุนสายอากาศที่ลักษณะเป็นโดเบิลได้மุน 0.9° ในแต่ละครั้งสเต็ป ดังนั้นสเต็ปมอเตอร์จะหมุน 400 สเต็ป ทำให้ได้มุมทั้งหมด 360°

5.5.2 วงศ์ขยายสัญญาณที่ย่านความถี่ 2.45 GHz

วงจรขยายสัญญาณจะใช้ MMIC เบอร์ HMC414MS8G ที่มีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณที่ช่วงความถี่ 2.2 GHz ถึง 2.8 GHz และมีอัตราขยายเฉลี่ย 20 dB ที่ความถี่ 2.45 GHz จากการทดสอบด้วยเครื่อง Spectrum Analyzer วัดอัตราขยายได้ 17.2 dB ที่ Power 0 dB เมื่อทำการปรับเพิ่มค่าของ Power พบว่าวงจรขยายสัญญาณมีอัตราขยายที่เป็นเสียงเด่น และเมื่อนำวงจรขยายสัญญาณมาต่อ กับ แบบ อนุกรม กับ ส่อง วงจร จะได้อัตราขยายที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และมีอัตราขยายที่ เป็นเสียงเด่น ด้วย เช่น กัน

5.5.3 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ

วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำโดยออกแบบให้เป็นวงจร Envelope Detector ภายในวงจรจะใช้ Diode เปอร์ HSMS 2862 ที่สามารถทำงานได้ที่ย่านความถี่ 2.45 GHz หากการทดสอบเมื่อมีสัญญาณเข้ามาความถี่ 1 kHz มอคุเลตมากับสัญญาณพาหะความถี่

5.5.4 วงจรขยายสัญญาณด้วย Op-amp และวงจรเรียงกระแส

ภายในวงจรจะใช้ Op-amp เบอร์ LM358 ที่เป็นแบบ Non-inverting Amplifier และ Diode เบอร์ 1N4148 จำนวน 4 ตัวต่อกันแบบบริค์ มีอิมพัลส์ภายนอกเข้ามาที่ความถี่ 1 kHz เช้ามาวงจรจะทำหน้าที่ขยายสัญญาณแล้วแปลงเป็นสัญญาณ DC เพื่อส่งให้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ประมวลผลต่อไป

จากการทดสอบเมื่อทำการต่อชุดอุปกรณ์และวงจรต่างๆ ในระบบรวมทั้งหมด แล้วทำการวัดแบบรูปการแผ่กระเจยคลื่นของสายอากาศที่ความถี่ 2.45 GHz โดยกำหนดให้ระยะห่างระหว่างสายอากาศภายนอกและภาคส่วนที่ต่ออยู่กัน 1 เมตร แล้วทำการวัดค่ากำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ภาครับสามารถรับได้ทั้งในระยะ E และระยะ H เมื่อทำการวัดค่าขั้วทางเดียว รอบ พบร่วมแบบรูปการแผ่กระเจยคลื่นที่วัดได้ในแต่ละครั้งมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งในสองระยะ แสดงว่าเครื่องวัดแบบรูปการแผ่กระเจยคลื่นของสายอากาศชนิดนี้ประศิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงแม่นยำที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง

บรรณานุกรม

- [1] <http://www.chontech.ac.th/~electric/html/stepermoter.htm>
- [2] http://www.sangtawan.org/news_detail.asp?lng=th&news_id=7
- [3] http://eestaff.kku.ac.th/~krit/book_project4/Project%20B4/2546/high%20voltage%20motor%20drive/high%20voltage%20motor%20drive_pdf+ppt.pdf
- [4] http://www.hittite.com/index.cfm?body_content=products&type=amplifier&catid=1&part_number=HMC414MS8G&source=dropdown&sort=function
- [5] กัมปนาท ล้านอก และ สุรเดช สุวรรณ โนรา. “วงจรขยายสัญญาณสำหรับเครื่อข่ายไร้สายย่านความถี่ 2.45 GHz โดยใช้วงจรขยายแบบ MMIC.” วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา, 2548
- [6] http://www.eng.mut.ac.th/electronics/article_detail.asp?ArticleID=291
- [7] http://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/RadCom/part9/page2.html
- [8] <http://www.en.kku.ac.th/engineer/project/files/ee%202004-20-286-1-12%20%BA%B7% B7%D5%E8%203%20%C7%A7%A8%C3%A2%C2%D2%C2%CA%D1%AD%AD%D2% B3.pdf>
- [9] <http://mylesson.swu.ac.th/ee210/Lesson05.htm>
- [10] <http://www.sukhothaitc.ac.th/kraisorn/teaching/OP-A.htm>
- [11] <http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit15/unit15.htm>
- [12] <http://www.chontech.ac.th/~electric/html/rectifier.htm>

ภาคผนวก ก

โปรแกรม CodeVisionAVR C Compiler Evaluationที่ใช้ในการ ควบคุมการหมุนของสเตปมอเตอร์

```

#include <mega128.h>                                // ATmega128 MCU
#include <stdio.h>                                    // Standard Input/Output functions
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0                           // ADC Used Internal Reference

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input); // Read ADC Result
void FW_Step(int step);
void delay (void);

void main(void)
{
    char uart_data;
    unsigned int j=1,val,val1,val2;                  // ADC Result

    DDRA = 0x7F;

    UCSR0A=0x00;
    UCSR0B=0x18;
    UCSR0C=0x86;
    UBRR0H=0x00;
    UBRR0L=0x67;

    ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA=0x87;
    SFIOR&=0xEF;
}

```

```

PORTA = 0x00;
delay();

while (1)
{
    uart_data = getchar();
    if(uart_data=='s')
    {
        printf("\rStop");
        PORTA = 0x00;
    }
    if(uart_data=='d')
    {
        val = read_adc(0);
        val1=(val*5)/1023;
        val2=(val*5)%1023;
        printf("\r%u.%u",val1,val2);
    }
    Else
    {
        if(uart_data=='l')
        {
            if(j<8){j++;}

            else if(j==8){j=1;}

            FW_Step(j);

        }

        if(uart_data=='r')
        {
            if(j>1){j--;}

            else if(j==1){j=8;}

            FW_Step(j);

        }
    }
}

```

```

    }

}

//*****
//***** Read the AD conversion result *****/;
//*****
//*****
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)          // Read Result ADC
{
    ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA|=0x40;                                // Start the AD conversion
    while ((ADCSRA & 0x10)==0);                  // Wait for the AD conversion to
                                                // complete
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
}

//*****
//*****FW-STEP*****/;
//*****
void FW_Step(int step)
{
    switch(step)
    {
        case 1: PORTA=0b00000001;delay();break;
        case 2: PORTA=0b00000011;delay();break;
        case 3: PORTA=0b00000010;delay();break;
        case 4: PORTA=0b00000110;delay();break;
        case 5: PORTA=0b00000100;delay();break;
        case 6: PORTA=0b00001100;delay();break;
        case 7: PORTA=0b00001000;delay();break;
        case 8: PORTA=0b00001001;delay();break;
    }
}

```


โปรแกรม Microsoft Visual Studio 6

ที่ใช้ในการวัดแบบรูปการແຜ່ກະຈາຍຄື່ນຂອງສາຍາກາຕ

```

Dim cc As Byte
Dim dd As Byte
Dim Data(400) As Double
Dim Data_n(400) As Double
Dim Data_max As Double
Dim xmax As Integer
Dim ymax As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Double
Dim x1 As Integer
Dim y1 As Integer
Dim x2 As Integer
Dim y2 As Integer
Dim b As Integer
Public info As Double
*****  

Private Sub bac_Click()
    Timer1.Enabled = False Then
        0
    Timer4.Interval = 200
    Timer4.Enabled = True
    If
    Sub
*****  

Private Sub Command1_Click()
    m.Enabled = True
    Command2.Enabled = True

```

```
    Command3.Enabled = True  
    reset.Enabled = True  
    start.Enabled = True  
    bac.Enabled = True  
    Timer1.Enabled = False  
    Timer2.Enabled = False  
    Timer3.Enabled = False  
    Timer4.Enabled = False  
    MSComm1.Output = "s"  
End Sub
```

```
*****  
Private Sub Command2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As  
Single)
```

```
If Timer1.Enabled = False Then  
    Timer2.Interval = 40  
    Timer2.Enabled = True
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
*****  
Private Sub Command3_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As  
Single)
```

```
If Timer1.Enabled = False Then  
    Timer3.Interval = 40  
    Timer3.Enabled = True
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
*****  
Private Sub Command2_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As  
Single)
```

```
If Timer1.Enabled = False Then  
    Timer2.Enabled = False  
    MSComm1.Output = "s"
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
*****  
Private Sub Command3_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As  
Single)
```

```
If Timer1.Enabled = False Then
```

```
Timer3.Enabled = False
```

```
MSComm1.Output = "s"
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
*****  
Private Sub Command4_Click()
```

```
Data_max = 0
```

```
For j = 0 To 400
```

```
If Data(j) > Data_max Then
```

```
Data_max = Data(j)
```

```
If
```

```
For j
```

```
For j = 0 To 400
```

```
If Data(j) > 0 Then
```

```
n(j) = Data(j) / Data_max * 5
```

```
If Data(j) = 0 Then
```

```
n(j) = 0
```

```
If
```

```
For j
```

```
Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
```

```
Picture1.Line (0, ymax / 2)-(xmax, ymax / 2), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 2, 0)-(xmax / 2, ymax), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 2 + 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 - 2147, ymax / 2 - 2147),
```

```
RGB(200, 200, 200)
```

```

Picture1.Line (xmax / 2 - 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 + 2147, ymax / 2 - 2147),
RGB(200, 200, 200)

Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8, RGB(200, 200, 200)

Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 2, RGB(200, 200, 200)

Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 3, RGB(200, 200, 200)

Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 4, RGB(200, 200, 200)

```

If (dd = 1 And Timer1.Enabled = False) Then

For j = 1 To 399

```
x1 = xmax / 2 + (Data_n(j - 1) * ymax / 10 * Cos(((j - 1) * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
```

```
y1 = ymax / 2 + (Data_n(j - 1) * ymax / 10 * Sin(((j - 1) * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
```

```
x2 = xmax / 2 + (Data_n(j) * ymax / 10 * Cos((j * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
```

```
y2 = ymax / 2 + (Data_n(j) * ymax / 10 * Sin((j * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
```

```
Picture1.Line (x1, ymax - y1)-(x2, ymax - y2), RGB(200, 0, 0)
```

```
Picture1.PSet (x2, ymax - y2), RGB(200, 0, 0)
```

Next j

```
x1 = xmax / 2 + (Data_n(0) * ymax / 10 * Cos((90) * 3.14159 / 180))
```

```
y1 = ymax / 2 + (Data_n(0) * ymax / 10 * Sin((90) * 3.14159 / 180))
```

```
x2 = xmax / 2 + (Data_n(399) * ymax / 10 * Cos((399 * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
```

```
y2 = ymax / 2 + (Data_n(399) * ymax / 10 * Sin((399 * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
```

```
Picture1.Line (x1, ymax - y1)-(x2, ymax - y2), RGB(200, 0, 0)
```

```
Picture1.PSet (x2, ymax - y2), RGB(200, 0, 0)
```

End If

End Sub

Private Sub Command5_Click()

Form2.Show

End Sub

Private Sub exit_Click()

```
    Timer1.Enabled = False
    Timer2.Enabled = False
    Timer3.Enabled = False
    Timer4.Enabled = False
    MSComm1.Output = "s"
    MSComm1.PortOpen = False
End Sub
*****
Private Sub Form_Load()
    i = 0
    h = 0
    max = Picture1.ScaleWidth
    max = Picture1.ScaleHeight
    Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.Settings = "9600, n , 8, 1"
    MSComm1.PortOpen = True
    Timer1.Enabled = False
End Sub
*****
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Timer1.Enabled = False
    Timer2.Enabled = False
    Timer3.Enabled = False
    Timer4.Enabled = False
    MSComm1.Output = "s"
    MSComm1.PortOpen = False
End Sub
*****
Private Sub mnuExit_Click(Index As Integer)
    Timer1.Enabled = False

```

```
Timer2.Enabled = False
Timer3.Enabled = False
Timer4.Enabled = False
MSComm1.Output = "s"
MSComm1.PortOpen = False
End
End Sub
*****
Private Sub mnuOpen_Click(Index As Integer)
    dlg1.ShowOpen
    If dlg1.FileName <> "" Then
        picture1.Picture = LoadPicture(dlg1.FileName)
        Label1.Height = 0
        Label1.Width = 0
        Label1.Visible = False
        Label1.Enabled = False
    End If
End Sub
*****
Sub polarplot()
    Label2.Visible = True
    Label3.Visible = True
    Label4.Visible = True
    Label5.Visible = True
    Label6.Visible = True
    Label7.Visible = True
    Label8.Visible = True
    Label9.Visible = True
    Label10.Visible = True
    Label11.Visible = True
    Label12.Visible = True
    Label13.Visible = True
End Sub
```

```

Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
Picture1.Line (0, ymax / 2)-(xmax, ymax / 2), RGB(200, 200, 200)
Picture1.Line (xmax / 2, 0)-(xmax / 2, ymax), RGB(200, 200, 200)
Picture1.Line (xmax / 2 + 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 - 2147, ymax / 2 - 2147),
RGB(200, 200, 200)
Picture1.Line (xmax / 2 - 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 + 2147, ymax / 2 - 2147),
RGB(200, 200, 200)

```

```

Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8, RGB(200, 200, 200)
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 2, RGB(200, 200, 200)
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 3, RGB(200, 200, 200)
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 4, RGB(200, 200, 200)

```

If (dd = 1 And Timer1.Enabled = False) Then

For j = 1 To 399

```

x1 = xmax / 2 + (Data(j - 1) * ymax / 10 * Cos((j - 1) * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
y1 = ymax / 2 + (Data(j - 1) * ymax / 10 * Sin((j - 1) * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
x2 = xmax / 2 + (Data(j) * ymax / 10 * Cos((j * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
y2 = ymax / 2 + (Data(j) * ymax / 10 * Sin((j * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
Picture1.Line (x1, ymax - y1)-(x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)
Picture1.PSet (x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)

```

Next j

```

x1 = xmax / 2 + (Data(0) * ymax / 10 * Cos((90) * 3.14159 / 180))
y1 = ymax / 2 + (Data(0) * ymax / 10 * Sin((90) * 3.14159 / 180))
x2 = xmax / 2 + (Data(399) * ymax / 10 * Cos((399 * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
y2 = ymax / 2 + (Data(399) * ymax / 10 * Sin((399 * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))

```

```

Picture1.Line (x1, ymax - y1)-(x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)
Picture1.PSet (x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)

```

End If

End Sub

```
*****
Private Sub mnuSave_Click(Index As Integer)
    Dim DialogTitle = "Save image"
    Dim Filter = "Image(*.bmp)|*.bmp|Image(*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*"
    Dim DefaultExt = ".bmp"
    Dim FileName = ""
    Dim ShowSave
    If dlg1.FileName <> "" Then
        SetPicture Picture1.Image, dlg1.FileName
    End If
End Sub
*****
Private Sub prcom_Click()
    If Timer1.Enabled = False Then
        If cc = 1 Then
            Call rectanplot
        End If
        If cc = 2 Then
            Call polarplot
        End If
    End If
End Sub
*****
Private Sub rectanplot()
    Dim2.Visible = False
    Dim3.Visible = False
    Dim4.Visible = False
End Sub
```

```
Label5.Visible = False  
Label6.Visible = False  
Label7.Visible = False  
Label8.Visible = False  
Label9.Visible = False  
Label10.Visible = False  
Label11.Visible = False  
Label12.Visible = False  
Label13.Visible = False
```

```
Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, ymax / 10)-(xmax - xmax / 20, ymax / 10), RGB(200, 200,  
200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, (ymax / 10 + (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax - xmax / 20,  
(ymax / 10 + (ymax - 2 * ymax / 10) / 5)), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, (ymax / 10 + 2 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax - xmax /  
20, (ymax / 10 + 2 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5)), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, (ymax / 10 + 3 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax - xmax /  
20, (ymax / 10 + 3 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5)), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, (ymax / 10 + 4 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax - xmax /  
20, (ymax / 10 + 4 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5)), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax - xmax /  
20, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5)), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax / 20,  
ymax / 10), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20 + (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 *  
ymax / 10) / 5))-(xmax / 20 + (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, ymax / 10), RGB(200, 200,  
200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20 + 2 * (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 *  
ymax / 10) / 5))-(xmax / 20 + 2 * (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, ymax / 10), RGB(200, 200,  
200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20 + 3 * (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax / 20 + 3 * (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, ymax / 10), RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Line (xmax / 20 + 4 * (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, (ymax / 10 + 5 * (ymax - 2 * ymax / 10) / 5))-(xmax / 20 + 4 * (xmax - 2 * xmax / 20) / 4, ymax / 10), RGB(200, 200, 200)
```

If dd = 1 And Timer1.Enabled = False Then

For j = 1 To 400

If j <= 200 Then

```
x1 = xmax / 2 - ((j - 1) * ((xmax - 2 * xmax / 20) / 400))
```

```
y1 = ymax - ((ymax / 10) + (ymax - 2 * ymax / 10) * Data(j - 1) / 5)
```

```
x2 = xmax / 2 - (j * ((xmax - 2 * xmax / 20) / 400))
```

```
y2 = ymax - ((ymax / 10) + (ymax - 2 * ymax / 10) * Data(j) / 5)
```

```
Picture1.Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(0, 0, 200)
```

```
Picture1.PSet (x2, y2), RGB(0, 0, 200)
```

ElseIf j > 200 And j < 400 Then

```
x1 = xmax - xmax / 20 - ((j - 200 - 1) * ((xmax - 2 * xmax / 20) / 400))
```

```
y1 = ymax - ((ymax / 10) + (ymax - 2 * ymax / 10) * Data(j - 1) / 5)
```

```
x2 = xmax - xmax / 20 - ((j - 200) * ((xmax - 2 * xmax / 20) / 400))
```

```
y2 = ymax - ((ymax / 10) + (ymax - 2 * ymax / 10) * Data(j) / 5)
```

```
Picture1.Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(0, 0, 200)
```

```
Picture1.PSet (x2, y2), RGB(0, 0, 200)
```

ElseIf j = 400 Then

```
x1 = xmax / 2
```

```
y1 = ymax - ((ymax / 10) + (ymax - 2 * ymax / 10) * Data(0) / 5)
```

```
Picture1.Line (x1, y1)-(x2, y2), RGB(0, 0, 200)
```

```
Picture1.PSet (x2, y2), RGB(0, 0, 200)
```

End If

Next j

End If

End Sub

Private Sub reset_Click()

Command1.Enabled = False

prcom.Enabled = False

reset.Enabled = False

If cc <> 0 Then

cc = 0

xmax = Picture1.ScaleWidth

ymax = Picture1.ScaleHeight

Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)

Timer1.Enabled = False

Timer2.Enabled = False

Timer3.Enabled = False

MSComm1.Output = "s"

For i = 0 To 399

Data(i) = 0

Next i

Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)

Picture1.Line (0, ymax / 2)-(xmax, ymax / 2), RGB(200, 200, 200)

Picture1.Line (xmax / 2, 0)-(xmax / 2, ymax), RGB(200, 200, 200)

Picture1.Line (xmax / 2 + 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 - 2147, ymax / 2 - 2147),
RGB(200, 200, 200)

Picture1.Line (xmax / 2 - 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 + 2147, ymax / 2 - 2147),
RGB(200, 200, 200)

```
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8, RGB(200, 200, 200)
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 2, RGB(200, 200, 200)
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 3, RGB(200, 200, 200)
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 4, RGB(200, 200, 200)

End If
Label2.Visible = True
Label3.Visible = True
Label4.Visible = True
Label5.Visible = True
Label6.Visible = True
Label7.Visible = True
Label8.Visible = True
Label9.Visible = True
Label10.Visible = True
Label11.Visible = True
Label12.Visible = True
Label13.Visible = True
End Sub
*****
Private Sub start_Click()
Command1.Enabled = True
start.Enabled = False
Command2.Enabled = False
Command3.Enabled = False
prcom.Enabled = False
reset.Enabled = False
bac.Enabled = False
Label1.Height = 0
Label1.Width = 0
Label1.Visible = False
Label1.Enabled = False
```

```
MSComm1.Output = "s"  
Timer1.Interval = 200  
Timer1.Enabled = True  
  
j = 1  
dd = 0  
cc = 1
```

```
Picture1.BackColor = RGB(255, 255, 255)  
Picture1.Line (0, ymax / 2)-(xmax, ymax / 2), RGB(200, 200, 200)  
Picture1.Line (xmax / 2, 0)-(xmax / 2, ymax), RGB(200, 200, 200)  
Picture1.Line (xmax / 2 + 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 - 2147, ymax / 2 - 2147),  
RGB(200, 200, 200)  
Picture1.Line (xmax / 2 - 2147, ymax / 2 + 2147)-(xmax / 2 + 2147, ymax / 2 - 2147),  
RGB(200, 200, 200)
```

```
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8, RGB(200, 200, 200)  
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 2, RGB(200, 200, 200)  
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 3, RGB(200, 200, 200)  
Picture1.Circle (xmax / 2, ymax / 2), ymax / 8 * 4, RGB(200, 200, 200)
```

```
Label2.Visible = True  
Label3.Visible = True  
Label4.Visible = True  
Label5.Visible = True  
Label6.Visible = True  
Label7.Visible = True  
Label8.Visible = True  
Label9.Visible = True  
Label10.Visible = True  
Label11.Visible = True  
Label12.Visible = True
```

```

Label13.Visible = True
j = 0
End Sub
*****
Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
Const SpeedBaud = 16000
Dim LngSize As Long, X
MSComm1.DTREnable = False
MSComm1.DTREnable = True
MSComm1.InputLen = 0

If dd = 1 Then
    MSComm1.Output = "1"
End If
Call plot

End Sub
*****
Sub plot()
    If dd = 0 Then
        MSComm1.Output = "d"           'get first data
        datain = MSComm1.Input
        j = datain
    End If

    dd = 1
    Data(0) = j
    info = Data(0)
    Form2.List1.List(0) = 0 & " : " & info

    Else

```

```

MSComm1.Output = "d"
datain = MSComm1.Input
j = datain
Data(i) = j
info = Data(i)
Form2.List1.List(i) = (i) * 0.9 & " : " & info

```

```

x1 = xmax / 2 + (Data(i - 1) * ymax / 10 * Cos(((i - 1) * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
y1 = ymax / 2 + (Data(i - 1) * ymax / 10 * Sin(((i - 1) * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
x2 = xmax / 2 + (Data(i) * ymax / 10 * Cos((i * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
y2 = ymax / 2 + (Data(i) * ymax / 10 * Sin((i * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))

```

```

Picture1.Line (x1, ymax - y1)-(x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)
Picture1.PSet (x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)

```

```
i = i + 1
```

```
End If
```

```
If i >= 400 Then 'limit data and plot line data(0)-data(360)
```

```

Timer1.Enabled = False
MSComm1.Output = "s"
prcom.Enabled = True
Command2.Enabled = True
Command3.Enabled = True
reset.Enabled = True
start.Enabled = True
bac.Enabled = True

```

```

MSComm1.Output = "d"
datain = MSComm1.Input

```

```

j = datain
Data(i) = j
info = Data(i)
Form2.List1.List(i) = (i) * 0.9 & " : " & info

x1 = xmax / 2 + (Data(0) * ymax / 10 * Cos((90) * 3.14159 / 180))
y1 = ymax / 2 + (Data(0) * ymax / 10 * Sin((90) * 3.14159 / 180))
x2 = xmax / 2 + (Data(400) * ymax / 10 * Cos((400 * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))
y2 = ymax / 2 + (Data(400) * ymax / 10 * Sin((400 * 0.9 + 90) * 3.14159 / 180))

Picture1.Line (x1, ymax - y1)-(x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)
Picture1.PSet (x2, ymax - y2), RGB(0, 0, 200)

End If
End Sub
*****
Private Sub Timer2_Timer()
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.Output = "l"
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
*****
Private Sub Timer3_Timer()
Comm1.PortOpen = True
Comm1.Output = "r"
Comm1.PortOpen = False
End Sub
*****
Private Sub Timer4_Timer()
Comm1.Output = "r"
b + 1
402 Then

```

```
Timer4.Interval = 0  
Timer4.Enabled = False  
End If  
End Sub
```

ภาคผนวก ฯ

ตารางแสดงผลกำลังงานวัดกำลังงานของสنانมแม่เหล็กไฟฟ้า

ทั้งในระนาบ E และระนาบ H

วัดกำลังงานของสถานะแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบ E ครั้งที่ 1

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
0.0	2.604	25.2	2.739	50.4	1.907
0.9	2.624	26.1	2.774	51.3	1.832
1.8	2.614	27.0	2.764	52.2	1.762
2.7	2.619	27.9	2.754	53.1	1.712
3.6	2.649	28.8	2.759	54.0	1.607
4.5	2.644	29.7	2.744	54.9	1.547
5.4	2.654	30.6	2.739	55.8	1.477
6.3	2.649	31.5	2.724	56.7	1.427
7.2	2.664	32.4	2.714	57.6	1.372
8.1	2.659	33.3	2.714	58.5	1.317
9.0	2.674	34.2	2.719	59.4	1.272
9.9	2.674	35.1	2.684	60.3	1.242
10.8	2.679	36.0	2.664	61.2	1.217
11.7	2.694	36.9	2.639	62.1	1.202
12.6	2.689	37.8	2.604	63.0	1.202
13.5	2.699	38.7	2.569	63.9	1.207
14.4	2.704	39.6	2.544	64.8	1.197
15.3	2.704	40.5	2.504	65.7	1.197
16.2	2.704	41.4	2.499	66.6	1.202
17.1	2.694	42.3	2.434	67.5	1.212
18.0	0.689	43.2	2.384	68.4	1.227
18.9	2.729	44.1	2.324	69.3	1.242
19.8	2.749	45.0	2.259	70.2	1.247
20.7	2.749	45.9	2.219	71.1	1.267
21.6	2.734	46.8	2.154	72.0	1.302
22.5	2.724	47.7	2.940	72.9	1.297
23.4	2.729	48.6	2.390	73.8	1.307
24.3	2.734	49.5	1.982	74.7	1.327

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
75.6	1.317	101.7	1.217	127.8	1.892
76.5	1.317	102.6	1.232	128.7	1.897
77.4	0.352	103.5	1.252	129.6	1.897
78.3	1.342	104.4	1.277	130.5	1.897
79.2	1.342	105.3	1.297	131.4	1.912
80.1	1.342	106.2	1.347	132.3	1.907
81.0	1.337	107.1	1.387	133.2	1.907
81.9	1.322	108.0	1.422	134.1	1.902
82.8	1.297	108.9	1.462	135.0	1.897
83.7	1.307	109.8	1.492	135.9	1.887
84.6	1.297	110.7	1.527	136.8	1.867
85.5	1.272	111.6	1.552	137.7	1.867
86.4	1.277	112.5	1.577	138.6	1.852
87.3	1.257	113.4	1.607	139.5	1.837
88.2	1.237	114.3	1.637	140.4	1.817
89.1	1.217	115.2	1.677	141.3	1.802
90.0	1.207	116.1	1.702	142.2	1.762
90.9	1.202	117.0	1.727	143.1	1.737
91.8	1.172	117.9	1.737	144.0	1.707
92.7	1.162	118.8	1.777	144.9	1.657
93.6	1.137	119.7	1.777	145.8	1.637
94.5	1.137	120.6	1.792	146.7	1.602
95.4	1.137	121.5	1.812	147.6	1.537
96.3	1.127	122.4	1.817	148.5	1.497
97.2	1.132	123.3	1.857	149.4	1.437
98.1	1.132	124.2	1.877	150.3	1.352
99.0	1.137	125.1	1.872	151.2	1.287
99.9	1.157	126.0	1.882	152.1	1.202
100.8	1.182	126.9	1.882	153.0	1.122

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
153.9	1.370	180.0	0.000	206.1	0.000
154.8	0.945	180.9	0.000	207.0	0.000
155.7	0.865	181.8	0.000	207.9	0.000
156.6	0.740	182.7	0.000	208.8	0.500
157.5	0.635	183.6	0.000	209.7	0.100
158.4	0.525	184.5	0.000	210.6	0.150
159.3	0.425	185.4	0.000	211.5	0.150
160.2	0.340	186.3	0.000	212.4	0.500
161.1	0.275	187.2	0.000	213.3	0.550
162.0	0.195	188.1	0.000	214.2	0.900
162.9	0.135	189.0	0.000	215.1	0.110
163.8	0.950	189.9	0.000	216.0	0.145
164.7	0.350	190.8	0.000	216.9	0.165
165.6	0.500	191.7	0.000	217.8	0.200
166.5	0.000	192.6	0.000	218.7	0.225
167.4	0.000	193.5	0.000	219.6	0.270
168.3	0.000	194.4	0.000	220.5	0.305
169.2	0.100	195.3	0.000	221.4	0.345
170.1	0.000	196.2	0.000	222.3	0.370
171.0	0.000	197.1	0.000	223.2	0.400
172.9	0.000	198.0	0.500	224.1	0.440
172.8	0.000	198.9	0.000	225.0	0.480
173.7	0.000	199.8	0.000	225.9	0.535
174.6	0.200	200.7	0.000	226.8	0.595
175.5	0.000	201.6	0.000	227.7	0.635
176.4	0.000	202.5	0.000	228.6	0.685
177.3	0.000	203.4	0.000	229.5	0.775
178.2	0.000	204.3	0.000	230.4	0.810
179.1	0.000	205.2	0.000	231.3	0.865

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
232.2	0.930	258.3	1.427	284.4	0.360
233.1	0.960	259.2	1.417	285.3	0.305
234.0	1.120	260.1	1.412	286.2	0.240
234.9	1.320	261.0	1.397	287.1	0.190
235.8	1.970	261.9	1.392	288.0	0.150
236.7	1.142	262.8	1.372	288.9	0.120
237.6	1.187	263.7	1.367	289.8	0.800
238.5	1.217	264.6	1.352	290.7	0.500
239.4	1.252	265.5	1.342	291.6	0.250
240.3	1.282	266.4	1.327	292.5	0.150
241.2	1.317	267.3	1.297	293.4	0.150
242.1	1.347	268.2	1.257	294.3	0.000
243.0	1.382	269.1	1.247	295.2	0.150
243.9	1.392	270.0	1.222	296.1	0.100
244.8	1.402	270.9	1.197	297.0	0.150
245.7	1.402	271.8	1.152	297.9	0.350
246.6	1.427	272.7	1.107	298.8	0.850
247.5	1.437	273.6	1.570	299.7	0.145
248.4	1.452	274.5	1.700	300.6	0.255
249.3	1.437	275.4	0.975	301.5	0.365
250.2	1.457	276.3	0.945	302.4	0.495
251.1	1.467	277.2	0.880	303.3	0.685
252.0	1.462	278.1	0.815	304.2	0.895
252.9	1.447	279.0	0.725	305.1	1.520
253.8	1.452	279.9	0.645	306.0	1.282
254.7	1.457	280.8	0.585	306.9	1.432
255.6	1.447	281.7	0.515	307.8	1.612
256.5	1.432	282.6	0.475	308.7	1.767
257.4	1.422	283.5	0.425	309.6	1.897

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
310.5	1.102	327.6	2.729	344.7	2.664
311.4	2.940	328.5	2.734	345.6	2.649
312.3	2.149	329.4	2.719	346.5	2.644
313.2	2.234	330.3	2.709	347.4	2.654
314.1	2.289	331.2	2.729	348.3	2.659
315.0	2.354	332.1	2.729	349.2	2.639
315.9	2.414	333.0	2.724	350.1	2.639
316.8	2.474	333.9	2.704	351.0	2.639
317.7	2.534	334.8	2.709	351.9	2.619
318.6	2.564	335.7	2.699	352.8	2.604
319.5	2.584	336.6	2.694	353.7	2.639
320.4	2.619"	337.5	2.689	354.6	2.629
321.3	2.634	338.4	2.684	355.5	2.634
322.2	2.664	339.3	2.714	356.4	2.599
323.1	2.674	340.2	2.694	357.3	2.624
324.0	2.689	341.1	2.689	358.2	2.614
324.9	2.719	342.0	2.689	359.1	2.604
325.8	2.734	342.9	2.674		
326.7	2.729	343.8	2.669		

วัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระนาบ E ครั้งที่ 2

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
0.0	2.614	25.2	2.724	50.4	2.164
0.9	2.609	26.1	2.719	51.3	2.740
1.8	2.614	27.0	2.754	52.2	2.140
2.7	2.614	27.9	2.754	53.1	2.190
3.6	2.624	28.8	2.759	54.0	1.887
4.5	2.644	29.7	2.754	54.9	1.812
5.4	2.639	30.6	2.754	55.8	1.732
6.3	2.659	31.5	2.749	56.7	1.662
7.2	2.649	32.4	2.729	57.6	1.612
8.1	2.659	33.3	2.764	58.5	1.532
9.0	2.644	34.2	2.754	59.4	1.462
9.9	2.644	35.1	2.744	60.3	1.442
10.8	2.679	36.0	2.724	61.2	1.337
11.7	2.694	36.9	2.719	62.1	1.287
12.6	2.704	37.8	2.694	63.0	1.252
13.5	2.699	38.7	2.689	63.9	1.242
14.4	2.694	39.6	2.644	64.8	1.202
15.3	2.699	40.5	2.619	65.7	1.182
16.2	2.699	41.4	2.614	66.6	1.172
17.1	2.694	42.3	2.574	67.5	1.177
18.0	2.699	43.2	2.549	68.4	1.177
18.9	2.729	44.1	2.504	69.3	1.182
19.8	2.729	45.0	2.464	70.2	1.187
20.7	2.719	45.9	2.449	71.1	1.217
21.6	2.729	46.8	2.364	72.0	1.232
22.5	2.724	47.7	2.309	72.9	1.257
23.4	2.734	48.6	2.254	73.8	1.262
24.3	2.719	49.5	2.219	74.7	1.252

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
75.6	1.297	101.7	1.820	127.8	1.897
76.5	1.302	102.6	1.920	128.7	1.897
77.4	1.312	103.5	1.107	129.6	1.907
78.3	1.327	104.4	1.127	130.5	1.922
79.2	1.347	105.3	1.167	131.4	1.942
80.1	1.357	106.2	1.202	132.3	1.942
81.0	1.357	107.1	1.247	133.2	1.942
81.9	1.352	108.0	1.302	134.1	1.942
82.8	1.347	108.9	1.337	135.0	1.942
83.7	1.347	109.8	1.377	135.9	1.937
84.6	1.337	110.7	1.377	136.8	1.932
85.5	1.327	111.6	1.442	137.7	1.927
86.4	1.327	112.5	1.492	138.6	1.932
87.3	1.307	113.4	1.532	139.5	1.932
88.2	1.287	114.3	1.562	140.4	1.912
89.1	1.287	115.2	1.592	141.3	1.902
90.0	1.247	116.1	1.647	142.2	1.902
90.9	1.227	117.0	1.677	143.1	1.857
91.8	1.192	117.9	1.687	144.0	1.842
92.7	1.157	118.8	1.697	144.9	1.822
93.6	1.147	119.7	1.742	145.8	1.812
94.5	1.112	120.6	1.767	146.7	1.802
95.4	1.107	121.5	1.782	147.6	1.757
96.3	1.127	122.4	1.812	148.5	1.712
97.2	1.102	123.3	1.847	149.4	1.672
98.1	1.570	124.2	1.877	150.3	1.637
99.0	1.470	125.1	1.862	151.2	1.587
99.9	1.170	126.0	1.872	152.1	1.527
100.8	1.670	126.9	1.892	153.0	1.477

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
153.9	1.467	180.0	0.000	206.1	0.000
154.8	1.357	180.9	0.000	207.0	0.000
155.7	1.287	181.8	0.000	207.9	0.000
156.6	1.212	182.7	0.000	208.8	0.000
157.5	1.117	183.6	0.000	209.7	0.000
158.4	1.120	184.5	0.000	210.6	0.000
159.3	0.930	185.4	0.000	211.5	0.500
160.2	0.815	186.3	0.000	212.4	0.300
161.1	0.795	187.2	0.000	213.3	0.450
162.0	0.655	188.1	0.000	214.2	0.550
162.9	0.535	189.0	0.000	215.1	0.125
163.8	0.435	189.9	0.500	216.0	0.175
164.7	0.330	190.8	0.000	216.9	0.225
165.6	0.260	191.7	0.000	217.8	0.265
166.5	0.180	192.6	0.000	218.7	0.265
167.4	0.130	193.5	0.000	219.6	0.335
168.3	0.950	194.4	0.000	220.5	0.380
169.2	0.400	195.3	0.150	221.4	0.420
170.1	0.500	196.2	0.000	222.3	0.460
171.0	0.000	197.1	0.000	223.2	0.490
172.9	0.000	198.0	0.000	224.1	0.515
172.8	0.000	198.9	0.000	225.0	0.560
173.7	0.000	199.8	0.000	225.9	0.565
174.6	0.000	200.7	0.000	226.8	0.600
175.5	0.000	201.6	0.000	227.7	0.640
176.4	0.000	202.5	0.000	228.6	0.670
177.3	0.000	203.4	0.000	229.5	0.675
178.2	0.000	204.3	0.000	230.4	0.710
179.1	0.000	205.2	0.000	231.3	0.730

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
232.2	0.745	258.3	1.547	284.4	0.495
233.1	0.755	259.2	1.562	285.3	0.435
234.0	0.755	260.1	1.557	286.2	0.415
234.9	0.760	261.0	1.547	287.1	0.385
235.8	0.810	261.9	1.542	288.0	0.350
236.7	0.805	262.8	1.527	288.9	0.295
237.6	0.845	263.7	1.517	289.8	0.240
238.5	0.870	264.6	1.517	290.7	0.240
239.4	0.890	265.5	1.497	291.6	0.160
240.3	0.890	266.4	1.487	292.5	0.130
241.2	0.935	267.3	1.457	293.4	0.110
242.1	0.965	268.2	1.417	294.3	0.600
243.0	1.200	269.1	1.412	295.2	0.400
243.9	1.570	270.0	1.352	296.1	0.150
244.8	1.920	270.9	1.322	297.0	0.150
245.7	1.132	271.8	1.277	297.9	0.150
246.6	1.167	272.7	1.247	298.8	0.150
247.5	1.177	273.6	1.192	299.7	0.150
248.4	1.257	274.5	1.142	300.6	0.150
249.3	1.287	275.4	1.720	301.5	0.500
250.2	1.332	276.3	1.670	302.4	0.600
251.1	1.377	277.2	0.985	303.3	0.140
252.0	1.412	278.1	0.925	304.2	0.235
252.9	1.437	279.0	0.855	305.1	0.270
253.8	1.462	279.9	0.810	306.0	0.480
254.7	1.452	280.8	0.755	306.9	0.650
255.6	1.497	281.7	0.690	307.8	0.875
256.5	1.507	282.6	0.615	308.7	1.107
257.4	1.507	283.5	0.605	309.6	1.302

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
310.5	1.502	327.6	2.709	344.7	2.689
311.4	1.682	328.5	2.714	345.6	2.684
312.3	1.697	329.4	2.719	346.5	2.669
313.2	1.902	330.3	2.724	347.4	2.689
314.1	2.400	331.2	2.724	348.3	2.689
315.0	2.104	332.1	2.729	349.2	2.684
315.9	2.189	333.0	2.739	350.1	2.669
316.8	2.259	333.9	2.734	351.0	2.664
317.7	2.339	334.8	2.724	351.9	2.639
318.6	2.409	335.7	2.724	352.8	2.654
319.5	2.409	336.6	2.714	353.7	2.634
320.4	2.489	337.5	2.714	354.6	2.649
321.3	2.509	338.4	2.704	355.5	2.624
322.2	2.569	339.3	2.704	356.4	2.644
323.1	2.589	340.2	2.719	357.3	2.634
324.0	2.614	341.1	2.734	358.2	2.634
324.9	2.674	342.0	2.714	359.1	2.634
325.8	2.694	342.9	2.704		
326.7	2.699	343.8	2.689		

วัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระนาบ H ครั้งที่ 1

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
0.0	2.759	25.2	2.799	50.4	2.774
0.9	2.749	26.1	2.804	51.3	2.769
1.8	2.759	27.0	2.804	52.2	2.754
2.7	2.759	27.9	2.804	53.1	2.759
3.6	2.739	28.8	2.774	54.0	2.739
4.5	2.759	29.7	2.784	54.9	2.719
5.4	2.744	30.6	2.814	55.8	2.699
6.3	2.734	31.5	2.819	56.7	2.664
7.2	2.744	32.4	2.819	57.6	2.629
8.1	2.764	33.3	2.814	58.5	2.629
9.0	2.769	34.2	2.804	59.4	2.599
9.9	2.769	35.1	2.804	60.3	2.584
10.8	2.764	36.0	2.809	61.2	2.569
11.7	2.759	36.9	2.804	62.1	2.539
12.6	2.744	37.8	2.839	63.0	2.504
13.5	2.754	38.7	2.839	63.9	2.474
14.4	2.764	39.6	2.834	64.8	2.444
15.3	2.774	40.5	2.824	65.7	2.439
16.2	2.789	41.4	2.824	66.6	2.404
17.1	2.784	42.3	2.824	67.5	2.389
18.0	2.784	43.2	2.819	68.4	2.364
18.9	2.779	44.1	2.824	69.3	2.329
19.8	2.789	45.0	2.824	70.2	2.309
20.7	2.789	45.9	2.834	71.1	2.269
21.6	2.779	46.8	2.819	72.0	2.254
22.5	2.779	47.7	2.809	72.9	2.239
23.4	2.799	48.6	2.809	73.8	2.204
24.3	2.809	49.5	2.789	74.7	2.174

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
75.6	2.169	101.7	1.317	127.8	0.920
76.5	2.144	102.6	1.242	128.7	0.925
77.4	2.134	103.5	1.217	129.6	0.925
78.3	2.690	104.4	1.172	130.5	0.930
79.2	2.640	105.3	1.152	131.4	0.935
80.1	2.490	106.2	1.122	132.3	0.930
81.0	2.240	107.1	1.620	133.2	0.940
81.9	1.102	108.0	1.320	134.1	0.960
82.8	1.102	108.9	1.170	135.0	0.945
83.7	1.992	109.8	0.995	135.9	0.960
84.6	1.962	110.7	0.985	136.8	0.945
85.5	1.917	111.6	0.955	137.7	0.940
86.4	1.892	112.5	0.950	138.6	0.945
87.3	1.882	113.4	0.930	139.5	0.945
88.2	1.857	114.3	0.905	140.4	0.945
89.1	1.822	115.2	0.890	141.3	0.935
90.0	1.797	116.1	0.885	142.2	0.920
90.9	1.757	117.0	0.885	143.1	0.905
91.8	1.737	117.9	0.880	144.0	0.890
92.7	1.672	118.8	0.875	144.9	0.890
93.6	1.652	119.7	0.885	145.8	0.875
94.5	1.637	120.6	0.880	146.7	0.860
95.4	1.577	121.5	0.880	147.6	0.840
96.3	1.547	122.4	0.885	148.5	0.810
97.2	1.507	123.3	0.870	149.4	0.805
98.1	1.462	124.2	0.890	150.3	0.785
99.0	1.432	125.1	0.885	151.2	0.780
99.9	1.367	126.0	0.895	152.1	0.760
100.8	1.347	126.9	0.905	153.0	0.725

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
153.9	0.695	180.0	0.270	206.1	0.660
154.8	0.650	180.9	0.275	207.0	0.695
155.7	0.650	181.8	0.260	207.9	0.750
156.6	0.635	182.7	0.250	208.8	0.780
157.5	0.590	183.6	0.250	209.7	0.795
158.4	0.590	184.5	0.250	210.6	0.835
159.3	0.570	185.4	0.265	211.5	0.845
160.2	0.515	186.3	0.280	212.4	0.885
161.1	0.505	187.2	0.300	213.3	0.920
162.0	0.485	188.1	0.270	214.2	0.960
162.9	0.475	189.0	0.270	215.1	1.200
163.8	0.445	189.9	0.285	216.0	1.700
164.7	0.425	190.8	0.300	216.9	1.170
165.6	0.405	191.7	0.325	217.8	1.420
166.5	0.395	192.6	0.340	218.7	1.720
167.4	0.375	193.5	0.355	219.6	1.107
168.3	0.37	194.4	0.350	220.5	1.142
169.2	0.37	195.3	0.350	221.4	1.162
170.1	0.345	196.2	0.380	222.3	1.197
171.0	0.315	197.1	0.400	223.2	1.202
172.9	0.305	198.0	0.435	224.1	1.197
172.8	0.305	198.9	0.440	225.0	1.252
173.7	0.310	199.8	0.455	225.9	1.272
174.6	0.295	200.7	0.485	226.8	1.307
175.5	0.285	201.6	0.510	227.7	1.317
176.4	0.275	202.5	0.535	228.6	1.327
177.3	0.275	203.4	0.58	229.5	1.342
178.2	0.260	204.3	0.600	230.4	1.367
179.1	0.255	205.2	0.635	231.3	1.377

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
232.2	1.432	258.3	1.662	284.4	2.369
233.1	1.417	259.2	1.652	285.3	2.399
234.0	1.422	260.1	1.667	286.2	2.404
234.9	1.437	261.0	1.702	287.1	2.439
235.8	1.447	261.9	1.732	288.0	2.439
236.7	1.462	262.8	1.757	288.9	2.469
237.6	1.477	263.7	1.782	289.8	2.479
238.5	1.487	264.6	1.792	290.7	2.479
239.4	1.497	265.5	1.862	291.6	2.509
240.3	1.497	266.4	1.882	292.5	2.529
241.2	1.502	267.3	1.872	293.4	2.539
242.1	1.502	268.2	1.927	294.3	2.569
243.0	1.512	269.1	1.947	295.2	2.584
243.9	1.527	270.0	1.101	296.1	2.579
244.8	1.517	270.9	2.14	297.0	2.589
245.7	1.522	271.8	2.54	297.9	2.599
246.6	1.502	272.7	2.84	298.8	2.609
247.5	1.522	273.6	2.99	299.7	2.654
248.4	1.532	274.5	2.99	300.6	2.674
249.3	1.542	275.4	2.114	301.5	2.689
250.2	1.542	276.3	2.159	302.4	2.699
251.1	1.552	277.2	2.209	303.3	2.689
252.0	1.547	278.1	2.234	304.2	2.699
252.9	1.532	279.0	2.249	305.1	2.714
253.8	1.552	279.9	2.284	306.0	2.734
254.7	1.587	280.8	2.289	306.9	2.774
255.6	1.587	281.7	2.304	307.8	2.774
256.5	1.607	282.6	2.314	308.7	2.779
257.4	1.612	283.5	2.344	309.6	2.779

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
310.5	2.794	327.6	2.814	344.7	2.804
311.4	2.794	328.5	2.814	345.6	2.804
312.3	2.804	329.4	2.854	346.5	2.804
313.2	2.804	330.3	2.834	347.4	2.789
314.1	2.809	331.2	2.824	348.3	2.789
315.0	2.834	332.1	2.814	349.2	2.769
315.9	2.819	333.0	2.819	350.1	2.764
316.8	2.839	333.9	2.814	351.0	2.789
317.7	2.839	334.8	2.819	351.9	2.794
318.6	2.834	335.7	2.804	352.8	2.804
319.5	2.829	336.6	2.834	353.7	2.784
320.4	2.819	337.5	2.819	354.6	2.769
321.3	2.819	338.4	2.819	355.5	2.759
322.2	2.839	339.3	2.809	356.4	2.759
323.1	2.839	340.2	2.814	357.3	2.759
324.0	2.844	341.1	2.799	358.2	2.759
324.9	2.834	342.0	2.799	359.1	2.774
325.8	2.819	342.9	2.794		
326.7	2.809	343.8	2.799		

วัดกำลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบ H ครั้งที่ 2

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
0.0	2.744	25.2	2.784	50.4	2.799
0.9	2.729	26.1	2.814	51.3	2.784
1.8	2.739	27.0	2.809	52.2	2.779
2.7	2.769	27.9	2.804	53.1	2.754
3.6	2.774	28.8	2.799	54.0	2.729
4.5	2.764	29.7	2.789	54.9	2.704
5.4	2.754	30.6	2.799	55.8	2.704
6.3	2.759	31.5	2.794	56.7	2.699
7.2	2.749	32.4	2.799	57.6	2.674
8.1	2.749	33.3	2.824	58.5	2.639
9.0	2.754	34.2	2.824	59.4	2.629
9.9	2.749	35.1	2.809	60.3	2.599
10.8	2.779	36.0	2.804	61.2	2.574
11.7	2.764	36.9	2.804	62.1	2.559
12.6	2.774	37.8	2.809	63.0	2.544
13.5	2.769	38.7	2.814	63.9	2.529
14.4	2.774	39.6	2.814	64.8	2.479
15.3	2.779	40.5	2.814	65.7	2.459
16.2	2.769	41.4	2.834	66.6	2.444
17.1	2.764	42.3	2.839	67.5	2.414
18.0	2.764	43.2	2.834	68.4	2.389
18.9	2.789	44.1	2.829	69.3	2.359
19.8	2.794	45.0	2.829	70.2	2.324
20.7	2.794	45.9	2.824	71.1	2.334
21.6	2.784	46.8	2.809	72.0	2.289
22.5	2.784	47.7	2.814	72.9	2.264
23.4	2.779	48.6	2.829	73.8	2.264
24.3	2.759	49.5	2.819	74.7	2.234

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
75.6	2.194	101.7	1.337	127.8	0.880
76.5	2.164	102.6	1.317	128.7	0.895
77.4	2.144	103.5	1.247	129.6	0.900
78.3	2.139	104.4	1.192	130.5	0.910
79.2	2.109	105.3	1.167	131.4	0.920
80.1	2.890	106.2	1.117	132.3	0.935
81.0	2.840	107.1	1.720	133.2	0.950
81.9	2.390	108.0	1.220	134.1	0.960
82.8	2.140	108.9	1.120	135.0	0.965
83.7	1.102	109.8	0.990	135.9	0.965
84.6	1.992	110.7	0.965	136.8	0.975
85.5	1.987	111.6	0.935	137.7	0.980
86.4	1.937	112.5	0.905	138.6	0.990
87.3	1.927	113.4	0.890	139.5	0.995
88.2	1.907	114.3	0.865	140.4	0.995
89.1	1.872	115.2	0.860	141.3	0.995
90.0	1.837	116.1	0.840	142.2	0.985
90.9	1.812	117.0	0.840	143.1	0.965
91.8	1.777	117.9	0.820	144.0	0.985
92.7	1.742	118.8	0.815	144.9	0.990
93.6	1.702	119.7	0.815	145.8	0.995
94.5	1.672	120.6	0.820	146.7	0.970
95.4	1.647	121.5	0.830	147.6	0.955
96.3	1.597	122.4	0.840	148.5	0.940
97.2	1.557	123.3	0.835	149.4	0.935
98.1	1.512	124.2	0.835	150.3	0.920
99.0	1.477	125.1	0.845	151.2	0.915
99.9	1.422	126.0	0.860	152.1	0.895
100.8	1.362	126.9	0.870	153.0	0.895

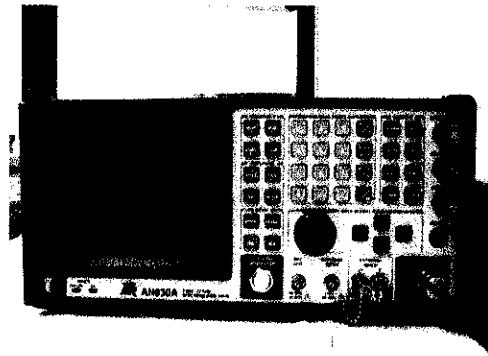
องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
153.9	0.850	180.0	0.380	206.1	0.750
154.8	0.825	180.9	0.385	207.0	0.785
155.7	0.820	181.8	0.390	207.9	0.800
156.6	0.805	182.7	0.385	208.8	0.845
157.5	0.790	183.6	0.375	209.7	0.880
158.4	0.760	184.5	0.370	210.6	0.890
159.3	0.740	185.4	0.370	211.5	0.905
160.2	0.725	186.3	0.380	212.4	0.950
161.1	0.700	187.2	0.395	213.3	0.975
162.0	0.665	188.1	0.400	214.2	0.101
162.9	0.655	189.0	0.395	215.1	1.200
163.8	0.640	189.9	0.395	216.0	1.420
164.7	0.605	190.8	0.410	216.9	1.620
165.6	0.590	191.7	0.410	217.8	1.770
166.5	0.555	192.6	0.430	218.7	1.970
167.4	0.555	193.5	0.455	219.6	1.107
168.3	0.525	194.4	0.470	220.5	1.152
169.2	0.515	195.3	0.475	221.4	1.162
170.1	0.495	196.2	0.470	222.3	1.192
171.0	0.500	197.1	0.500	223.2	1.207
172.9	0.450	198.0	0.525	224.1	1.222
172.8	0.435	198.9	0.550	225.0	1.232
173.7	0.430	199.8	0.580	225.9	1.252
174.6	0.430	200.7	0.595	226.8	1.262
175.5	0.425	201.6	0.625	227.7	1.297
176.4	0.410	202.5	0.620	228.6	1.302
177.3	0.405	203.4	0.660	229.5	1.327
178.2	0.390	204.3	0.700	230.4	1.347
179.1	0.365	205.2	0.720	231.3	1.342

องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
232.2	1.367	258.3	1.632	284.4	2.349
233.1	1.362	259.2	1.657	285.3	2.369
234.0	1.382	260.1	1.657	286.2	2.399
234.9	1.402	261.0	1.672	287.1	2.399
235.8	1.412	261.9	1.712	288.0	2.449
236.7	1.417	262.8	1.747	288.9	2.449
237.6	1.417	263.7	1.762	289.8	2.469
238.5	1.447	264.6	1.797	290.7	2.474
239.4	1.442	265.5	1.837	291.6	2.494
240.3	1.452	266.4	1.877	292.5	2.509
241.2	1.457	267.3	1.897	293.4	2.519
242.1	1.457	268.2	1.917	294.3	2.524
243.0	1.472	269.1	1.962	295.2	2.559
243.9	1.482	270.0	1.972	296.1	2.579
244.8	1.487	270.9	1.1012	297.0	2.589
245.7	1.492	271.8	2.900	297.9	2.604
246.6	1.487	272.7	2.540	298.8	2.614
247.5	1.492	273.6	2.990	299.7	2.629
248.4	1.502	274.5	2.114	300.6	2.629
249.3	1.472	275.4	2.124	301.5	2.659
250.2	1.517	276.3	2.169	302.4	2.689
251.1	1.522	277.2	2.184	303.3	2.709
252.0	1.537	278.1	2.209	304.2	2.709
252.9	1.542	279.0	2.224	305.1	2.714
253.8	1.547	279.9	2.264	306.0	2.719
254.7	1.562	280.8	2.304	306.9	2.744
255.6	1.567	281.7	2.309	307.8	2.739
256.5	1.572	282.6	2.324	308.7	2.754
257.4	1.602	283.5	2.334	309.6	2.779

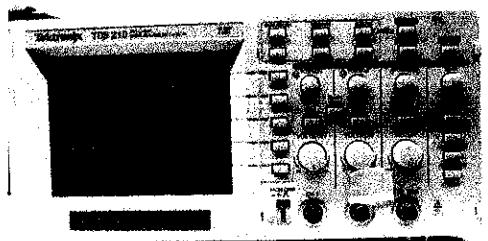
องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)	องศา (Degree)	ระดับแรงดัน (V)
310.5	2.804	327.6	2.834	344.7	2.794
311.4	2.799	328.5	2.819	345.6	2.774
312.3	2.799	329.4	2.814	346.5	2.774
313.2	2.809	330.3	2.809	347.4	2.804
314.1	2.814	331.2	2.814	348.3	2.799
315.0	2.819	332.1	2.844	349.2	2.799
315.9	2.809	333.0	2.829	350.1	2.789
316.8	2.819	333.9	2.824	351.0	2.774
317.7	2.844	334.8	2.814	351.9	2.769
318.6	2.849	335.7	2.814	352.8	2.764
319.5	2.829	336.6	2.814	353.7	2.764
320.4	2.839	337.5	2.809	354.6	2.789
321.3	2.819	338.4	2.804	355.5	2.774
322.2	2.829	339.3	2.824	356.4	2.769
323.1	2.814	340.2	2.814	357.3	2.759
324.0	2.819	341.1	2.814	358.2	2.764
324.9	2.844	342.0	2.814	359.1	2.774
325.8	2.839	342.9	2.814		
326.7	2.834	343.8	2.809		

ภาคผนวก ค

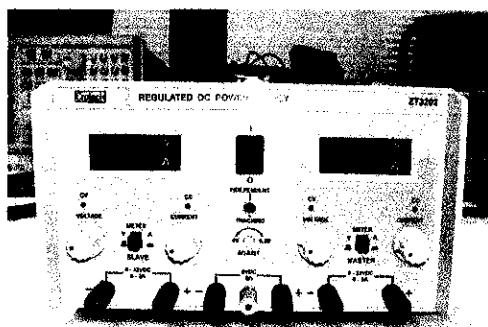
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำโครงการ



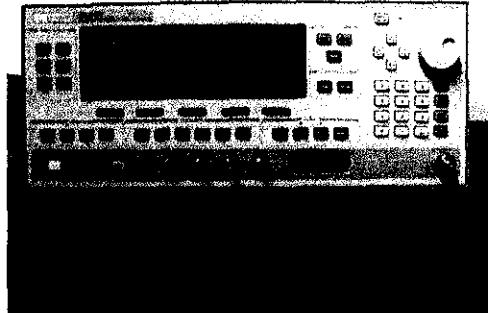
Spectrum Analyzer



Digital Real-Time Oscilloscope (Tektronix)



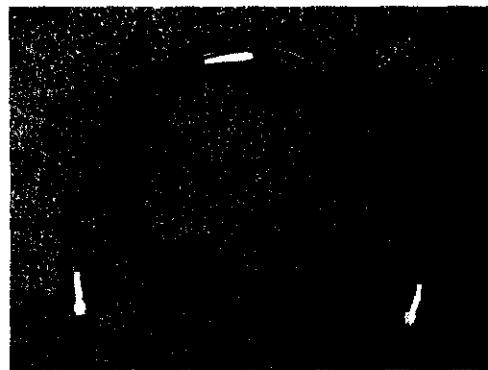
Regulated DC Power Supply (Crotech)



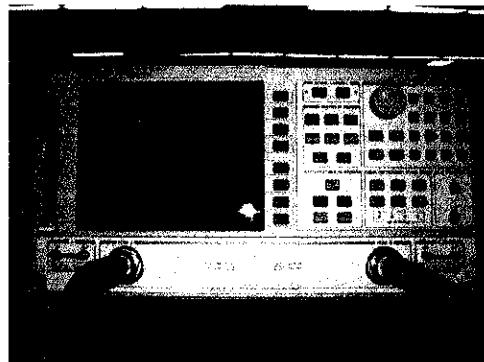
Signal Generator (HEWLETT PACKARD)



DC Power Supply 6553A (HEWLETT PACKARD)



สายวัสดุภายนอกที่ความถี่สูง

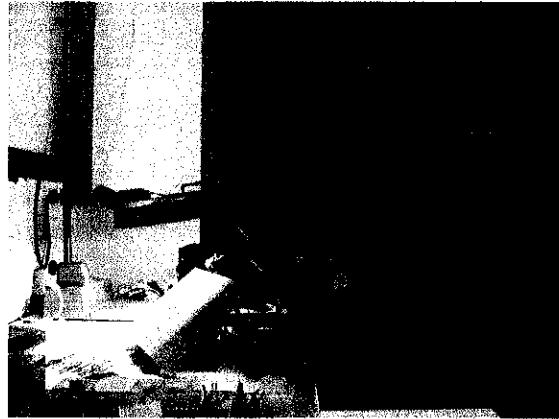


Network Analyzer

รูปในการปฏิบัติงาน



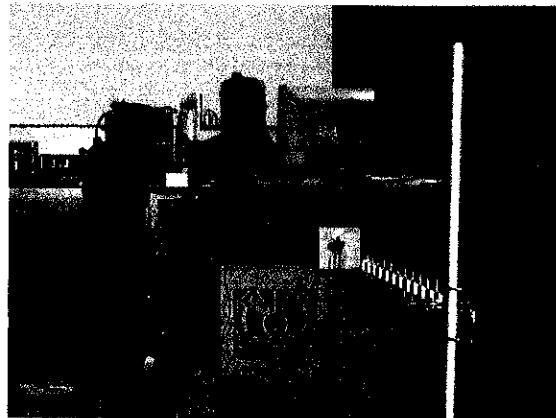
การบัดกรี MMIC และ IC ลงในวงจร



นำเอาวงจรย่ออย่างๆ บรรจุลงในกล่องวงจรภาครับ



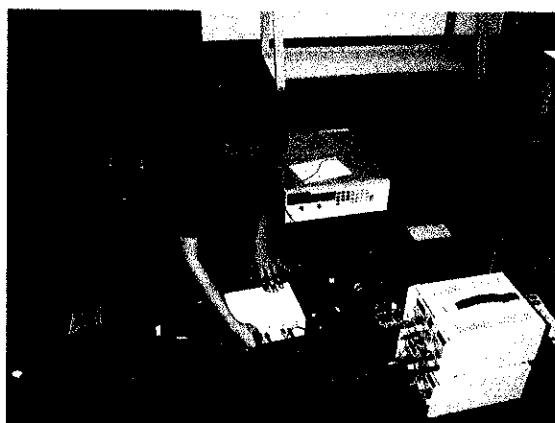
ต่อเชื่อมวงจรต่างๆ ในกล่องวงจรภาครับ



ทำการรันโปรแกรม



ทำการต่อสายอากาศ



ต่อชุดอุปกรณ์และกล่องวงจรภาครับ

Data Sheet



HMC414MS8G / 414MS8GE

GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz

5

Typical Applications

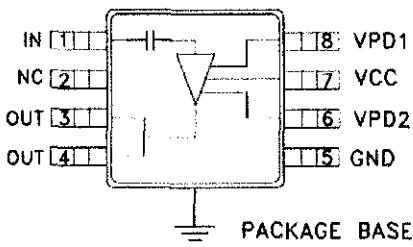
This amplifier is ideal for use as a power amplifier for 2.2 - 2.7 GHz applications:

- BLUETOOTH
- MMDS

Features

- Gain: 20 dB
- Saturated Power: +30 dBm
- 32% PAE
- Supply Voltage: +2.75V to +5.0 V
- Power Down Capability
- Low External Part Count

Functional Diagram



General Description

The HMC414MS8G & HMC414MS8GE are high efficiency GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC Power amplifiers which operate between 2.2 and 2.8 GHz. The amplifier is packaged in a low cost, surface mount 8 leaded package with an exposed base for improved RF and thermal performance. With a minimum of external components, the amplifier provides 20 dB of gain, +30 dBm of saturated power at 32% PAE from a +5.0 V supply voltage. The amplifier can also operate with a 3.6 V supply. Vpd can be used for full power down or RF output power/current control.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ C$, As a Function of V_s , $V_{pd} = 3.6V$

Parameter	$V_s = 3.6V$			$V_s = 5.0V$			Units
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Frequency Range		2.2 - 2.8			2.2 - 2.8		GHz
Gain	17	20	25	17	20	25	dB
Gain Variation Over Temperature		0.03	0.04		0.03	0.04	dB/°C
Input Return Loss		8			8		dB
Output Return Loss		9			9		dB
Output Power for 1 dB Compression (P_{1dB})	21	25		23	27		dBm
Saturated Output Power (P_{sat})		27			30		dBm
Output Third Order Intercept (I_{PO3})	30	35		35	39		dBm
Noise Figure		6.5			7.0		dB
Supply Current (I_{Q})	$V_{pd} = 0V / 3.6V$	0.002 / 240			0.002 / 300		mA
Control Current (I_{pd})	$V_{pd} = 3.6V$	7			7		mA
Switching Speed	t_{ON}, t_{OFF}	45			45		ns

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com

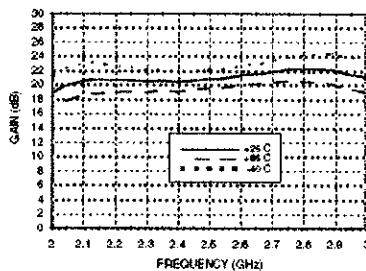


HMC414MS8G / 414MS8GE

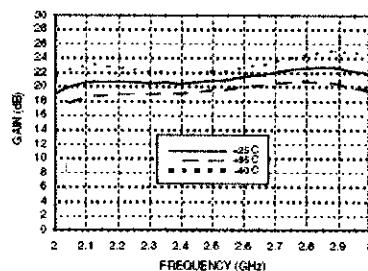
GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz

5

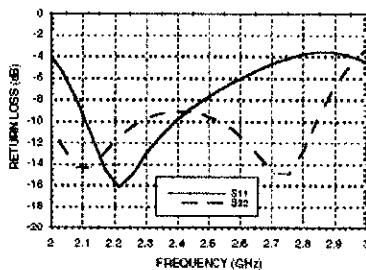
Gain vs. Temperature, Vs = 3.6V



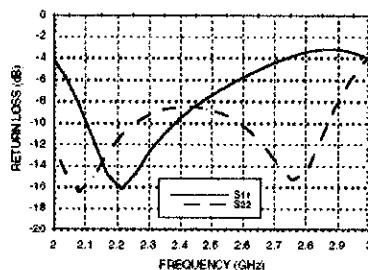
Gain vs. Temperature, Vs = 5.0V



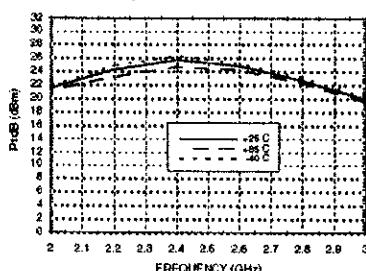
Return Loss, Vs = 3.6V



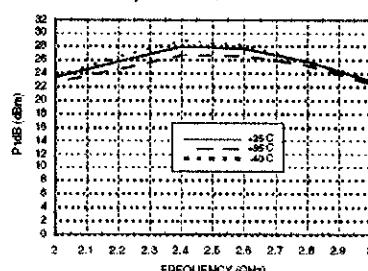
Return Loss, Vs = 5.0V



P1dB vs. Temperature, Vs = 3.6V



P1dB vs. Temperature, Vs = 5.0V



AMPLIFIERS - SMT

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com

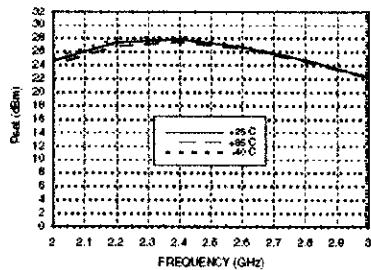
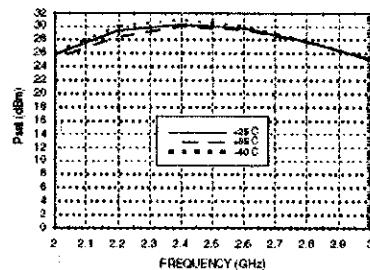
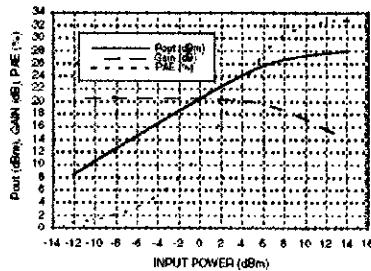
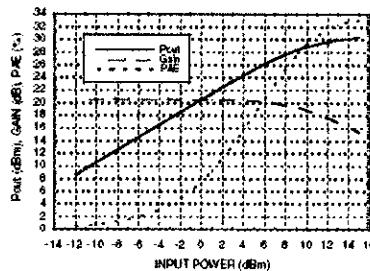
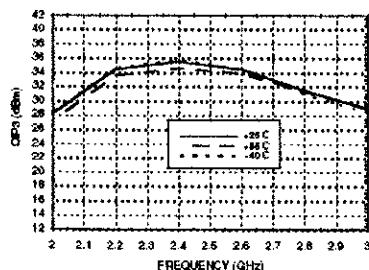
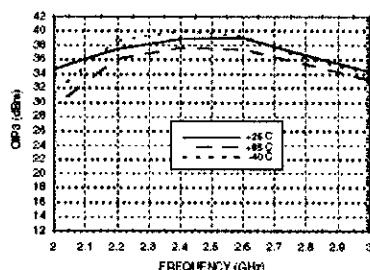


MICROWAVE CORPORATION v03.0505

**HMC414MS8G / 414MS8GE**

**GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz**

5

P_{sat} vs. Temperature, V_s = 3.6V**P_{sat} vs. Temperature, V_s = 5.0V****Power Compression@ 2.4 GHz, V_s = 3.6V****Power Compression@ 2.4 GHz, V_s = 5.0V****Output IP3 vs. Temperature, V_s = 3.6V****Output IP3 vs. Temperature, V_s = 5.0V**

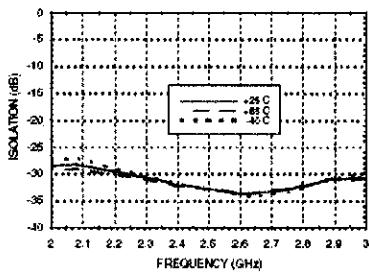
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com



V03.0505



Reverse Isolation
vs. Temperature, Vs = 3.6V



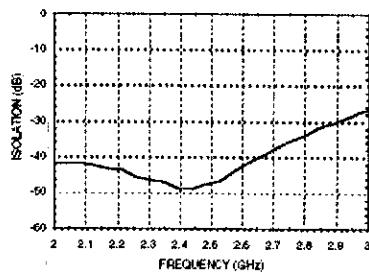
HMC414MS8G / 414MS8GE

GaAs InGap HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz

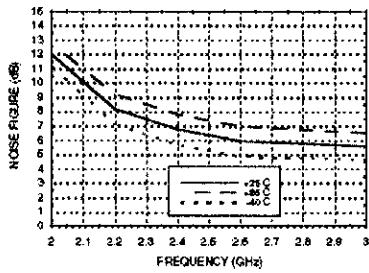
5

AMPLIFIERS - SMT

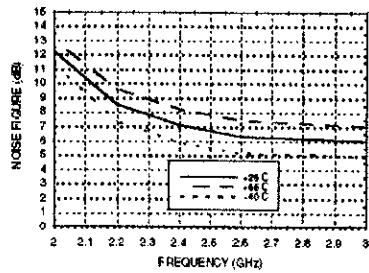
Power Down Isolation, Vs = 3.6V



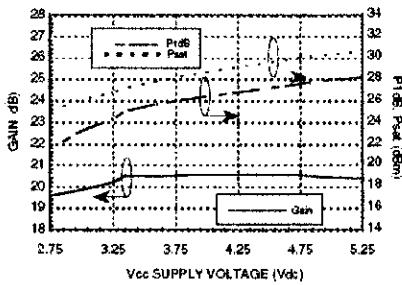
Noise Figure vs. Temperature, Vs = 3.6V



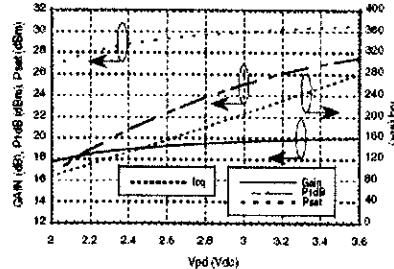
Noise Figure vs. Temperature, Vs = 5.0V



Gain & Power vs. Supply Voltage



Gain, Power & Quiescent Supply Current vs Vpd@ 2.4 GHz



For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com



v03.0506

HMC414MS8G / 414MS8GE

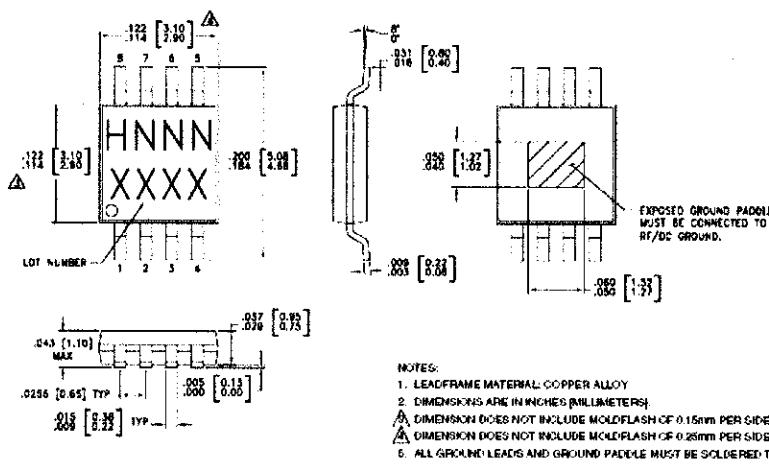
**GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz**

Absolute Maximum Ratings

Collector Bias Voltage (V _{CC})	+5.5 Vdc
Control Voltage (V _{PD1} , V _{PD2})	+4.0 Vdc
RF Input Power (RFin) (V _S = +5.0, V _{PD} = +3.6 Vdc)	+17 dBm
Junction Temperature	150 °C
Continuous Pdles (T = 85 °C) (derate 27 mW/°C above 85 °C)	1.755 W
Thermal Resistance (junction to ground paddle)	37 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

Outline Drawing**Package Information**

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking [3]
HMC414MS8G	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 [1]	H414 XXXX
HMC414MS8GE	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 [1]	H414 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
 20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
 Order On-line at www.hittite.com



MICROWAVE CORPORATION

v03.0605

**HMC414MS8G / 414MS8GE****GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz**

5

AMPLIFIERS - SMT**Pin Descriptions**

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms from 2.2 to 2.8 GHz.	RFIN O--- ---
2	NC	Not Connected.	
3, 4	RFOUT	RF output and DC bias for the output stage.	
5	GND	Ground: Backside of package has exposed metal ground slug that must be connected to ground thru a short path. Vias under the device are required.	
6, 8	Vpd1, Vpd2	Power control pin. For maximum power, this pin should be connected to 3.6V. For 5V operation, a dropping resistor is required. A higher voltage is not recommended. For lower idle current, this voltage can be reduced.	
7	Vcc	Power supply voltage for the first amplifier stage. An external bypass capacitor of 330 pF is required as shown in the application schematic.	

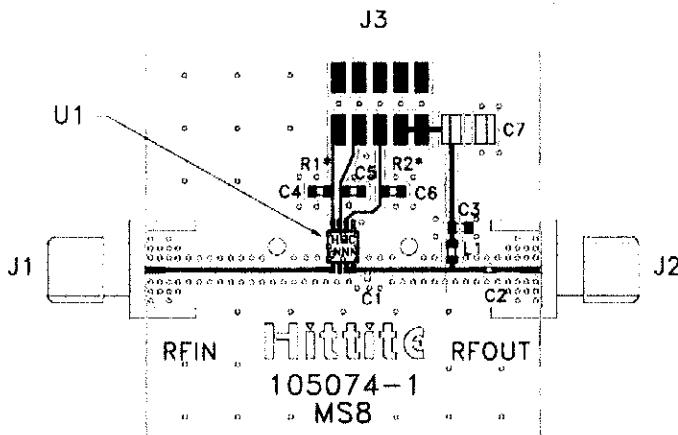
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
 20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
 Order On-line at www.hittite.com



MICROWAVE CORPORATION v03.0505

**HMC414MS8G / 414MS8GE****GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz**

5

Evaluation PCB

* For 5V operation on Vcc1 line,
select R1, R2 such that 3.6V is
presented on Pins 6 and 8.

List of Materials for Evaluation PCB 105006 [1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA RF Connector
J3	2 mm DC Header
C1	2.7 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C2	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C3 - C6	330 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C7	2.2 μ F Capacitor, Tantalum
L1	18nH Inductor 0603 Pkg.
U1	HMC414MS8G / HMC414MS8GE Amplifier
PCB [2]	105074 Eval Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of VIA holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com



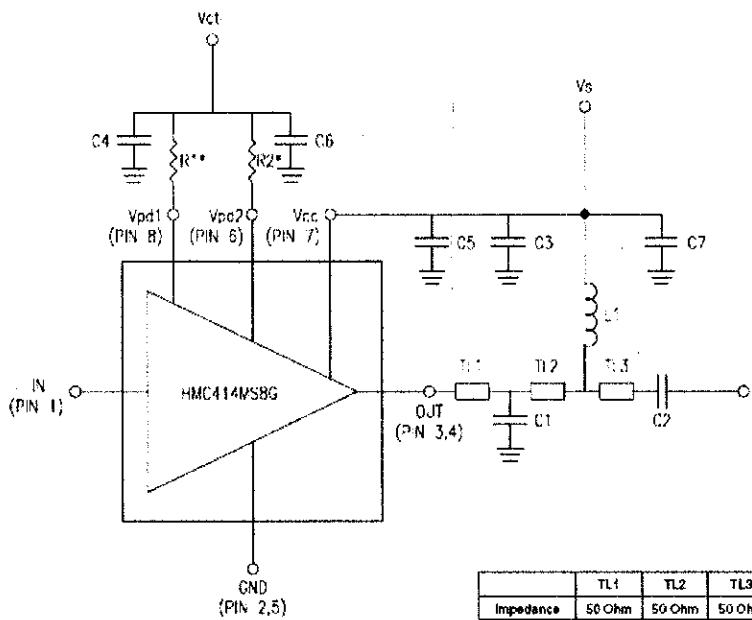
HMC414MS8G / 414MS8GE

GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 2.2 - 2.8 GHz

5

AMPLIFIERS - SMT

Application Circuit



* For 5V operation on Vcc line, select R1, R2 such that 3.6V is presented on Pins 6 and 8.

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com



Surface Mount RF Schottky Barrier Diodes

Technical Data

HSMS-282x Series

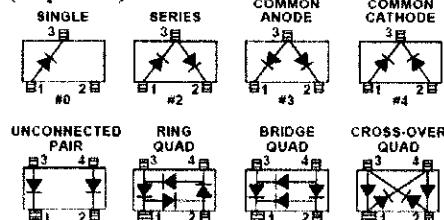
Features

- Low Turn-On Voltage (As Low as 0.34V at 1 mA)
- Low FIT (Failure in Time) Rate¹
- Six-sigma Quality Level
- Single, Dual and Quad Versions
- Unique Configurations in Surface Mount SOT-363 Package
 - increase flexibility
 - save board space
 - reduce cost
- HSMS-282K Grounded Center Leads Provide up to 10 dB Higher Isolation
- Matched Diodes for Consistent Performance
- Better Thermal Conductivity for Higher Power Dissipation
- For more information see the Surface Mount Schottky Reliability Data Sheet.

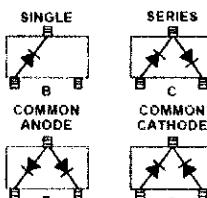
Description/Applications

These Schottky diodes are specifically designed for both analog and digital applications. This series offers a wide range of specifications and package configurations to give the designer wide flexibility. Typical applications of these Schottky diodes are mixing, detecting, switching, sampling, clamping, and wave shaping. The HSMS-282x series of diodes is the

Package Lead Code Identification, SOT-23/SOT-143 (Top View)



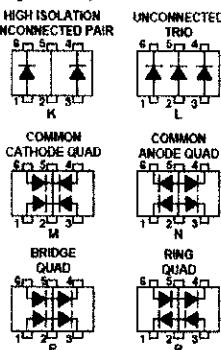
Package Lead Code Identification, SOT-323 (Top View)



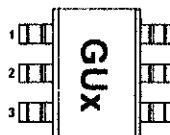
best all-around choice for most applications, featuring low series resistance, low forward voltage at all current levels and good RF characteristics.

Note that Agilent's manufacturing techniques assure that dice found in pairs and quads are taken from adjacent sites on the wafer, assuring the highest degree of match

Package Lead Code Identification, SOT-363 (Top View)



Pin Connections and Package Marking



Notes:

1. Package marking provides orientation and identification.
2. See "Electrical Specifications" for appropriate package marking.

Absolute Maximum Ratings⁽¹⁾ $T_c = 25^\circ\text{C}$

Symbol	Parameter	Unit	SOT-23/SOT-413	SOT-323/SOT-363
I_F	Forward Current (1 μs Pulse)	Amp	1	1
V_{PI}	Peak Inverse Voltage	V	15	15
T_j	Junction Temperature	$^\circ\text{C}$	150	150
T_{sg}	Storage Temperature	$^\circ\text{C}$	-65 to 150	-65 to 150
θ_{jk}	Thermal Resistance ⁽²⁾	$^\circ\text{C}/\text{W}$	600	150

Notes:

1. Operation in excess of any one of these conditions may result in permanent damage to the device.
2. $T_c = +25^\circ\text{C}$, where T_c is defined to be the temperature at the package pins where contact is made to the circuit board.

Electrical Specifications $T_c = 25^\circ\text{C}$, Single Diode⁽¹⁾

Part Number HSM3 ⁽³⁾	Package Marking Code	Lead Code	Configuration	Minimum Breakdown Voltage V_BD (V)	Maximum Forward Voltage V_F (mV)	Maximum Forward Voltage V_F (V) Φ	Maximum Reverse Leakage I_R (mA) Φ	Maximum Capacitance C_V (pF)	Typical Dynamic Resistance R_D (Ω) ⁽⁴⁾
2821	C0 ⁽⁵⁾	0	Single Series		340	0.5 - 10	100 - 1	1.0	12
2822	C2 ⁽⁵⁾	2	Common Anode						
2823	C3 ⁽⁵⁾	3	Common Cathode						
2824	C4 ⁽⁵⁾	4	Unconnected Pair						
2825	C5 ⁽⁵⁾	5	Ring Quad ⁽⁶⁾						
2827	C7 ⁽⁵⁾	7	Bridge Quad ⁽⁶⁾						
2828	C8 ⁽⁵⁾	8	Cross-over Quad						
2829	C9 ⁽⁵⁾	9	Single						
282B	C0 ⁽⁵⁾	B	Series						
282C	C2 ⁽⁵⁾	C	Common Anode						
282E	C3 ⁽⁵⁾	E	Common Cathode						
282F	C4 ⁽⁵⁾	F	High Isolation						
282K	C8 ⁽⁵⁾	K	Unconnected Pair						
282L	CL ⁽⁵⁾	L	Unconnected Trio						
282M	HH ⁽⁵⁾	M	Common Cathode Quad						
282N	NN ⁽⁵⁾	N	Common Anode Quad						
282P	CP ⁽⁵⁾	P	Bridge Quad						
282R	OO ⁽⁵⁾	R	Ring Quad						
Test Conditions				$I_F = 100 \mu\text{A}$	$I_F = 1 \text{ mA}$ ⁽¹⁾			$V_F = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}^{(2)}$	$I_F = 5 \text{ mA}$

Notes:

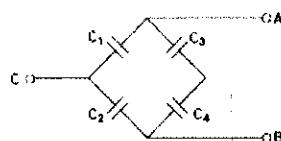
1. ΔV_F for diodes in pairs and quads is 15 mV maximum at 1 mA.
2. ΔC_{Vf} for diodes in pairs and quads is 0.2 pF maximum.
3. Package marking code is in white.
4. Effective Carrier Lifetime (τ) for all these diodes is 100 μs maximum measured with Krakauer method at 5 mA.
5. See section titled "Quad Capacitance."
6. $R_D = R_S + 5.2\Omega$ at 25°C and $I_F = 5 \text{ mA}$.
7. Package marking code is laser marked.

Quad Capacitance

Capacitance of Schottky diode quads is measured using an HP4271 LCR meter. This instrument effectively isolates individual diode branches from the others, allowing accurate capacitance measurement of each branch or each diode. The conditions are: 20 mV R.M.S. voltage at 1 MHz. Agilent defines this measurement as "CM", and it is equivalent to the capacitance of the diode by itself. The equivalent diagonal and adjacent capacitances can then be calculated by the formulas given below.

In a quad, the diagonal capacitance is the capacitance between points A and B as shown in the figure below. The diagonal capacitance is calculated using the following formula

$$C_{\text{DIAGONAL}} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} + \frac{C_3 \times C_4}{C_3 + C_4}$$

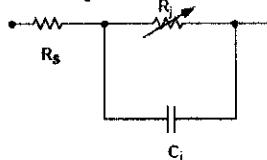


The equivalent adjacent capacitance is the capacitance between points A and C in the figure below. This capacitance is calculated using the following formula

$$C_{\text{ADJACENT}} = C_1 + \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}}$$

This information does not apply to cross-over quad diodes.

Linear Equivalent Circuit Model Diode Chip



R_s = series resistance (see Table of SPICE parameters)
 C_j = junction capacitance (see Table of SPICE parameters)

$$R_s = \frac{8.33 \times 10^{-6} nT}{I_b + I_s}$$

where

I_b = externally applied bias current in amps

I_s = saturation current (see table of SPICE parameters)

T = temperature, °K

n = ideality factor (see table of SPICE parameters)

SPICE Parameters

Parameter	Units	HSMS-282x
B_V	V	15
C_{j0}	pF	0.7
E_G	eV	0.69
I_{BV}	A	1E-4
I_S	A	2.2E-8
N		1.08
R_S	Ω	6.0
P_B	V	0.65
P_T		2
M		0.5

Note:
To effectively model the packaged HSMS-282x product,
please refer to Application Note AN1124.

ESD WARNING:
Handling Precautions Should Be Taken To Avoid Static Discharge.

Typical Performance, $T_c = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise noted). Single Diode

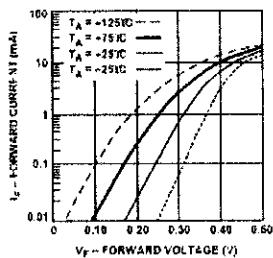


Figure 1. Forward Current vs.
Forward Voltage at Temperatures.

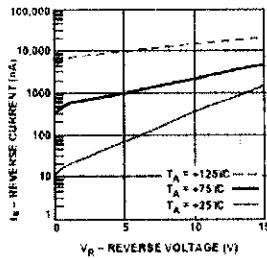


Figure 2. Reverse Current vs.
Reverse Voltage at Temperatures.

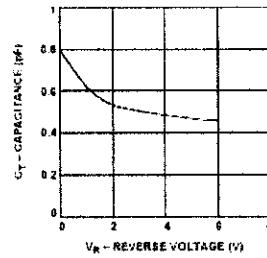


Figure 3. Total Capacitance vs.
Reverse Voltage.

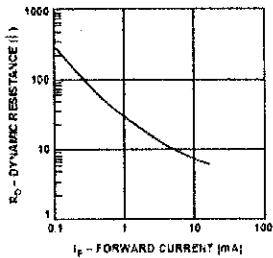


Figure 4. Dynamic Resistance vs.
Forward Current.

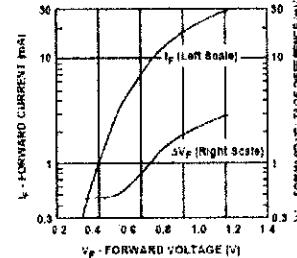


Figure 5. Typical V_g Match, Series Pairs
and Quads at Mixer Bias Levels

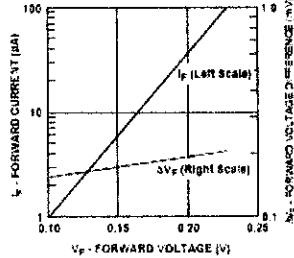


Figure 6. Typical V_g Match, Series Pairs
at Detector Bias Levels

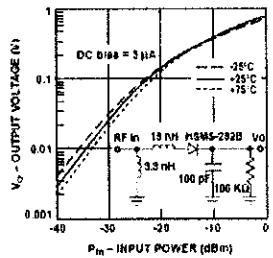


Figure 7. Typical Output Voltage vs.
Input Power, Small Signal Detector
Operating at 830 MHz.

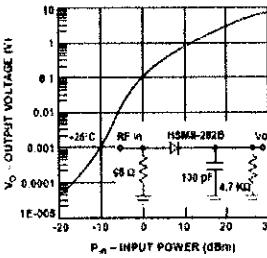


Figure 8. Typical Output Voltage vs.
Input Power, Large Signal Detector
Operating at 915 MHz.

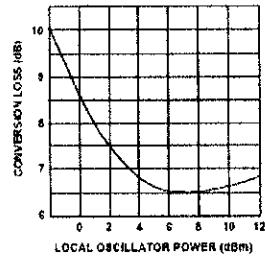


Figure 9. Typical Conversion Loss vs.
L.O. Drive, 2.0 GHz (Ref AN897).

Applications Information

Product Selection

Agilent's family of surface mount Schottky diodes provide unique solutions to many design problems. Each is optimized for certain applications.

The first step in choosing the right product is to select the diode type. All of the products in the HSMS-282x family use the same diode chip—they differ only in package configuration. The same is true of the HSMS-280x, -281x, -283x, -286x and -270x families. Each family has a different set of characteristics, which can be compared most easily by consulting the SPICE parameters given on each data sheet.

The HSMS-282x family has been optimized for use in RF applications, such as

- ✓ DC biased small signal detectors to 1.5 GHz.
- ✓ Biased or unbiased large signal detectors (AGC or power monitors) to 4 GHz.
- ✓ Mixers and frequency multipliers to 6 GHz

The other feature of the HSMS-282x family is its unit-to-unit and lot-to-lot consistency. The silicon chip used in this series has been designed to use the fewest possible processing steps to minimize variations in diode characteristics. Statistical data on the consistency of this product, in terms of SPICE parameters, is available from Agilent.

For those applications requiring very high breakdown voltage, use the HSMS-280x family of diodes. Turn to the HSMS-281x when you

need very low flicker noise. The HSMS-283x is a family of zero bias detector diodes for small signal applications. For high frequency detector or mixer applications, use the HSMS-286x family. The HSMS-270x is a series of specialty diodes for ultra high speed clamping and clamping in digital circuits.

Schottky Barrier Diode Characteristics

Stripped of its package, a Schottky barrier diode chip consists of a metal-semiconductor barrier formed by deposition of a metal layer on a semiconductor. The most common of several different types, the passivated diode, is shown in Figure 10, along with its equivalent circuit.

R_s is the parasitic series resistance of the diode, the sum of the bondwire and leadframe resistance, the resistance of the bulk layer of silicon, etc. RF energy coupled into R_s is lost as heat—it does not contribute to the rectified output of the diode. C_J is parasitic junction capacitance of the diode, controlled by the thickness of the epitaxial layer and the diameter of the Schottky contact. R_j is the junction resistance of the diode, a function of the total current flowing through it.

$$R_j = \frac{8.33 \times 10^5 n T}{I_s + I_b} = R_V - R_s$$

$$= \frac{0.026}{I_s + I_b} \text{ at } 25^\circ\text{C}$$

where

- n = ideality factor (see table of SPICE parameters)
- T = temperature in $^\circ\text{K}$
- I_s = saturation current (see table of SPICE parameters)
- I_b = externally applied bias current in amps
- R_V = sum of junction and series resistance, the slope of the V-I curve

I_s is a function of diode barrier height, and can range from picamps for high barrier diodes to as much as 5 μA for very low barrier diodes.

The Height of the Schottky Barrier

The current-voltage characteristic of a Schottky barrier diode at room temperature is described by the following equation:

$$I = I_s (e^{V - IR_s} - 1)$$

On a semi-log plot (as shown in the Agilent catalog) the current graph will be a straight line with inverse slope $2.3 \times 0.026 = 0.060$ volts per cycle (until the effect of

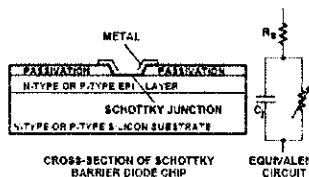


Figure 10. Schottky Diode Chip.

R_s is seen in a curve that droops at high current). All Schottky diode curves have the same slope, but not necessarily the same value of current for a given voltage. This is determined by the saturation current, I_S , and is related to the barrier height of the diode.

Through the choice of p-type or n-type silicon, and the selection of metal, one can tailor the characteristics of a Schottky diode. Barrier height will be altered, and at the same time C_J and R_s will be changed. In general, very low barrier height diodes (with high values of I_S , suitable for zero bias applications) are realized on p-type silicon. Such diodes suffer from higher values of R_s than do the n-type. Thus, p-type diodes are generally reserved for detector applications (where very high values of R_V swamp out high R_s) and n-type diodes, such as the HSMS-282x are used for mixer applications (where high L.O. drive levels keep R_V low). DC biased detectors and self-biased detectors used in gain or power control circuits.

Detector Applications

Detector circuits can be divided into two types, large signal ($P_{in} > -20$ dBm) and small signal ($P_{in} < -20$ dBm). In general, the former use resistive impedance matching at the input to improve flatness over frequency—this is possible since the input signal levels are high enough to produce adequate output voltages without the need for a high Q reactive input matching network. These circuits are self-biased (no external DC bias) and are used for gain and power control of amplifiers.

Small signal detectors are used as very low cost receivers, and require a reactive input impedance matching network to achieve adequate sensitivity and output voltage. Those operating with zero bias utilize the HSMS-283x family of detector diodes. However, superior performance over temperature can be achieved with the use of 3 to 30 μA of DC bias. Such circuits will use the HSMS-282x family of diodes if the operating frequency is 1.5 GHz or lower.

Typical performance of single diode detectors (using HSMS-2820 or HSMS-282B) can be seen in the transfer curves given in Figures 7 and 8. Such detectors can be realized either as series or shunt circuits, as shown in Figure 11.

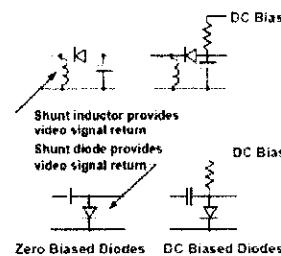


Figure 11. Single Diode Detectors.

The series and shunt circuits can be combined into a voltage doubler^[1], as shown in Figure 12. The doubler offers three advantages over the single diode circuit.

- ✓ The two diodes are in parallel in the RF circuit, lowering the input impedance and making the design of the RF matching network easier.
- ✓ The two diodes are in series in the output (video) circuit, doubling the output voltage.
- ✓ Some cancellation of even-order harmonics takes place at the input.

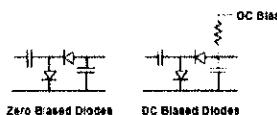


Figure 12. Voltage Doubler.

The most compact and lowest cost form of the doubler is achieved when the HSMS-2822 or HSMS-282C series pair is used.

Both the detection sensitivity and the DC forward voltage of a biased Schottky detector are temperature sensitive. Where both must be compensated over a wide range of temperatures, the differential detector^[2] is often used. Such a circuit requires that the detector diode and the reference diode exhibit identical characteristics at all DC bias levels and at all temperatures. This is accomplished through the use of two diodes in one package, for example the HSMS-2825 in Figure 13. In the Agilent assembly facility, the two dice in a surface mount package are taken from adjacent sites on the wafer (as illustrated in Figure 14). This

[1] Agilent Application Note 956-1, "Schottky Diode Voltage Doubler."

[2] Raymond W. Waugh, "Designing Large-Signal Detectors for Handsets and Base Stations," *Wireless Systems Design*, Vol. 2, No. 7, July 1997, pp. 42–48.

assures that the characteristics of the two diodes are more highly matched than would be possible through individual testing and hand matching.

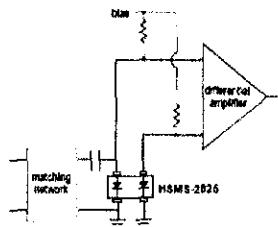


Figure 13. Differential Detector.

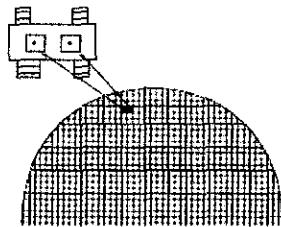


Figure 14. Fabrication of Agilent Diode Pairs.

In high power applications, coupling of RF energy from the detector diode to the reference diode can introduce error in the differential detector. The HSMS-282K diode pair, in the six lead SOT-363 package, has a copper bar between the diodes that adds 10 dB of additional isolation between them. As this part is manufactured in the SOT-363 package it also provides the benefit of being 40% smaller than larger SOT-143 devices. The HSMS-282K is illustrated in Figure 15—note that the ground connections must be made as close to the package as possible to minimize stray inductance to ground.

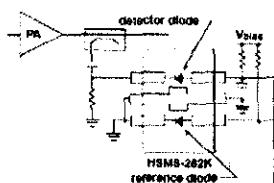


Figure 15. High Power Differential Detector.

The concept of the voltage doubler can be applied to the differential detector, permitting twice the output voltage for a given input power (as well as improving input impedance and suppressing second harmonics).

However, care must be taken to assure that the two reference diodes closely match the two detector diodes. One possible configuration is given in Figure 16, using two HSMS-2825. Board space can be saved through the use of the HSMS-282P open bridge quad, as shown in Figure 17.

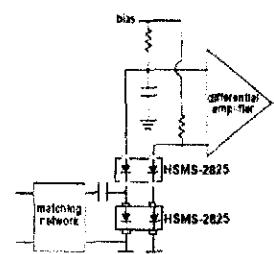


Figure 16. Voltage Doubler Differential Detector.

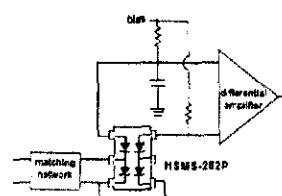


Figure 17. Voltage Doubler Differential Detector.

While the differential detector works well over temperature, another design approach^[3] works well for large signal detectors. See Figure 18 for the schematic and a physical layout of the circuit. In this design, the two 4.7 kΩ resistors and diode D2 act as a variable power divider, assuring constant output voltage over temperature and improving output linearity.

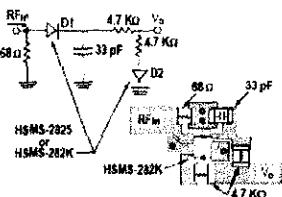


Figure 18. Temperature Compensated Detector.

In certain applications, such as a dual-band cellphone handset operating at both 900 and 1800 MHz, the second harmonics generated in the power control output detector when the handset is working at 900 MHz can cause problems. A filter at the output can reduce unwanted emissions at 1800 MHz in this case, but a

^[3] Hans Eriksson and Raymond W. Waugh, "A Temperature Compensated Linear Diode Detector," to be published.

lower cost solution is available⁴. Illustrated schematically in Figure 19, this circuit uses diode D2 and its associated passive components to cancel all even order harmonics at the detector's RF input. Diodes D3 and D4 provide temperature compensation as described above. All four diodes are contained in a single HSMS-282R package, as illustrated in the layout shown in Figure 20.

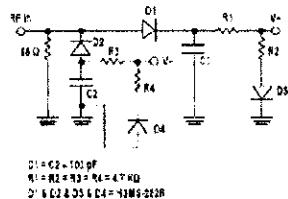


Figure 19. Schematic of Suppressed Harmonic Detector.

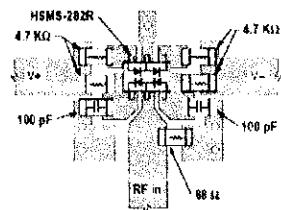


Figure 20. Layout of Suppressed Harmonic Detector.

Note that the foregoing discussion refers to the output voltage being extracted at point V_+ with respect to ground. If a differential output is taken at V_+ with respect to V_- , the circuit acts as a voltage doubler.

Mixer applications

The HSMS-282x family, with its wide variety of packaging, can be used to make excellent mixers at frequencies up to 6 GHz.

The HSMS-2827 ring quad of matched diodes (in the SOT-143 package) has been designed for double balanced mixers. The smaller (SOT-363) HSMS-282R ring quad can similarly be used, if the quad is closed with external connections as shown in Figure 21.

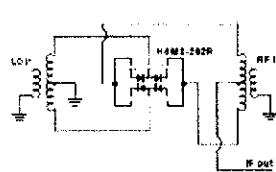


Figure 21. Double Balanced Mixer.

Both of these networks require a crossover or a three dimensional circuit. A planar mixer can be made using the SOT-143 crossover quad, HSMS-2829, as shown in Figure 22. In this product, a special lead frame permits the crossover to be placed inside the plastic package itself, eliminating the need for via holes (or other measures) in the RF portion of the circuit itself.

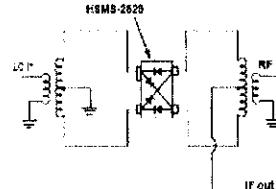


Figure 22. Planar Double Balanced Mixer.

A review of Figure 21 may lead to the question as to why the HSMS-282R ring quad is open on the ends. Distortion in double balanced mixers can be reduced if LO drive is increased, up to the point where the Schottky diodes are driven into saturation. Above this point, increased LO drive will not result in improvements in distortion. The use of expensive high barrier diodes (such as those fabricated on GaAs) can take advantage of higher LO drive power, but a lower cost solution is to use a eight (or twelve) diode ring quad. The open design of the HSMS-282R permits this to easily be done, as shown in Figure 23.

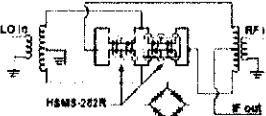


Figure 23. Low Distortion Double Balanced Mixer.

This same technique can be used in the single-balanced mixer. Figure 24 shows such a mixer, with two diodes in each spot normally occupied by one. This mixer, with a sufficiently high LO drive level, will display low distortion.

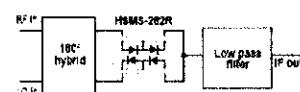


Figure 24. Low Distortion Balanced Mixer.

⁴ Alan Nixon and Raymond W. Waugh, "A Suppressed Harmonic Power Detector for Dual Band Phones," to be published.

Sampling Applications

The six lead HSMS-282P can be used in a sampling circuit, as shown in Figure 25. As was the case with the six lead HSMS-282R in the mixer, the open bridge quad is closed with traces on the circuit board. The quad was not closed internally so that it could be used in other applications, such as illustrated in Figure 17.

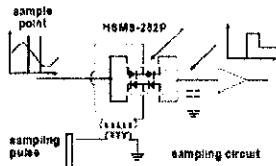


Figure 25. Sampling Circuit.

Thermal Considerations

The obvious advantage of the SOT-323 and SOT-363 over the SOT-23 and SOT-142 is combination of smaller size and extra leads. However, the copper leadframe in the SOT-3x3 has a thermal conductivity four times higher than the Alloy 42 leadframe of the SOT-23 and SOT-143, which enables the smaller packages to dissipate more power.

The maximum junction temperature for these three families of Schottky diodes is 150°C under all operating conditions. The following equation applies to the thermal analysis of diodes:

$$T_j = (V_f I_f + P_{RF}) \theta_{jc} + T_a \quad (1)$$

where

- T_j = junction temperature
- T_a = diode case temperature
- θ_{jc} = thermal resistance
- $V_f I_f$ = DC power dissipated
- P_{RF} = RF power dissipated

Note that θ_{jc} , the thermal resistance from diode junction to the foot of the leads, is the sum of two component resistances,

$$\theta_{jc} = \theta_{pk} + \theta_{chip} \quad (2)$$

Package thermal resistance for the SOT-3x3 package is approximately 100°C/W, and the chip thermal resistance for the HSMS-282x family of diodes is approximately 40°C/W. The designer will have to add in the thermal resistance from diode case to ambient—a poor choice of circuit board material or heat sink design can make this number very high.

Equation (1) would be straightforward to solve but for the fact that diode forward voltage is a function of temperature as well as forward current. The equation for V_f is:

$$I_f = I_S \left[e^{\frac{11600(V_f - I_f R_s)}{nT}} - 1 \right] \quad (3)$$

where n = ideality factor
 T = temperature in °K
 R_s = diode series resistance

and I_S (diode saturation current) is given by

$$I_S = I_0 \left(\frac{T}{298} \right)^{\frac{2}{n}} e^{-\frac{4060}{T} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298} \right)} \quad (4)$$

Equation (4) is substituted into equation (3), and equations (1) and (3) are solved simultaneously to obtain the value of junction temperature for given values of diode case temperature, DC power dissipation and RF power dissipation.

Diode Burnout

Any Schottky junction, be it an RF diode or the gate of a MESFET, is relatively delicate and can be burned out with excessive RF power. Many crystal video receivers used in RFID (tag) applications find themselves in poorly controlled environments where high power sources may be present. Examples are the areas around airport and FAA radars, nearby ham radio operators, the vicinity of a broadcast band transmitter, etc. In such environments, the Schottky diodes of the receiver can be protected by a device known as a limiter diode.¹³ Formerly available only in radar warning receivers and other high cost electronic warfare applications, these diodes have been adapted to commercial and consumer circuits.

Agilent offers a complete line of surface mountable PIN limiter diodes. Most notably, our HSMP-4820 (SOT-23) can act as a very fast (nanosecond) power-sensitive switch when placed between the antenna and the Schottky diode, shorting out the RF circuit temporarily and reflecting the excessive RF energy back out the antenna.

¹³ Agilent Application Note 1050, "Low Cost, Surface Mount Power Limiters."

Assembly Instructions

SOT-3x3 PCB Footprint

Recommended PCB pad layouts for the miniature SOT-3x3 (SC-70) packages are shown in Figures 26 and 27 (dimensions are in inches). These layouts provide ample allowance for package placement by automated assembly equipment without adding parasitics that could impair the performance.

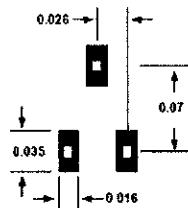


Figure 26. PCB Pad Layout, SOT-3x3 (dimensions in inches)

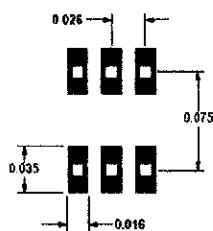


Figure 27. PCB Pad Layout, SOT-363 (dimensions in inches).

SMT Assembly

Reliable assembly of surface mount components is a complex process that involves many material, process, and equipment factors, including: method of heating (e.g., IR or vapor phase reflow, wave soldering, etc.) circuit board material, conductor thickness and pattern, type of solder alloy, and the thermal conductivity and thermal mass of components. Components with a low mass, such as the SOT packages, will reach solder reflow temperatures faster than those with a greater mass.

Agilent's diodes have been qualified to the time-temperature profile shown in Figure 28. This profile is representative of an IR reflow type of surface mount assembly process.

After ramping up from room temperature, the circuit board with components attached to it (held in place with solder paste)

passes through one or more preheat zones. The preheat zones increase the temperature of the board and components to prevent thermal shock and begin evaporating solvents from the solder paste. The reflow zone briefly elevates the temperature sufficiently to produce a reflow of the solder.

The rates of change of temperature for the ramp-up and cool-down zones are chosen to be low enough to not cause deformation of the board or damage to components due to thermal shock. The maximum temperature in the reflow zone (T_{MAX}) should not exceed 235°C.

These parameters are typical for a surface mount assembly process for Agilent diodes. As a general guideline, the circuit board and components should be exposed only to the minimum temperatures and times necessary to achieve a uniform reflow of solder.

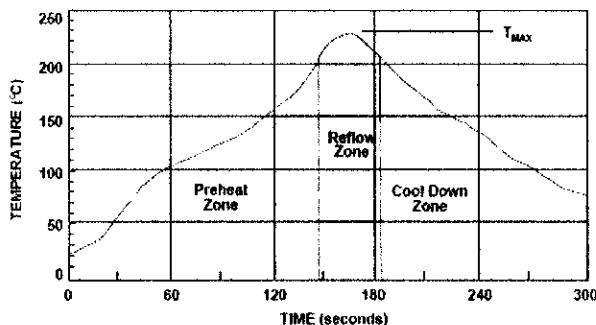


Figure 28. Surface Mount Assembly Profile.

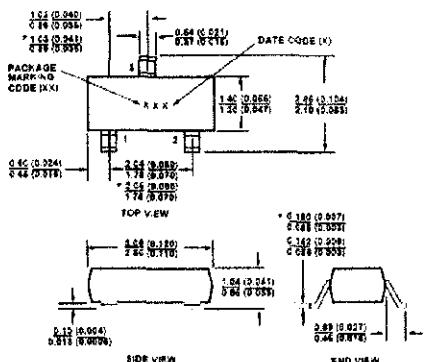
Part Number Ordering Information

Part Number	No. of Devices	Container
HSMS-282x-TR2 ^x	10000	13" Reel
HSMS-282x-TR1 ^x	3000	7" Reel
HSMS-282x-BLK ^x	100	antistatic bag

x = 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, B, C, E, F, K, L, M, N, P or R

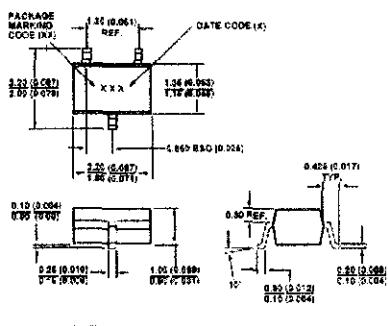
Package Dimensions

Outline 23 (SOT-23)



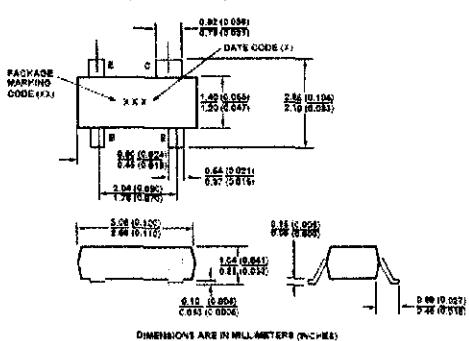
* THESE DIMENSIONS FOR HSMS-282X AND -281X PARTS ONLY.
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES)

Outline SOT-323 (SC-70 3 Lead)



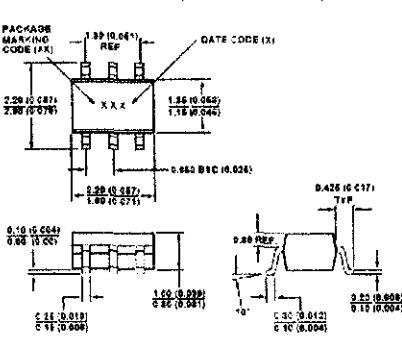
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES)

Outline 143 (SOT-143)



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES)

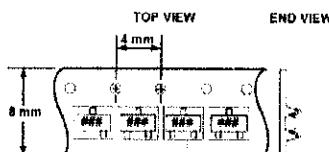
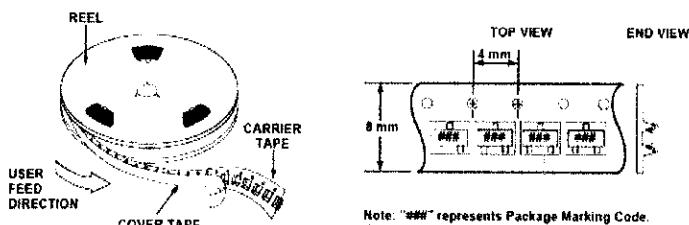
Outline SOT-363 (SC-70 6 Lead)



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES)

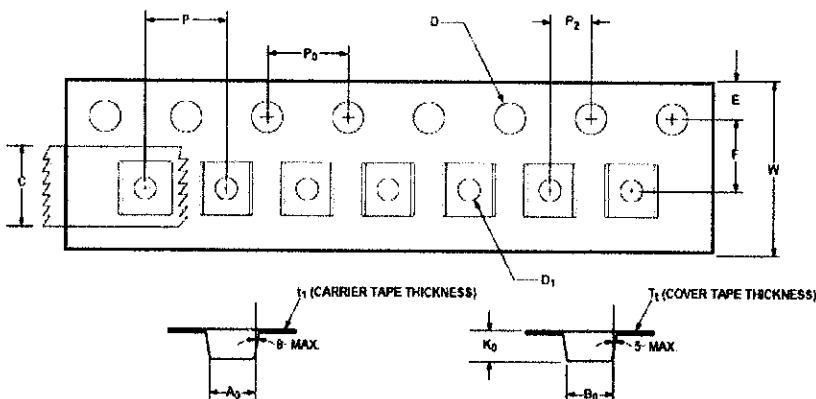


Device Orientation



Note: "####" represents Package Marking Code.
Package marking is right side up with carrier tape perforations at top. Conforms to Electronic Industries RS-481, "Taping of Surface Mounted Components for Automated Placement". Standard quantity is 3,000 devices per reel.

Tape Dimensions and Product Orientation For Outline SOT-323 (SC-70 3 Lead)

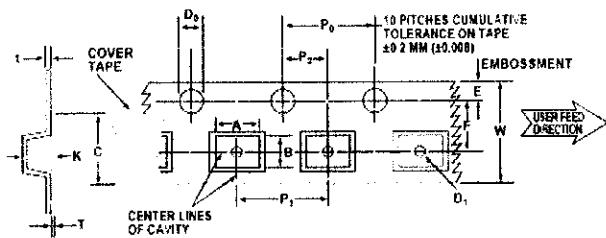


DESCRIPTION	SYMBOL	SIZE (mm)	SIZE (INCHES)
CAVITY	A ₀	2.24 ± 0.10	0.088 ± 0.004
	B ₀	2.34 ± 0.10	0.092 ± 0.004
	K ₀	1.22 ± 0.10	0.048 ± 0.004
	P	4.00 ± 0.10	0.157 ± 0.004
	D ₁	1.00 ± 0.25	0.039 ± 0.010
PERFORATION	D	1.55 ± 0.05	0.061 ± 0.002
	P ₀	4.00 ± 0.10	0.157 ± 0.004
	E	1.75 ± 0.10	0.069 ± 0.004
CARRIER TAPE	W	8.00 ± 0.30	0.315 ± 0.012
	t _c	0.255 ± 0.013	0.010 ± 0.0005
COVER TAPE	C	5.4 ± 0.10	0.209 ± 0.004
	t _r	0.062 ± 0.001	0.0025 ± 0.00004
DISTANCE	F	3.50 ± 0.05	0.138 ± 0.002
	P ₂	2.00 ± 0.05	0.079 ± 0.002

www.semiconductor.agilent.com

Data subject to change.
Copyright © 2000 Agilent Technologies
Obsoletes 5068-2960E, 5068-5034E
5068-5014E (1/00)

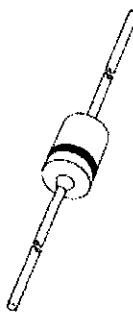
**Tape Dimensions and Product Orientation
For Outline SOT-23**



DESCRIPTION		SYMBOL	SIZE (mm)	SIZE (INCHES)
CAVITY	LENGTH	A	3.15 ± 0.15	0.124 ± 0.006
	WIDTH	B	2.65 ± 0.25	0.104 ± 0.010
	DEPTH	K	1.30 ± 0.10	0.051 ± 0.004
	PITCH	P ₁	4.00 ± 0.10	0.157 ± 0.004
	BOTTOM HOLE DIAMETER	D ₁	1.00 mm	0.04 min.
PERFORATION	DIAMETER	D ₀	1.55 ± 0.10/-0	0.061 ± 0.004/-0
	PITCH	P ₀	4.00 ± 0.10	0.157 ± 0.004
	POSITION	E	1.75 ± 0.10	0.069 ± 0.004
CARRIER TAPE	WIDTH	W	8.00 ± 0.2	0.315 ± 0.008
	THICKNESS	t	0.30 ± 0.05	0.012 ± 0.002
COVER TAPE	WIDTH	C	5.40 ± 0.25	0.205 ± 0.010
	TAPE THICKNESS	T	0.064 ± 0.01	0.003 ± 0.004
DISTANCE BETWEEN CENTERLINE	CAVITY TO PERFORATION (WIDTH DIRECTION)	F	3.50 ± 0.10	0.138 ± 0.004
	CAVITY TO PERFORATION (LENGTH DIRECTION)	P ₂	2.00 ± 0.05	0.079 ± 0.002

DISCRETE SEMICONDUCTORS

DATA SHEET



1N4148; 1N4448 High-speed diodes

Product specification
Supersedes data of 1996 Sep 03

1999 May 25

Philips
Semiconductors



PHILIPS

Philips Semiconductors

Product specification

High-speed diodes**1N4148; 1N4448****FEATURES**

- Hermetically sealed leaded glass SOD27 (DO-35) package
- High switching speed: max. 4 ns
- General application
- Continuous reverse voltage: max. 75 V
- Repetitive peak reverse voltage: max. 75 V
- Repetitive peak forward current: max. 450 mA.

DESCRIPTION

The 1N4148 and 1N4448 are high-speed switching diodes fabricated in planar technology, and encapsulated in hermetically sealed leaded glass SOD27 (DO-35) packages.

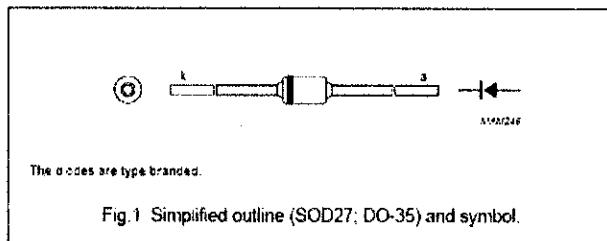


Fig.1 Simplified outline (SOD27; DO-35) and symbol.

APPLICATIONS

- High-speed switching.

LIMITING VALUES

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{RRM}	repetitive peak reverse voltage		—	75	V
V_R	continuous reverse voltage		—	75	V
I_F	continuous forward current	see Fig.2; note 1	—	200	mA
I_{FRM}	repetitive peak forward current		—	450	mA
I_{FSM}	non-repetitive peak forward current	square wave; $T = 25^\circ\text{C}$ prior to surge; see Fig.4 $t = 1 \mu\text{s}$ $t = 1 \text{ ms}$ $t = 1 \text{ s}$	—	4 1 0.5	A
P_{tot}	total power dissipation	$T_{amb} = 25^\circ\text{C}$; note 1	—	500	mW
T_{stg}	storage temperature		-65	+200	°C
T_j	junction temperature		—	200	°C

Note

1. Device mounted on an FR4 printed circuit-board; lead length 10 mm.

Philips Semiconductors

Product specification

High-speed diodes**1N4148; 1N4448****ELECTRICAL CHARACTERISTICS** $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_F	forward voltage IN4148	see Fig.3 $I_F = 10 \text{ mA}$	-	1	V
	IN4448	$I_F = 5 \text{ mA}$	0.62	0.72	V
		$I_F = 100 \text{ mA}$	-	1	V
I_R	reverse current	$V_R = 20 \text{ V}$; see Fig.5	25	nA	
		$V_R = 20 \text{ V}; T_j = 150^\circ\text{C}$; see Fig.5	-	50	μA
I_Q	reverse current; 1N4448	$V_R = 20 \text{ V}; T_j = 100^\circ\text{C}$; see Fig.5	-	3	μA
C_d	diode capacitance	$f = 1 \text{ MHz}; V_R = 0$; see Fig.6	-	4	pF
t_{rr}	reverse recovery time	when switched from $I_F = 10 \text{ mA}$ to $I_Q = 60 \text{ mA}; R_L = 100 \text{ Ω}$ measured at $I_R = 1 \text{ mA}$; see Fig.7	-	4	ns
V_{fr}	forward recovery voltage	when switched from $I_F = 50 \text{ mA}$; $t_r = 20 \text{ ns}$; see Fig.8	-	2.5	V

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	VALUE	UNIT
$R_{th,j-p}$	thermal resistance from junction to tie-point	lead length 10 mm	240	K/W
$R_{th,j-a}$	thermal resistance from junction to ambient	lead length 10 mm; note 1	350	K/W

Note

1. Device mounted on a printed circuit-board without metallization pad.

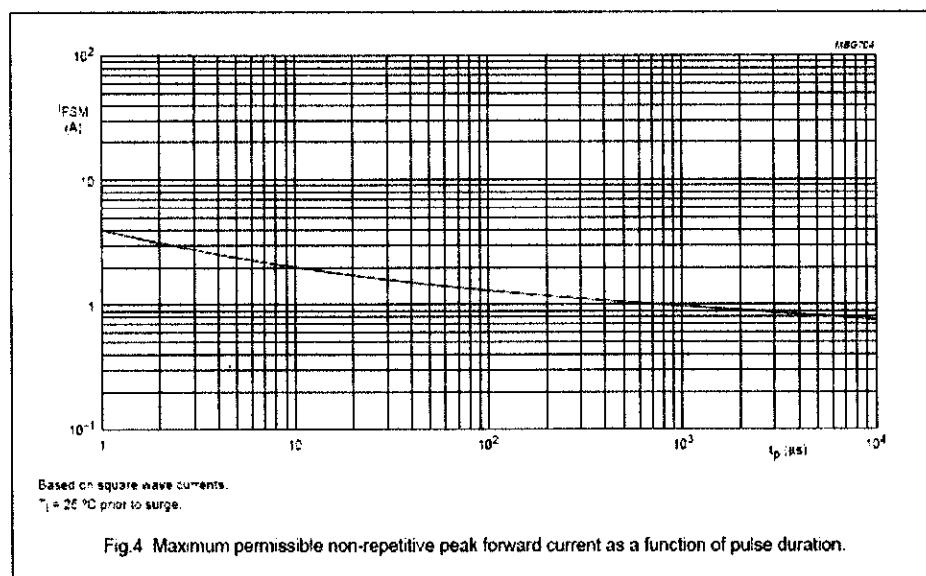
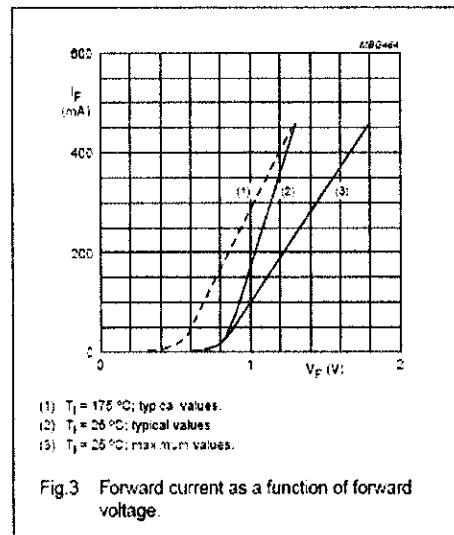
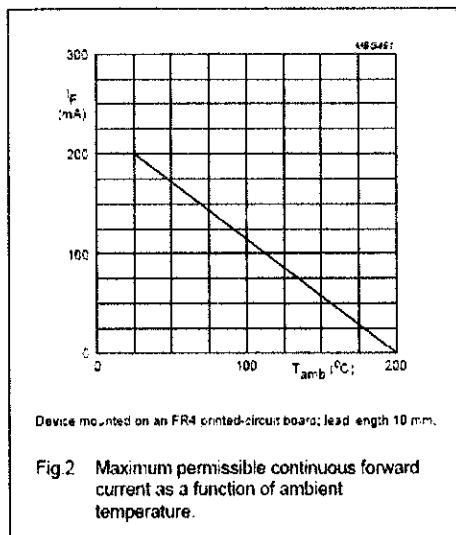
Philips Semiconductors

Product specification

High-speed diodes

1N4148; 1N4448

GRAPHICAL DATA



Philips Semiconductors

Product specification

High-speed diodes

1N4148; 1N4448

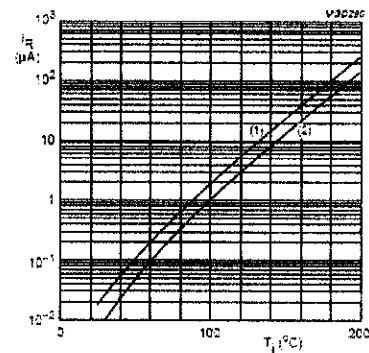


Fig.5 Reverse current as a function of junction temperature.

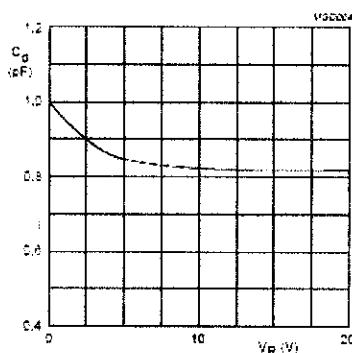


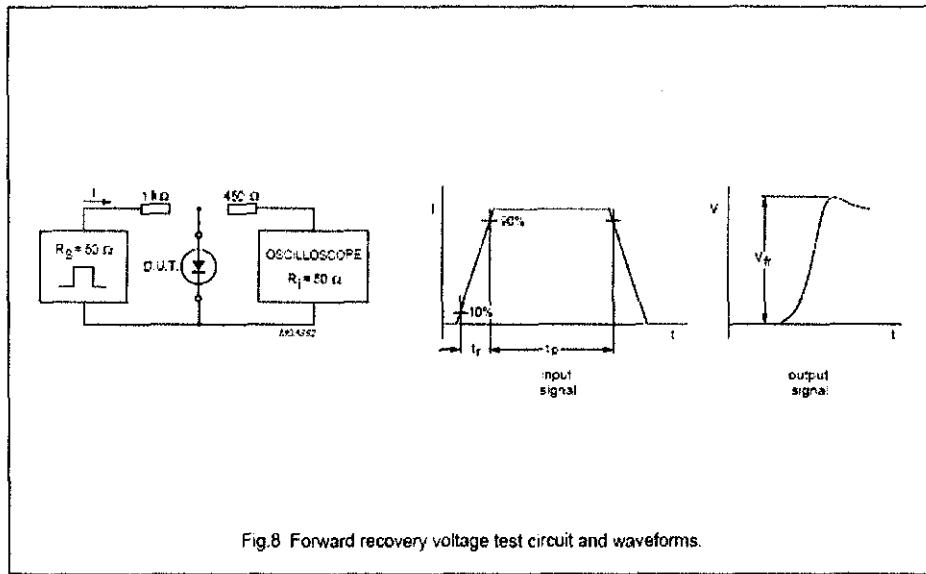
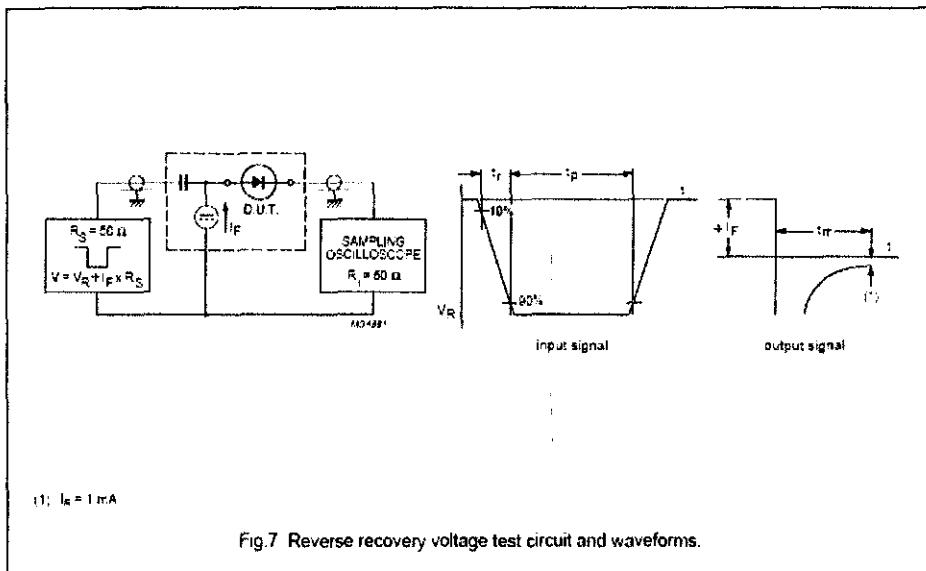
Fig.6 Diode capacitance as a function of reverse voltage; typical values.

Philips Semiconductors

Product specification

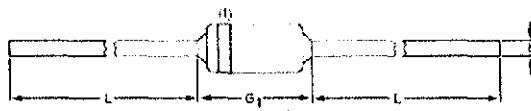
High-speed diodes

1N4148; 1N4448



Philips Semiconductors

Product specification

High-speed diodes**1N4148; 1N4448****PACKAGE OUTLINE****Hermetically sealed glass package; axial leaded; 2 leads****SOD27****DIMENSIONS (mm are the original dimensions)**

UNIT	b max.	D max.	G ₁ max.	L min.
mm	0.56	1.85	4.25	25.4

Note

1. The marking band indicates the cathode.

OUTLINE VERSION	REFERENCES			EUROPEAN PROJECTION	ISSUE DATE
	IEC	JEDEC	EIAJ		
SOD27	A24	DO-35	SC-40		97-08-09

DEFINITIONS

Data Sheet Status	
Objective specification	This data sheet contains target or goal specifications for product development.
Preliminary specification	This data sheet contains preliminary data; supplementary data may be published later.
Product specification	This data sheet contains final product specifications.
Limiting values	
Limiting values given are in accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). Stress above one or more of the limiting values may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and operation of the device at these or at any other conditions above those given in the Characteristics sections of the specification is not implied. Exposure to limiting values for extended periods may affect device reliability.	
Application information	
Where application information is given, it is advisory and does not form part of the specification.	

LIFE SUPPORT APPLICATIONS

These products are not designed for use in life support appliances, devices, or systems where malfunction of these products can reasonably be expected to result in personal injury. Philips customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Philips for any damages resulting from such improper use or sale.

Philips Semiconductors – a worldwide company

Argentina: see South America

Australia: 34 Waterloo Road, NORTH RYDE, NSW 2113
Tel. +61 2 8806 4456, Fax. +61 2 2605 4466

Austria: Computerstr. 8, A-1101 WEN, P.O. Box 213.
Tel. +43 1 82 101 1248, Fax. +43 1 82 101 1210

Belarus: Hotel Minsk Business Center, Bld. 3, r. 1211, Volodarski Str. 6,
220050 MINSK. Tel. +375 172 20 2732, Fax. +375 172 20 0775

Belgium: see The Netherlands

Brazil: see South America

Bulgaria: Philips Bulgaria Ltd., Energoproject, 15th Floor,
51 James Bourchier Blvd., 1407 SOFIA
Tel. +359 2 25 9211, Fax. +359 2 25 9102

Canada: PHILIPS SEMICONDUCTORS/COMPONENTS,
Tel. +1 800 234 7331, Fax. +1 800 043 0057

China/Hong Kong: 601 Hong Kong Industrial Technology Centre,
72 Tai Chee Avenue, Kowloon Tong, HONG KONG.
Tel. +852 2312 7888 Fax. +852 2319 7700

Colombia: see South America

Czech Republic: see Austria

Denmark: Sychausvægade 23, 1750 COPENHAGEN V.
Tel. +45 33 29 3333, Fax. +45 33 29 3000

Finland: Siivakatu 3, FIN-02630 ESPCO,
Tel. +358 0 16 800, Fax. +358 0 168 0020

France: 61 Rue Carnot, BP317, 92190 SURESNES Cedex.
Tel. +33 1 4299 8121, Fax. +33 1 4308 6437

Germany: Hammerbrookstrasse 62, D-20297 HAMBURG.

Tel. +49 40 2383 00, Fax. +49 40 2363 8200

Hungary: see Austria

India: Philips INDIA Ltd., Band Box Building, 2nd Floor,
254-D, Dr. Annai Besant Road, Worli, MUMBAI 400 026.
Tel. +91 22 493 8241, Fax. +91 22 493 0260

Indonesia: PT Philips Development Corporation, Semiconductors Division
Gedung Philips, Jl. Buncit Raya Kav. 22-108, JAKARTA 12510
Tel. +62 21 794 0040 ext. 2501, Fax. +62 21 794 0085

Ireland: Newstead, Clonskeagh DUBLIN 14.

Tel. +353 1 7640 020, Fax. +353 1 7640 200

Israel: RAPAC Electron cs 7 Kehilat Salomoni St, P.O. Box 18053,
TE. AVIV 11102, Tel. +972 3 645 2444, Fax. +972 3 540 1007

Italy: PHILIPS SEMICONDUCTORS, Piazza IV Novembre 3,
20124 MILANO. Tel. +39 02 67 52 2531, Fax. +39 02 67 52 2557

Japan: Philips Bldg 13-37, Kohoku 2-chome, Minato-ku

TOKYO 108-6507, Tel. +81 3 3740 5130, Fax. +81 3 3740 6057

Korea: Philips, 260-109 Iaewon-dong Yongsan-ku, SEOUL

Tel. +82 2 708 1412, Fax. +82 2 708 1415

Malaysia: No. 76 Jalan Universiti, 4200 PETALING JAYA, SELANGOR.

Tel. +60 3 755 5214, Fax. +60 3 757 4882

Mexico: 6000 Gateway East, Suite 200, EL PASO, TEXAS 79905.

Tel. +915 500 234 7251, Fax. +915 500 043 0087

Middle East: see Italy

Netherlands: Postbus 20050, 2130 PB EINDHOVEN, Bldg. VB

Tel. +31 40 27 82756, Fax. +31 40 27 83362

New Zealand: 2 Wagener Place, C.P.O. Box 1041, AUCKLAND.

Tel. +64 9 649 4120, Fax. +64 9 649 7311

Norway: Box 1, Manglerud 0212 OSLO.

Tel. +47 22 74 8020, Fax. +47 22 74 8341

Pakistan: see Singapore

Philippines: Philips Semiconductors Philippines Inc.

100 Valero St., Salcedo Village, P.C. Box 2105 MCC, MAKATI,

Metro MANILA, Tel. +63 2 516 6250, Fax. +63 2 817 3474

Poland: Ul. Lukasza 10, PL 04-123 WARSZAWA

Tel. +48 22 612 2351, Fax. +48 22 612 2327

Portugal: see Spain

Romania: see Italy

Russia: Philips Russia, ul. Usatcheva 36a, 119046 MOSCOW

Tel. +7 095 755 6018, Fax. +7 095 755 6019

Singapore: Lorong 1, Toa Payoh, SINGAPORE 319762

Tel. +65 360 2539 Fax. +65 261 6500

Slovakia: see Austria

Slovenia: see Italy

South Africa: S.A. PHILIPS Pty Ltd, 165-215 Main Road Martindale,

2092 JOHANNESBURG, P.O. Box 58058 Newville 2114.

Tel. +27 11 471 5401 Fax. +27 11 471 5398

South America: Av. Vicente Pinzon, 173, 6th floor

24547-123 SAO PAULO, SP, Brazil.

Tel. +55 11 821 2333 Fax. +55 11 821 2382

Spain: Balmer 22, 08007 BARCELONA.

Tel. +34 93 301 6312 Fax. +34 93 321 4107

Sweden: Kungsgatan 7, Alkalla, S-16485 STOCKHOLM.

Tel. +46 8 5995 2100, Fax. +46 8 5995 2745

Switzerland: Alimentstrasse 140, CH-8027 ZURICH

Tel. +41 1 482 2741 Fax. +41 1 485 3263

Taiwan: Philips Semiconductors, 6F, no. 26, Chien Kuo N. Rd., Sec. 1,

TAIPEI, Taiwan Tel. +886 2 2124 2886, Fax. +886 2 2124 2674

Thailand: PHILIPS ELECTRONICS (THAILAND) Ltd.

209/2 Sanpanich-Sangna Road Prakanong, BANGKOK 10260.

Tel. +66 2 742 4020 Fax. +66 2 388 0793

Turkey: Yukarı Cudu u, Org. San. B.g., 2 Cad. Nr. 25 51262 Umraniye,

ISTANBUL, Tel. +90 2 622 1600, Fax. +90 2 622 1513

Ukraine: PHILIPS UKRAINE, 4 Farfot Lumumba str, Building B, Floor 7,

262042 K.EV., Tel. +380 44 264 2770, Fax. +380 44 268 0421

United Kingdom: Philips Semiconductors Ltd, 278 Bath Road, Hayes

MIDDLESEX UB9 6BX, Tel. +44 181 730 5000, Fax. +44 181 754 2421

United States: 811 East Arques Avenue, SUNNYVALE, CA 94085-3400.

Tel. +1 800 234 7381 Fax. +1 800 645 0087

Uruguay: see South America

Vietnam: see Singapore

Yugoslavia: PHILIPS, Trg N. Pasica 5/V, 11000 BEOGRAD.

Tel. +381 11 62 6344 Fax. +381 11 62 6777

For all other countries apply to: Philips Semiconductors,
International Marketing & Sales Communications, Building BE-p, P.O. Box 218,
5600 MD EINDHOVEN, The Netherlands. Fax. +31 40 27 24825

© Philips Electronics N.V. 1992

All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual property rights.

Printed in The Netherlands

1162023ppc

Date of release: 1993 May 18

Document order number: 9307 760 0892

Internet: <http://www.semiconductors.philips.com>

SCA85

Philips
Semiconductors



PHILIPS

LM2904, LM358/LM358A, LM258/ LM258A

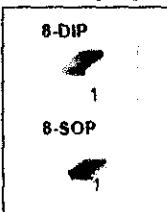
Dual Operational Amplifier

Features

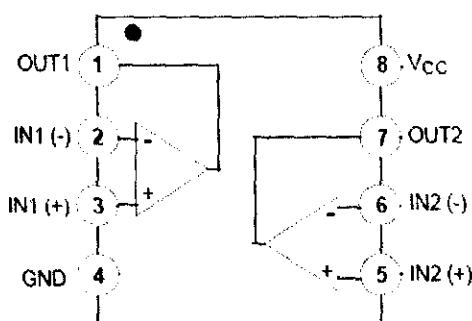
- Internally Frequency Compensated for Unity Gain
- Large DC Voltage Gain: 100dB
- Wide Power Supply Range:
LM258 LM258A: LM358/LM358A: 3V~32V (or $\pm 1.5V$ ~ 16V)
LM2904 : 3V~26V (or $\pm 1.5V$ ~ 13V)
- Input Common Mode Voltage Range Includes Ground
- Large Output Voltage Swing: 0V DC to Vcc -1.5V DC
- Power Drain Suitable for Battery Operation

Description

The LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A consist of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltage. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifier, DC gain blocks and all the conventional OP-AMP circuits which now can be easily implemented in single power supply systems.



Internal Block Diagram

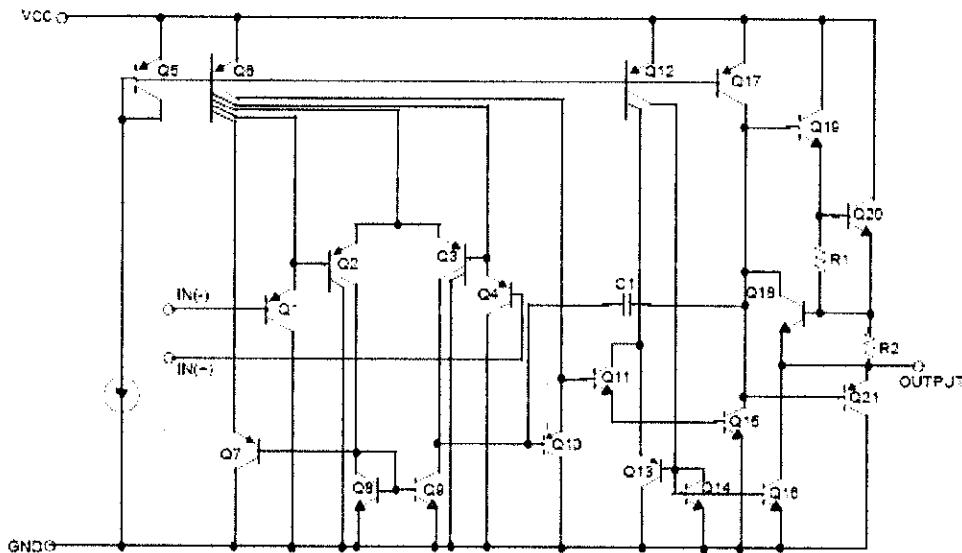


Rev. 1.0.2

LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Schematic Diagram

(One section only)

**Absolute Maximum Ratings**

Parameter	Symbol	LM258/LM258A	LM358/LM358A	LM2904	Unit
Supply Voltage	V _{CC}	±16 or 32	±16 or 32	±13 or 26	V
Differential Input Voltage	V _{IN(DIFF)}	32	32	26	V
Input Voltage	V _I	-0.3 to +32	-0.3 to +32	-0.3 to +26	V
Output Short Circuit to GND V _{CC} ≤15V, T _A = 25°C(One Amp)	-	Continuous	Continuous	Continuous	-
Operating Temperature Range	T _{OPR}	-25 ~ +85	0 ~ +70	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-65 ~ +150	-65 ~ +150	-65 ~ +150	°C

LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Electrical Characteristics(V_{CC} = 5.0V, V_{EE} = GND, T_A = 25°C, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	LM258			LM358			LM2904			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V _{IO}	V _{CM} = 0V to V _{CC} -1.5V V _{O(P)} = 1.4V, R _S = 0Ω	-	2.9	5.0	-	2.9	7.0	-	2.9	7.0	mV
Input Offset Current	I _{IO}	-	-	3	30	-	5	50	-	5	50	nA
Input Bias Current	I _{BIAS}	-	-	45	150	-	45	250	-	45	250	nA
Input Voltage Range	V _{I(R)}	V _{CC} = 30V (LM2904, V _{CC} =26V)	0	-	V _{CC} -1.5	0	-	V _{CC} -1.5	0	-	V _{CC} -1.5	V
Supply Current	I _{CC}	R _L = ∞, V _{CC} = 30V (LM2904, V _{CC} =26V)	-	0.8	2.0	-	0.8	2.0	-	0.8	2.0	mA
		R _L = ∞, V _{CC} = 5V	-	0.5	1.2	-	0.5	1.2	-	0.5	1.2	mA
Large Signal Voltage Gain	G _V	V _{CC} = 15V, R _L =2kΩ V _{O(P)} = 1V to 11V	50	100	-	25	100	-	25	100	-	V/mV
Output Voltage Swing	V _{O(H)}	V _{CC} =30V (V _{CC} =26V for LM2904)	26	-	-	26	-	-	22	-	-	V
		R _L = 10kΩ	27	28	-	27	28	-	23	24	-	V
	V _{O(L)}	V _{CC} = 5V, R _L =10kΩ	-	5	20	-	5	20	-	5	20	mV
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	-	70	85	-	65	80	-	50	80	-	dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	-	65	100	-	65	100	-	50	100	-	dB
Channel Separation	CS	f = 1kHz to 20kHz (Note 1)	-	120	-	-	120	-	-	120	-	dB
Short Circuit to GND	I _{SC}	-	-	40	60	-	40	60	-	40	60	mA
Output Current	I _{SOURCE}	V _{I(+)} = 1V, V _{I(-)} = 0V V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	20	30	-	20	30	-	20	30	-	mA
	I _{SINK}	V _{I(+)} = 0V, V _{I(-)} = 1V, V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	10	15	-	10	15	-	10	15	-	mA
		V _{I(+)} = 0V, V _{I(-)} = 1V, V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 200mV	12	100	-	12	100	-	-	-	-	μA
Differential Input Voltage	V _{I(DIFF)}	-	-	V _{CC}	-	-	V _{CC}	-	-	V _{CC}	-	V

Note:

1. This parameter, although guaranteed, is not 100% tested in production.

LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Electrical Characteristics (Continued)(V_{CC} = 5.0V, V_{EE} = GND, unless otherwise specified)The following specification apply over the range of -25°C ≤ T_A ≤ +85°C for the LM258; and the 0°C ≤ T_A ≤ +70°C for the LM358; and the -40°C ≤ T_A ≤ +85°C for the LM2904

Parameter	Symbol	Conditions	LM258			LM358			LM2904			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V _{IO}	V _{CM} = 0V to V _{CC} - 1.5V V _{O(P)} = 1.4V, R _S = 0Ω	-	-	7.0	-	-	9.0	-	-	10.0	mV
Input Offset Voltage Drift	ΔV _{IO} /ΔT	R _S = 0Ω	-	7.0	-	-	7.0	-	-	7.0	-	μV/°C
Input Offset Current	I _{IO}	-	-	-	100	-	-	150	-	45	200	nA
Input Offset Current Drift	ΔI _{IO} /ΔT	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	pA/°C
Input Bias Current	I _{IBIAS}	-	-	40	300	-	40	500	-	40	500	nA
Input Voltage Range	V _{IR(R)}	V _{CC} = 30V (LM2904) V _{CC} = 26V	0	-	V _{CC} -2.0	0	-	V _{CC} -2.0	0	-	V _{CC} -2.0	V
Large Signal Voltage Gain	G _V	V _{CC} = 15V, R _L = 2.0kΩ V _{O(P)} = 1V to 11V	25	-	-	15	-	-	15	-	-	V/mV
Output Voltage Swing	V _{O(H)}	V _{CC} = 30V, R _L = 2kΩ	26	-	-	26	-	-	22	-	-	V
		R _L = 10kΩ	27	28	-	27	28	-	23	24	-	V
Output Current	I _{SOURCE}	V _{CC} = 5V, R _L = 10kΩ	-	5	20	-	5	20	-	5	20	mV
	I _{SINK}	V _{I(+)} = 0V, V _{I(-)} = 1V V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	10	30	-	10	30	-	10	30	-	mA
Differential Input Voltage	V _{I(DIFF)}	-	-	-	V _{CC}	-	-	V _{CC}	-	-	V _{CC}	V

LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Electrical Characteristics (Continued)(V_{CC} = 5.0V, V_{EE} = GND, T_A = 25°C, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	LM258A			LM358A			Unit	
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.		
Input Offset Voltage	V _{IO}	V _{CM} = 0V to V _{CC} - 1.5V V _{O(P)} = 1.4V, R _S = 0Ω	-	1.0	3.0	-	2.0	3.0	mV	
Input Offset Current	I _{IO}	-	-	2	15	-	5	30	nA	
Input Bias Current	I _{BIAS}	-	-	40	80	-	45	100	nA	
Input Voltage Range	V _{II(R)}	V _{CC} = 30V	0	-	V _{CC} - 1.5	0	-	V _{CC} - 1.5	V	
Supply Current	I _{CC}	R _L = ∞, V _{CC} = 30V	-	0.8	2.0	-	0.8	2.0	mA	
		R _L = ∞, V _{CC} = 5V	-	0.5	1.2	-	0.5	1.2	mA	
Large Signal Voltage Gain	G _V	V _{CC} = 15V, R _L = 2kΩ V _O = 1V to 11V	50	100	-	25	100	-	V/mV	
Output Voltage Swing	V _{CH}	V _{CC} = 30V	R _L = 2kΩ	26	-	-	26	-	-	V
			R _L = 10kΩ	27	28	-	27	28	-	V
	V _{O(L)}	V _{CC} = 5V, R _L = 10kΩ	-	5	20	-	5	20	mV	
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	-	70	85	-	65	85	-	dB	
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	-	65	100	-	65	100	-	dB	
Channel Separation	CS	f = 1kHz to 20kHz (Note 1)	-	120	-	-	120	-	dB	
Short Circuit to GND	I _{SC}	-	-	40	60	-	40	60	mA	
Output Current	I _{SOURCE}	V _{I(+)} = 1V, V _{I(-)} = 0V V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	20	30	-	20	30	-	mA	
	I _{SINK}	V _{I(+)} = 1V, V _{I(-)} = 0V V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	10	15	-	10	15	-	mA	
		V _{I(+)} = 0V, V _{I(-)} = 1V V _{O(P)} = 200mV	12	100	-	12	100	-	μA	
Differential Input Voltage	V _{I(DIFF)}	-	-	-	V _{CC}	-	-	V _{CC}	V	

Note:

1. This parameter, although guaranteed, is not 100% tested in production.

LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Electrical Characteristics (Continued)(V_{CC} = 5.0V, V_{EE} = GND, unless otherwise specified)The following specification apply over the range of -25°C ≤ T_A ≤ +85°C for the LM258A; and the 0°C ≤ T_A ≤ +70°C for the LM358A

Parameter	Symbol	Conditions	LM258A			LM358A			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Input Offset Voltage	V _{IO}	V _{CM} = 0V to V _{CC} - 1.5V V _{O(P)} = 1.4V, R _S = 0Ω	-	-	4.0	-	-	5.0	mV
Input Offset Voltage Drift	ΔV _{IO} /ΔT	-	-	7.0	15	-	7.0	20	μV/°C
Input Offset Current	I _{IO}	-	-	-	30	-	-	75	nA
Input Offset Current Drift	ΔI _{IO} /ΔT	-	-	10	200	-	10	300	pA/°C
Input Bias Current	I _{BIAIS}	-	-	40	100	-	40	200	nA
Input Common-Mode Voltage Range	V _{I(R)}	V _{CC} = 30V	0	-	V _{CC} - 2.0	0	-	V _{CC} - 2.0	V
Output Voltage Swing	V _{O(H)}	V _{CC} = 30V	R _L = 2kΩ	26	-	-	26	-	-
			R _L = 10kΩ	27	28	-	27	28	-
Large Signal Voltage Gain	G _V	V _{CC} = 15V, R _L = 2.0kΩ V _{O(P)} = 1V to 11V	25	-	-	15	-	-	V/mV
Output Current	I _{SOURCE}	V _{I(+)} = 1V, V _{I(-)} = 0V V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	10	30	-	10	30	-	mA
	I _{SINK}	V _{I(+)} = 1V, V _{I(-)} = 0V V _{CC} = 15V, V _{O(P)} = 2V	5	9	-	5	9	-	mA
Differential Input Voltage	V _{I(DIFF)}	-	-	-	V _{CC}	-	-	V _{CC}	V

LM2904,LM358/LM358A,LM268/LM258A

Typical Performance Characteristics

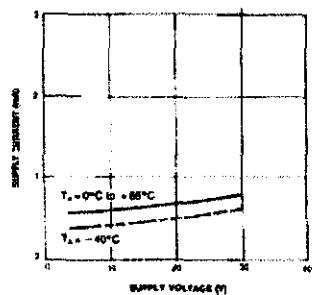


Figure 1. Supply Current vs Supply Voltage

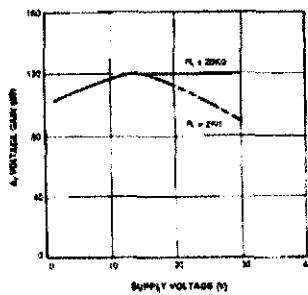


Figure 2. Voltage Gain vs Supply Voltage

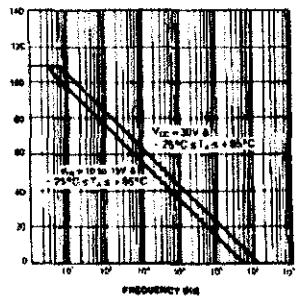


Figure 3. Open Loop Frequency Response

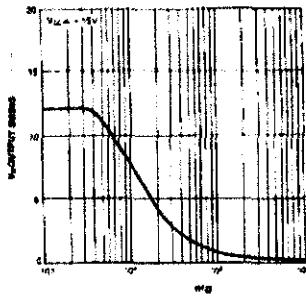


Figure 4. Large Signal Output Swing vs Frequency

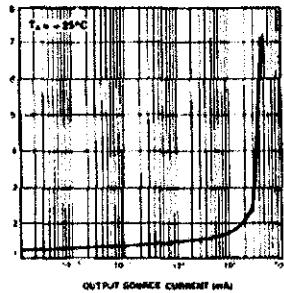


Figure 5. Output Characteristics vs Current Sourcing

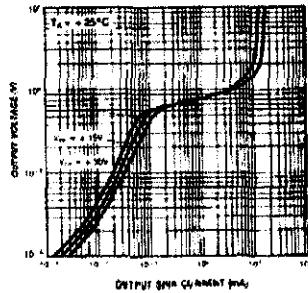


Figure 6. Output Characteristics vs Current Sinking

LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Typical Performance Characteristics (Continued)

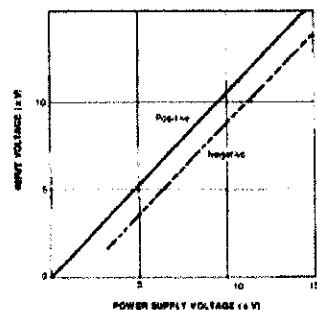


Figure 7. Input Voltage Range vs Supply Voltage

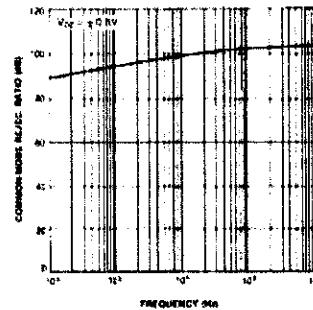


Figure 8. Common-Mode Rejection Ratio

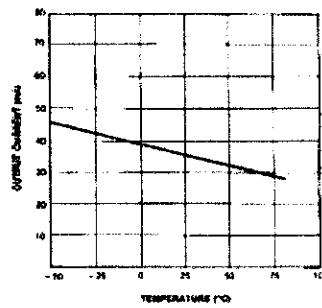


Figure 9. Output Current vs Temperature (Current Limiting)

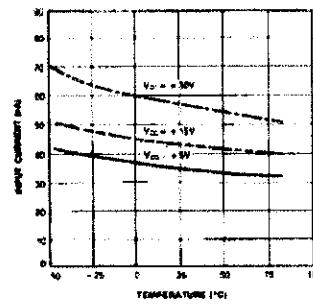


Figure 10. Input Current vs Temperature

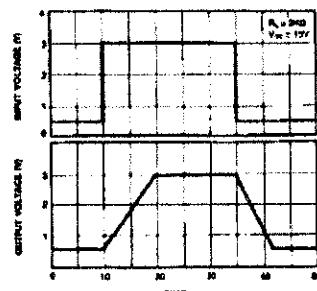


Figure 11. Voltage Follower Pulse Response

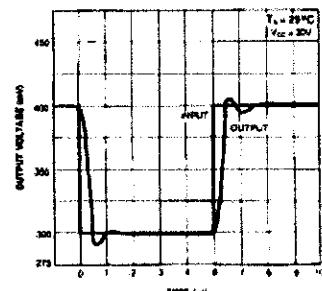


Figure 12. Voltage Follower Pulse Response (Small Signal)

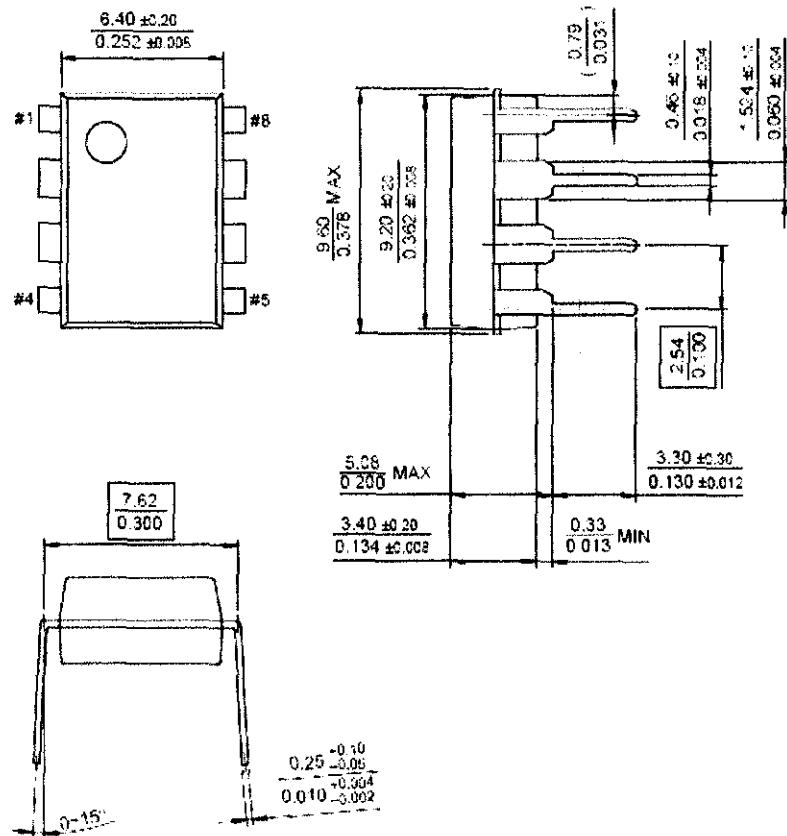
LM2904,LM358/LM358A,LM258/LM258A

Mechanical Dimensions

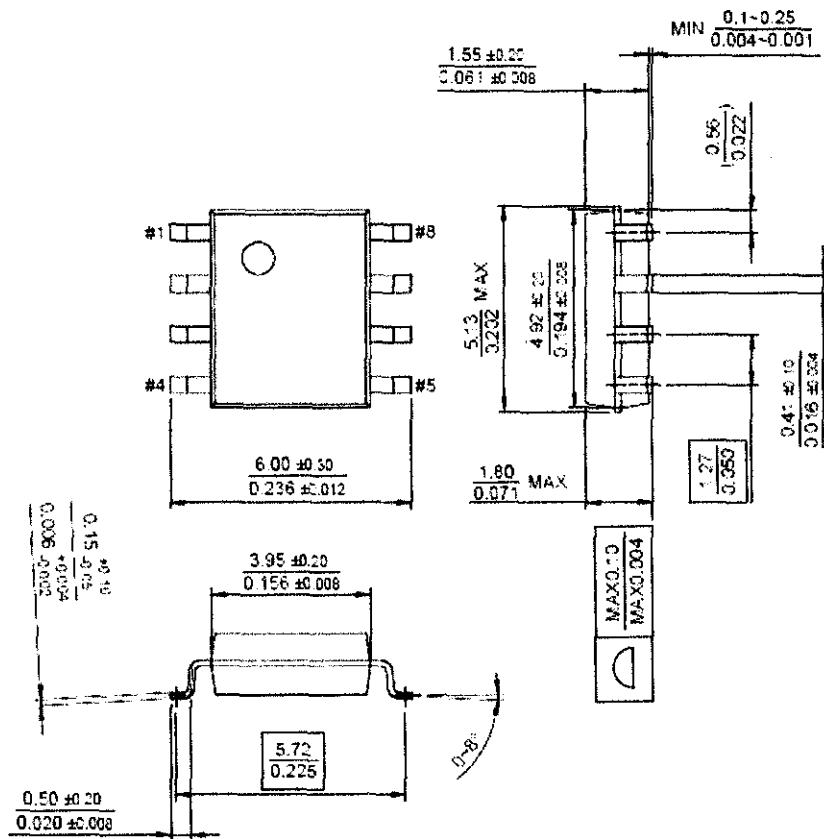
Package

Dimensions in millimeters

8-DIP



LM2904, LM358/LM358A, LM258/LM258A

Mechanical Dimensions (Continued)**Package****Dimensions in millimeters****8-SOP**

LM2904,LM358/LM358A,LM258/LM258A

Ordering Information

Product Number	Package	Operating Temperature	
LM358N	8-DIP	0 ~ +70°C	
LM358AN			
LM358M	8-SOP	-40 ~ +85°C	
LM358AM			
LM2904N	8-DIP	-25 ~ +85°C	
LM2904M	8-SOP		
LM258N	8-DIP	-25 ~ +85°C	
LM258AN			
LM258M	8-SOP		
LM258AM			

LM2904,LM358/LM358A,LM258/LM258A

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury of the user.
2. A critical component in any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

www.fairchildsemi.com

5/28/02 0.0m.001
Siced#CSxxxxxx
© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

 Order this document
 by 4N38/D


GlobalOptoisolator™


**6-Pin DIP Optoisolators
Transistor Output**

The 4N38 and 4N38A⁽¹⁾ devices consist of a gallium arsenide infrared emitting diode optically coupled to a monolithic silicon phototransistor detector.

- Guaranteed 80 Volt Collector-to-Emitter Breakdown ((BR)CEO)) Minimum
- Meets or Exceeds All JEDEC Registered Specifications
- To order devices that are tested and marked per VDE 0884 requirements, the suffix "V" must be included at end of part number. VDE 0884 is a test option.

Applications

- General Purpose Switching Circuits
- Interfacing and coupling systems of different potentials and impedances
- Monitor and Detection Circuits

MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise noted)

Rating	Symbol	Value	Unit
INPUT LED			
Reverse Voltage	V _R	3	Volts
Forward Current — Continuous	I _F	80	mA
Forward Current — Pk (PW = 300 µs, 2% duty cycle)	I _{F(pk)}	3	A
LED Power Dissipation @ TA = 25°C with Negligible Power in Output Detector Derate above 25°C	P _D	150	mW
		1.41	mW/°C
OUTPUT TRANSISTOR			
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	80	Volts
Emitter-Collector Voltage	V _{ECD}	7	Volts
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	80	Volts
Collector Current — Continuous	I _C	100	mA
Detector Power Dissipation @ TA = 25°C with Negligible Power in Input LED Derate above 25°C	P _D	150	mW
		1.76	mW/°C
TOTAL DEVICE			
Isolation Surge Voltage ⁽²⁾ (Peak ac Voltage, 60 Hz, 1 sec Duration)	V _{ISO}	7500	Vac(pk)
Total Device Power Dissipation @ TA = 25°C Derate above 25°C	P _D	250 2.94	mW mW/°C
Ambient Operating Temperature Range ⁽³⁾	T _A	-55 to +100	°C
Storage Temperature Range ⁽³⁾	T _{stg}	-55 to +150	°C
Soldering Temperature (10 sec, 1/16" from case)	T _L	260	°C

1. 4N38 does not require UL approval. 4N38A does. Otherwise both parts are identical. Both parts built by Motorola have UL approval.
2. Isolation surge voltage is an internal device dielectric breakdown rating.
For this test, Pins 1 and 2 are common, and Pins 4, 5 and 6 are common.
3. Refer to Quality and Reliability Section in Opto Data Book for information on test conditions.

Preferred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

Global Optoisolator is a trademark of Motorola, Inc.

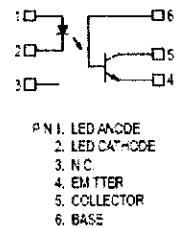
4N38
4N38A*

[CTR = 20% Min]

*Motorola Preferred Device

STYLE 1 PLASTIC

STANDARD THRU HOLE
 CASE 730A-04

SCHEMATIC


REV 2

© Motorola, Inc. 1995



4N38 4N38AELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)⁽¹⁾

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
INPUT LED					
Forward Voltage ($I_F = 10 \text{ mA}$)	V_F	—	1.15	1.5	Volts
$T_A = 25^\circ\text{C}$		—	1.3	—	
$T_A = -55^\circ\text{C}$		—	1.05	—	
$T_A = 100^\circ\text{C}$		—	—	—	
Reverse Leakage Current ($V_R = 3 \text{ V}$)	I_R	—	—	100	μA
Capacitance ($V = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$)	C_J	—	18	—	pF
OUTPUT TRANSISTOR					
Collector-Emitter Dark Current ($V_{CE} = 60 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)	I_{CEO}	—	20	50	nA
$V_{CE} = 60 \text{ V}$, $T_A = 100^\circ\text{C}$		—	6	—	μA
Collector-Base Dark Current ($V_{CB} = 60 \text{ V}$)	I_{CBO}	—	2	20	nA
Collector-Emitter Breakdown Voltage ($I_C = 1 \text{ mA}$)	$V_{(BR)CEO}$	80	120	—	Volts
Collector-Base Breakdown Voltage ($I_C = 1 \mu\text{A}$)	$V_{(BR)CBO}$	80	120	—	Volts
Emitter-Collector Breakdown Voltage ($I_E = 100 \mu\text{A}$)	$V_{(BR)ECO}$	7	7.6	—	Volts
DC Current Gain ($I_C = 2 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$)	HFE	—	400	—	—
Collector-Emitter Capacitance ($f = 1 \text{ MHz}$, $V_{CE} = 0$)	C_{CE}	—	8	—	pF
Collector-Base Capacitance ($f = 1 \text{ MHz}$, $V_{CB} = 0$)	C_{CB}	—	21	—	pF
Emitter-Base Capacitance ($f = 1 \text{ MHz}$, $V_{EB} = 0$)	C_{EB}	—	8	—	pF
COUPLED					
Output Collector Current ($I_F = 20 \text{ mA}$, $V_{CE} = 1 \text{ V}$)	$I_C (\text{CTR})^{(2)}$	4 (20)	7 (35)	—	mA (%)
Collector-Emitter Saturation Voltage ($I_C = 4 \text{ mA}$, $I_F = 20 \text{ mA}$)	$V_{CE(\text{sat})}$	—	—	1	Volts
Turn-On Time ($I_C = 2 \text{ mA}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$) ⁽³⁾	t_{on}	—	5	—	μs
Turn-Off Time ($I_C = 2 \text{ mA}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$) ⁽³⁾	t_{off}	—	4	—	μs
Rise Time ($I_C = 2 \text{ mA}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$) ⁽³⁾	t_r	—	2	—	μs
Fall Time ($I_C = 2 \text{ mA}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$) ⁽³⁾	t_f	—	3	—	μs
Isolation Voltage ($f = 60 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ sec}$) ⁽⁴⁾	V_{ISO}	7500	—	—	Volts(pk)
Isolation Resistance ($V = 500 \text{ V}$) ⁽⁴⁾	R_{ISO}	10 ¹¹	—	—	Ω
Isolation Capacitance ($V = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$) ⁽⁴⁾	C_{ISO}	—	0.2	—	pF

1. Always design to the specified minimum/maximum electrical limits (where applicable).

2. Current Transfer Ratio (CTR) = $I_C/I_F \times 100\%$.

3. For test circuit setup and waveforms, refer to Figure 11.

4. For this test, Pins 1 and 2 are common, and Pins 4, 5 and 6 are common.

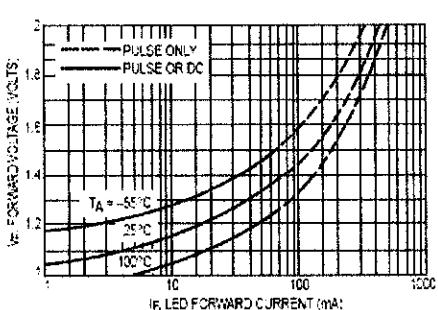
TYPICAL CHARACTERISTICS

Figure 1. LED Forward Voltage versus Forward Current

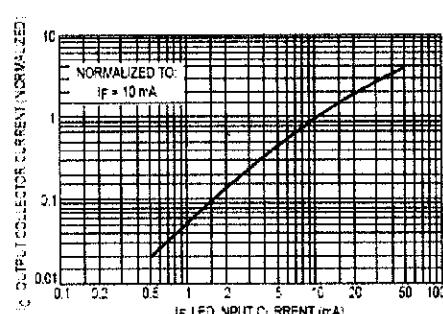


Figure 2. Output Current versus Input Current

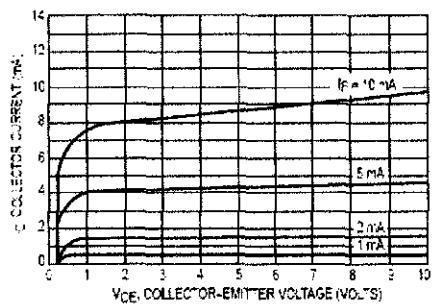


Figure 3. Collector Current versus
Collector-Emitter Voltage

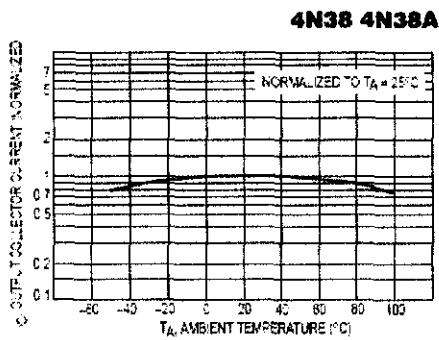


Figure 4. Output Current versus
Ambient Temperature

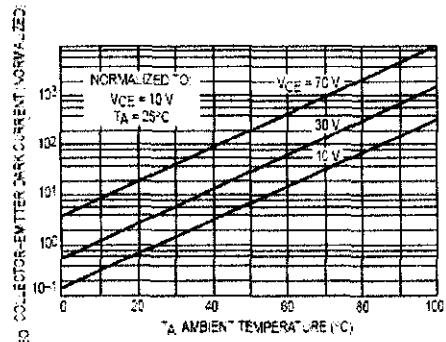


Figure 5. Dark Current versus
Ambient Temperature

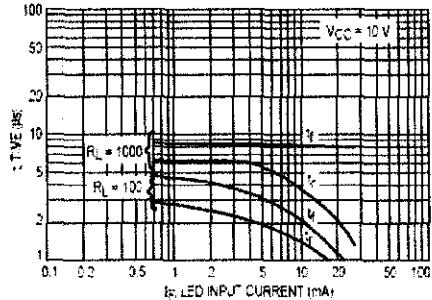


Figure 6. Rise and Fall Times
(Typical Values)

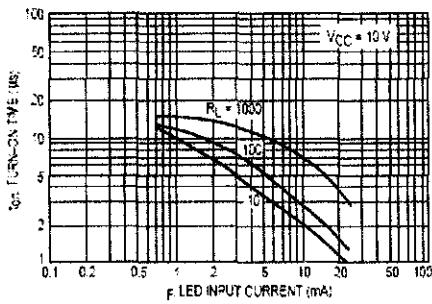


Figure 7. Turn-On Switching Times
(Typical Values)

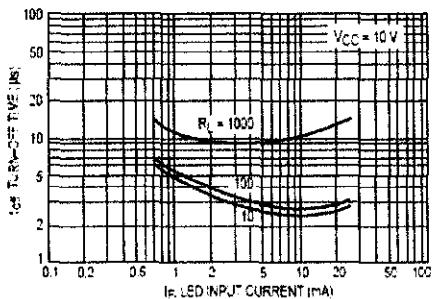


Figure 8. Turn-Off Switching Times
(Typical Values)

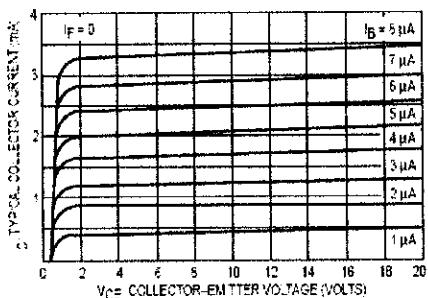
4N38 4N38A

Figure 9. DC Current Gain (Detector Only)

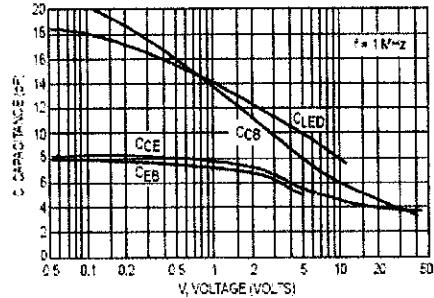


Figure 10. Capacitances versus Voltage

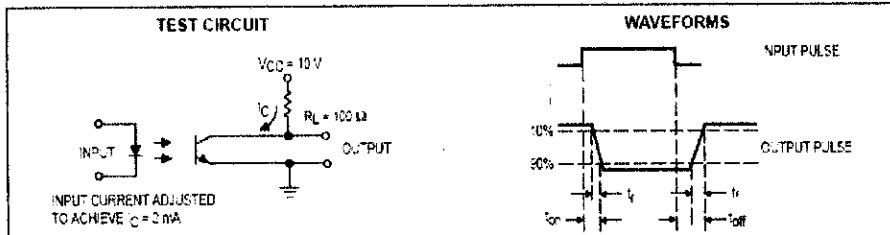
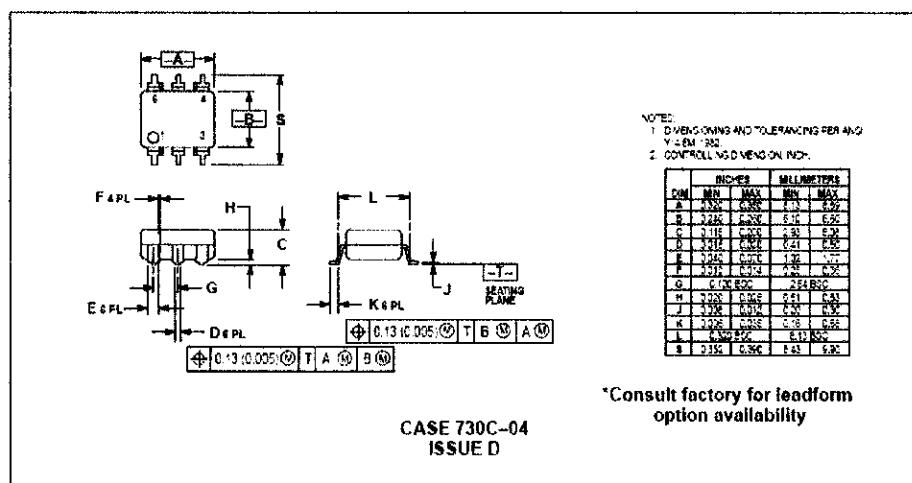
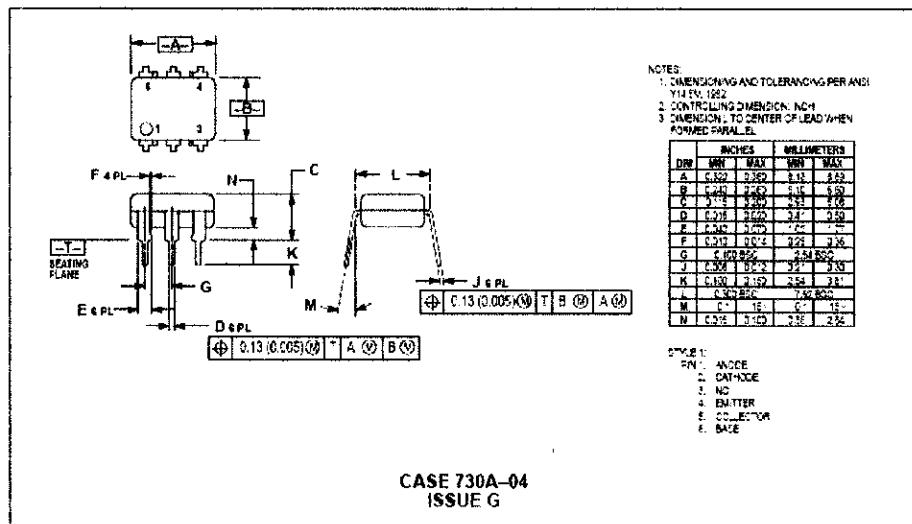


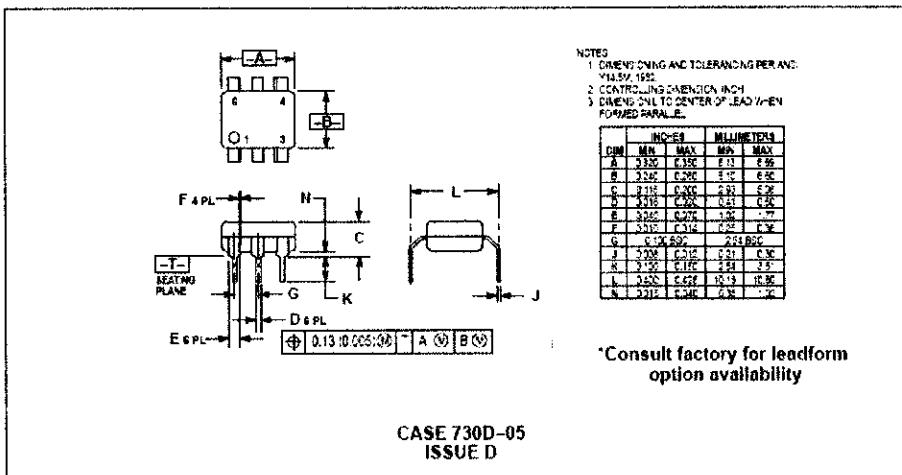
Figure 11. Switching Time Test Circuit and Waveforms

4N38 4N38A

PACKAGE DIMENSIONS



4N38 4N38A



Motorola reserves the right to make changes without further notice to any products herein. Motorola makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Motorola assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. "Typical" parameters can and do vary in different applications. All operating parameters, including "typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. Motorola does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Motorola products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the Motorola product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use Motorola products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold Motorola and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that Motorola was negligent regarding the design or manufacture of the part. Motorola and MC are registered trademarks of Motorola, Inc. Motorola, Inc. is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.

How to reach us:

USA/EUROPE: Motorola Literature Distribution:
P.O. Box 20912, Phoenix, Arizona 85088 1-800-441-2447

MFAX: RMFAX0@email.esps.mot.com - TOUCH-TONE (602) 244-6609
INTERNET: http://Design-NET.com

JAPAN: Nippon Motorola Ltd; Tatsun-SPD-JLDC Toshikatsu-Otsuki,
6F Seibu-Bldg.,-Center, 3-14-2 Tatsun-Koto-Ku, Tokyo 136 Japan. 03-3621-2816

HONG KONG: Motorola Semiconductors H.K. Ltd; 8B Tai Ping Industrial Park,
51 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong. 852-26622998



4N38/D

Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor**
IRFZ44N**GENERAL DESCRIPTION**

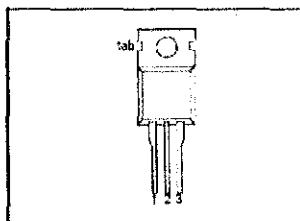
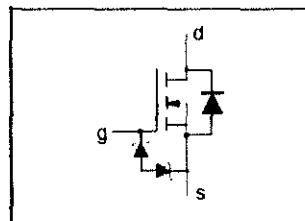
N-channel enhancement mode standard level field-effect power transistor in a plastic envelope using 'trench' technology. The device features very low on-state resistance and has integral zener diodes giving ESD protection up to 2kV. It is intended for use in switched mode power supplies and general purpose switching applications.

QUICK REFERENCE DATA

SYMBOL	PARAMETER	MAX.	UNIT
V_{DS}	Drain-source voltage	55	V
I_D	Drain current (DC)	49	A
P_{tot}	Total power dissipation	110	W
T_J	Junction temperature	175	°C
$R_{DS(on)}$	Drain-source on-state resistance $V_{GS} = 10\text{ V}$	22	$\text{m}\Omega$

PINNING - TO220AB

PIN	DESCRIPTION
1	gate
2	drain
3	source
tab	drain

PIN CONFIGURATION**SYMBOL****LIMITING VALUES**

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{DS}	Drain-source voltage	-	-	55	V
V_{DGN}	Drain-gate voltage	$R_{GS} = 20\text{ k}\Omega$	-	55	V
$\pm V_{GS}$	Gate-source voltage	-	-	20	V
I_D	Drain current (DC)	$T_{J\max} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	49	A
I_D	Drain current (DC)	$T_{J\max} = 100\text{ }^\circ\text{C}$	-	35	A
I_{DM}	Drain current (pulse peak value)	$T_{J\max} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	160	A
P_{tot}	Total power dissipation	$T_{J\max} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	-	110	W
T_{SS}, T_J	Storage & operating temperature	-	-55	175	$^\circ\text{C}$

ESD LIMITING VALUE

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_c	Electrostatic discharge capacitor voltage, all pins	Human body model (100 pF, 1.5 kΩ)	-	2	kV

THERMAL RESISTANCES

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	TYP.	MAX.	UNIT
$R_{\eta-jb}$	Thermal resistance junction to mounting base	-	-	1.4	K/W
$R_{\eta-ja}$	Thermal resistance junction to ambient	in free air	60	-	K/W

Philips Semiconductors

Product specification

N-channel enhancement mode TrenchMOS™ transistor

IRFZ44N

STATIC CHARACTERISTICS

T = 25°C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	
V_{BREDS}	Drain-source breakdown voltage	$V_{GS} = 0 \text{ V}; I_D = 0.25 \text{ mA}$	55	-	-	V	
$V_{GTO(-)}$	Gate threshold voltage	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 1 \text{ mA}$	50	-	-	V	
I_{SS}	Zero gate voltage drain current	$V_{DS} = 55 \text{ V}; V_{GS} = 0 \text{ V}$	2.0	3.0	4.0	V	
I_{SO}	Gate source leakage current	$V_{GS} = \pm 10 \text{ V}; V_{DS} = 0 \text{ V}$	$T_J = 175^\circ\text{C}$	1.0	-	V	
$\pm V_{BR(SO)}$	Gate source breakdown voltage	$I_G = \pm 1 \text{ mA}$	$T_J = -55^\circ\text{C}$	-	-	V	
$R_{DS(on)}$	Drain-source on-state resistance	$V_{GS} = 10 \text{ V}; I_D = 25 \text{ A}$	$T_J = 175^\circ\text{C}$	16	15	42	$\text{m}\Omega$

DYNAMIC CHARACTERISTICS

$T_{mp} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
g_s	Forward transconductance	$V_{DS} = 25 \text{ V}; I_D = 25 \text{ A}$	-	-	-	s
C_{ss}	Input capacitance	$V_{GS} = 0 \text{ V}; V_{DS} = 25 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	-	1350	1800	pF
C_{os}	Output capacitance		-	330	400	pF
C_{rd}	Feedback capacitance		-	155	215	pF
Q_g	Total gate charge	$V_{CC} = 44 \text{ V}; I_D = 50 \text{ A}; V_{GS} = 10 \text{ V}$	-	-	62	nC
Q_{gs}	Gate-source charge		-	-	15	nC
Q_{gd}	Gate-drain (Miller) charge		-	-	26	nC
t_{on}	Turn-on delay time	$V_{DD} = 30 \text{ V}; I_D = 25 \text{ A};$	-	18	26	ns
t_r	Turn-on rise time	$V_{GS} = 10 \text{ V}; R_G = 10 \Omega$	-	60	75	ns
t_{off}	Turn-off delay time	Resistive load	-	40	50	ns
t_f	Turn-off fall time		-	30	40	ns
L_d	Internal drain inductance	Measured from contact screw on tab to centre of die	-	3.5	-	nH
L_d	Internal drain inductance	Measured from drain lead 6 mm from package to centre of die	-	4.5	-	nH
L_s	Internal source inductance	Measured from source lead 6 mm from package to source bond pad	-	7.5	-	nH

REVERSE DIODE LIMITING VALUES AND CHARACTERISTICS

T₁ = 25°C unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
I_{DR}	Continuous reverse drain current		-	-	49	A
I_{DRM}	Pulsed reverse drain current		-	-	160	A
V_{SD}	Diode forward voltage	$I_F = 25 \text{ A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$ $I_F = 40 \text{ A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$	-	0.95	1.2	V
t_r Q_r	Reverse recovery time Reverse recovery charge	$I_F = 40 \text{ A}; -dI/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s};$ $V_{GS} = -10 \text{ V}; V_R = 30 \text{ V}$	-	47	-	ns μC

Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor**
IRFZ44N**AVALANCHE LIMITING VALUE**

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
W _{oss}	Drain-source non-repetitive unclamped inductive turn-off energy	I _D = 45 A; V _{SD} ≤ 25 V; V _{GS} = 10 V; R _{DS} = 50 Ω; T _{mb} = 25 °C	-	-	110	mJ

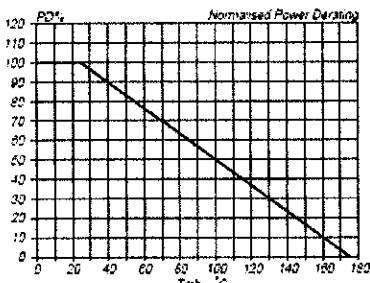


Fig. 1. Normalised power dissipation.
 $PD\% = 100 \frac{P_D}{P_{D,25}} \leq f(T_{mb})$

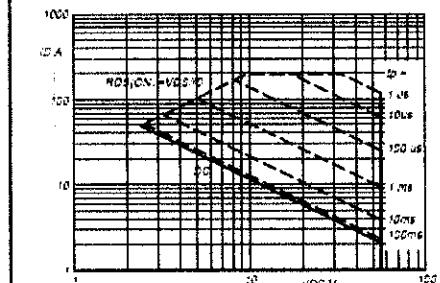


Fig. 3. Safe operating area. T_{mb} = 25 °C
 I_d & $I_{CM} = f(V_{DS})$; I_{CM} single pulse; parameter t_p

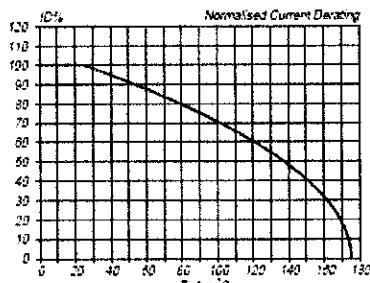


Fig. 2. Normalised continuous drain current
 $ID\% = 100 \frac{I_D}{I_{D,25}} \leq f(T_{mb})$; conditions: V_{GS} ≥ 10 V

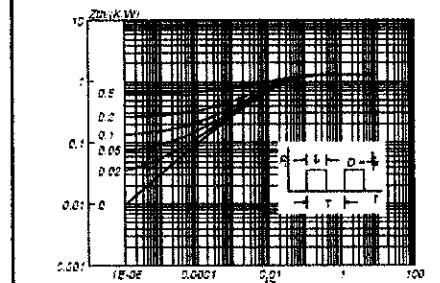


Fig. 4. Transient thermal impedance.
 $Z_{m,eff} = f(t)$; parameter D = t/T

Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor**

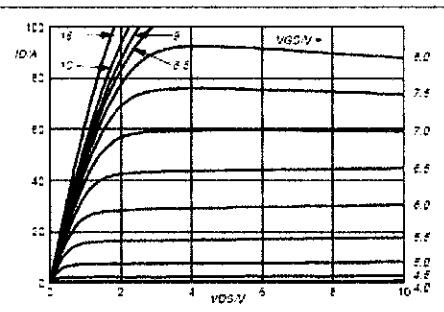
IRFZ44N

Fig. 5. Typical output characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$.
 $I_D = f(V_{GS})$; parameter V_{GS}

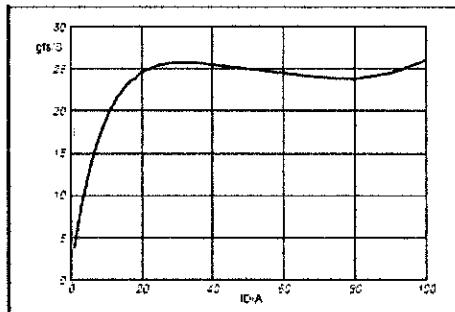


Fig. 8. Typical transconductance, $T_j = 25^\circ\text{C}$.
 $g_{fs} = f(I_D)$; conditions: $V_{GS} = 25\text{ V}$

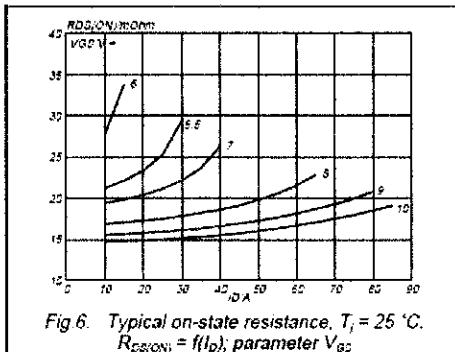


Fig. 6. Typical on-state resistance, $T_j = 25^\circ\text{C}$.
 $R_{DS(on)} = f(I_D)$; parameter V_{GS}

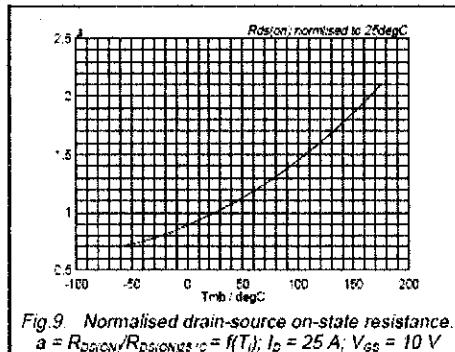


Fig. 9. Normalised drain-source on-state resistance.
 $a = R_{DS(25V)}/R_{DS(on)25^\circ\text{C}} = f(T_j)$; $I_D = 25\text{ A}$; $V_{GS} = 10\text{ V}$

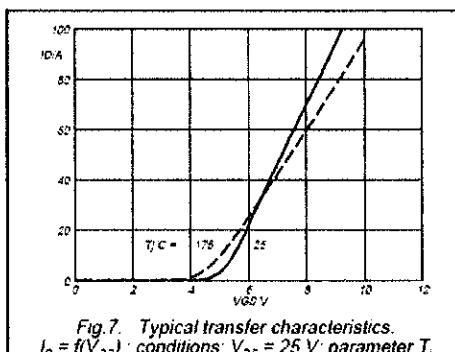


Fig. 7. Typical transfer characteristics.
 $I_D = f(V_{GS})$; conditions: $V_{DS} = 25\text{ V}$; parameter T_j

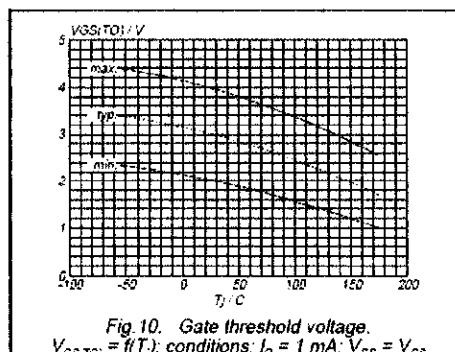
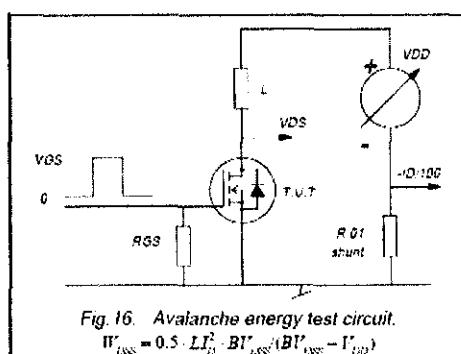
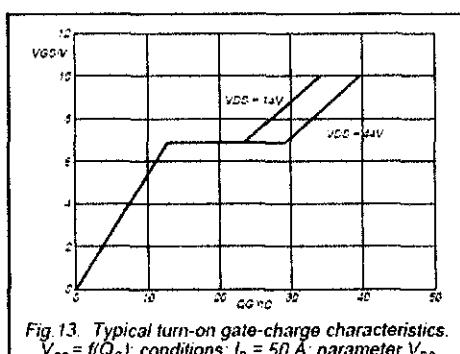
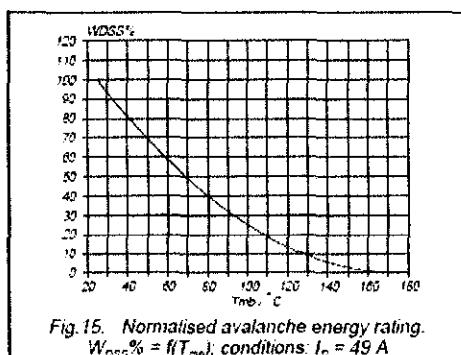
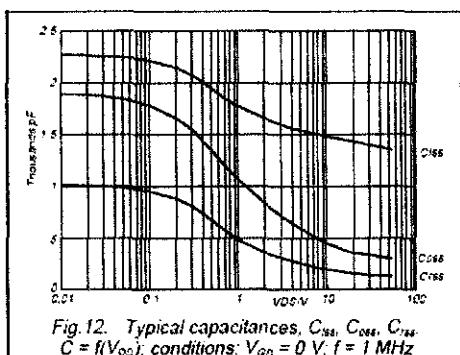
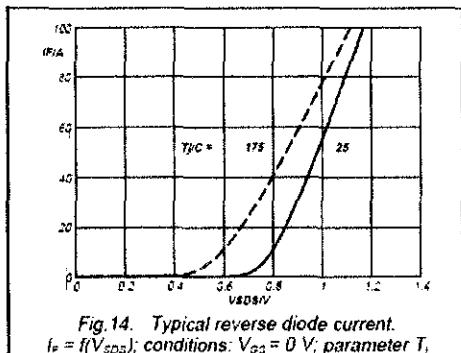
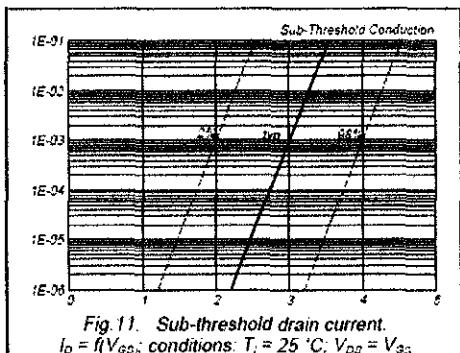


Fig. 10. Gate threshold voltage.
 $V_{GS(th)} = f(T_j)$; conditions: $I_D = 1\text{ mA}$; $V_{GS} = V_{GS}$

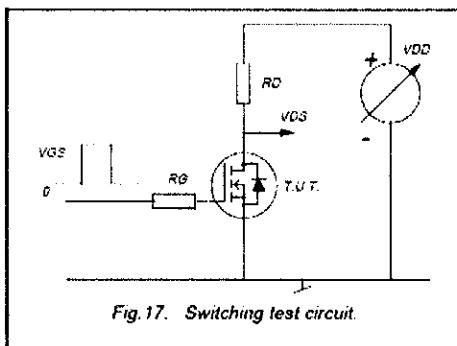
Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor**
IRFZ44N

Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor****IRFZ44N***Fig. 17. Switching test circuit.*

Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor**

IRFZ44N

MECHANICAL DATA

Dimensions in mm

Net Mass: 2 g

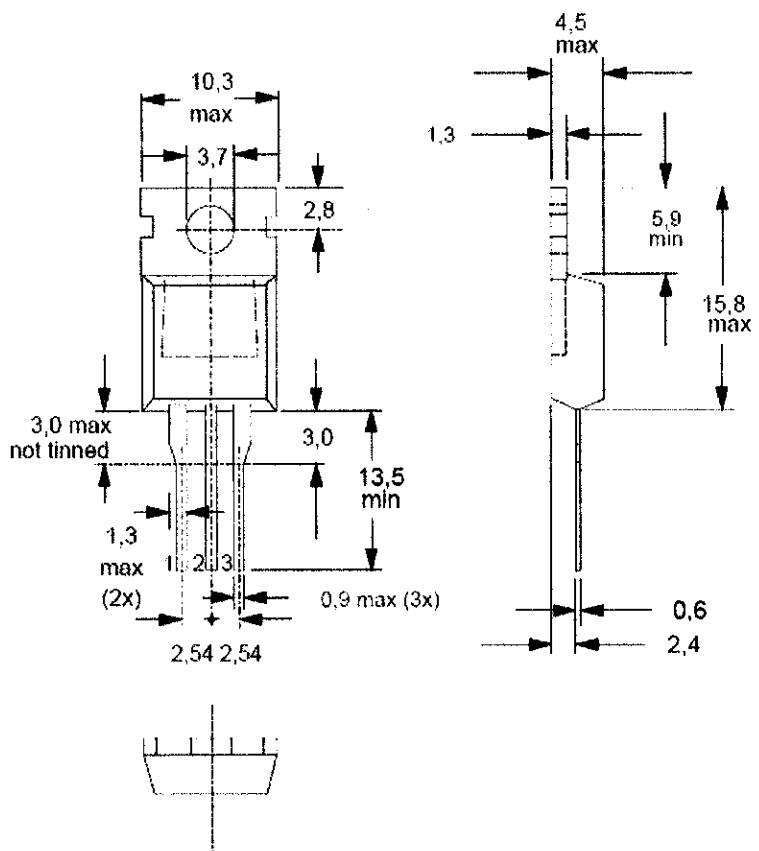


Fig.18. SOT78 (TO220AB); pin 2 connected to mounting base.

Notes

1. Observe the general handling precautions for electrostatic-discharge sensitive devices (ESDs) to prevent damage to MOS gate oxide.
2. Refer to mounting instructions for SOT78 (TO220) envelopes.
3. Epoxy meets UL94 V0 at 1/8".

Philips Semiconductors

Product specification

**N-channel enhancement mode
TrenchMOS™ transistor**

IRFZ44N

DEFINITIONS

Data sheet status	
Objective specification	This data sheet contains target or goal specifications for product development.
Preliminary specification	This data sheet contains preliminary data; supplementary data may be published later.
Product specification	This data sheet contains final product specifications.
Limiting values	
Limiting values are given in accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). Stress above one or more of the limiting values may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and operation of the device at these or at any other conditions above those given in the Characteristics sections of this specification is not implied. Exposure to limiting values for extended periods may affect device reliability.	
Application information	
Where application information is given, it is advisory and does not form part of the specification.	
<input checked="" type="checkbox"/> Philips Electronics N.V. 1999 All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, it is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual property rights.	

LIFE SUPPORT APPLICATIONS

These products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Philips customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Philips for any damages resulting from such improper use or sale.

ET-BASE AVR ATmega64/128

ET-BASE AVR ATmega64/128 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ของบริษัท Atme ซึ่งบอร์ดนี้เลือกใช้ MCU เมอร์ ATmega64 และ ATmega128 ขนาด 64 Pin โดยในบอร์ด ET-BASE AVR ATmega64/128 มีช่องเม้นบาร์ใช้งานที่พื้นที่ทางขวาของตัว MCU เช่นเป็นหลัก ซึ่งจะมี การต่อขาสัญญาณ I/O ออกมาก็ต่ำเรียงไปเป็นพertz PA,PB,PC,PD,PE,PF และพertz ET-CLCD .พื้นที่ทางขวาของตัวบอร์ดใช้งาน พื้นที่ที่ต้องหันรับความโน้มถ่วงในอุดหนูภายนอก ขนาดจากนี้ยังได้เพิ่มวงจรไฟฟ้าอย่าง RS-232 เต้าไปเก็บยังพื้นที่ด้านหลังตัวบอร์ดอยู่กับช่อง RS-232 ได้ภายในและจะดูว่าอย่างไร

คุณสมบัติของบอร์ด

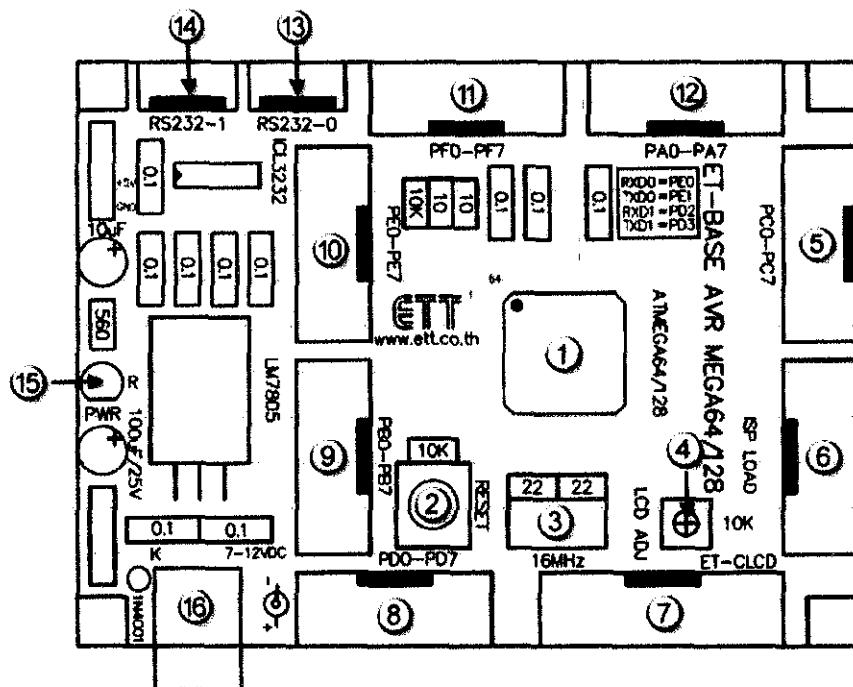
- เลือกใช้ MCU ตระกูล AVR เมอร์ ATmega64 , ATmega128 ของ Atme ซึ่งเป็น MCU ขนาด 8-Bit โดยเลือกใช้เมล็ดกำเนิดสัญญาณมาที่แกน XTAL ค่า 16 MHz ซึ่ง คุณสมบัติเด่น ๆ ของ MCU ได้แก่
 - มีหน่วยความจำ Flash สำหรับรีบันโปรแกรม 64 KBytes สำหรับ ATmega64 และ 128K Bytes สำหรับ ATmega128 และมี RAM 4 KBytes
 - มีหน่วยความจำสำหรับข้อมูลการทำงาน EEPROM ขนาด 2K Bytes สำหรับ ATmega64 และ 4 K Bytes สำหรับ ATmega128 สำหรับการอ่านและรีบันข้อมูลมากกว่า 100,000 ครั้ง
 - จำนวน I/O สูงสุดถึง 53 I/O Pins
 - มีวงจรสื่อสาร SPI จำนวน 1 ช่อง , I2C จำนวน 1 ช่อง , Programmable Serial USARTs จำนวน 2 ช่อง
 - มี ADC ขนาด 10-Bit จำนวน 8 ช่อง
 - มี Timers/Counters 8-Bit จำนวน 2 ช่อง , Timers/Counters 16-Bit จำนวน 2 ช่อง , 8-Bit PWM 2 ช่อง , Watchdog Timer , Real Time Counter
- I/O PORT 10 PIN จำนวน 6 PORT ดังนี้ PA,PB,PC,PD,PE,PF
- พertz ISP LOAD สำหรับโปรแกรม MCU (ต้องใช้กับ ET-AVR ISP หรือเครื่องโปรแกรม ISP ซึ่งมีการจัดรีบันข้อมูลสัญญาณเหมือนกัน)
- วงจร Line Driver สำหรับพertzสื่อสารภายนอก RS232 จำนวน 2 ช่อง โดยรีบันที่อยู่ที่ สัญญาณ PE0(RXD0) และ PE1(TXD0) จำนวน 1 ช่อง ส่วนที่เหลืออีก 1 ช่อง จะต้องต่อ สัญญาณ PD2(RXD1) และ PD3(TXD1) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถต่อหอดต่อหากต้องการสื่อสาร RS232

คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128

ETT

- วงจรใช้อุปกรณ์แสดงผล LCD แบบ Character (ET-CLCD) พร้อม VR ปรับความสว่างของ LCD ซึ่งใช้การเรียนรู้ของกับ LCD แบบ 4 Bit Interface
- วงจร Regulate ขนาด +5V / 1A สำหรับใช้งานบินแหล่งจ่ายไฟเดิมๆ ให้กับ จอแสดงผล LCD และอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ที่ใช้บันแหล่งจ่ายขนาด +5V พร้อม LED แสดงสถานะดำเนินการ
- ขนาด PCB Size เล็กเพียง 8 X 6 cm

โครงสร้างของบอร์ด



- หมายเลข 1 คือ MCU เทคโนโลยี ATmega64 หรือ ATmega128 ซึ่งเป็น MCU ตระกูล AVR จาก ATMEL
- หมายเลข 2 คือ Switch RESET ใช้สำหรับ Reset การทำงานของ MCU
- หมายเลข 3 คือ Crystal ค่า 16 MHz
- หมายเลข 4 คือ ตัวสำเนาท่านสำหรับปรับค่าความสว่างให้ LCD
- หมายเลข 5 คือ PORTC มีขนาด 8 Bit คือ PC0-PC7
- หมายเลข 6 คือ พอดuct ISP LOAD สำหรับดาวน์โหลด Hex File ให้กับ MCU

- หมายเลข 7 คือ พорт ET-CLCD สำหรับเพื่อการรับ LCD ชนิด Character Type ซึ่งให้การรับข้อมูลแบบ 4 Bit
- หมายเลข 8 คือ PORTD มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PD0-PD7
- หมายเลข 9 คือ PORTB มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PB0-PB7
- หมายเลข 10 คือ PORTE มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PE0-PE7
- หมายเลข 11 คือ PORTF มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PF0-PF7
- หมายเลข 12 คือ PORTA มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PA0-PA7
- หมายเลข 13 และ 14 คือ ช่อง RS232 สำหรับใช้งานทั่วไป
- หมายเลข 15 คือ LED Power ใช้สำหรับแสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟ +5VDC
- หมายเลข 16 คือ ช่องแบล็คจ่ายไฟสำหรับเส้นสายจราจรของบอร์ด

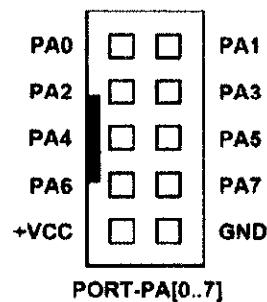
ช่องสัญญาณต่าง ๆ

สำหรับช่องสัญญาณของพอร์ต I/O จาก MCU นี้จะถูกออกแบบและจัดเตรียมไว้สำหรับช่องแบบ IDC-Header ขนาด 10 Pin (2x5) จำนวน 6 ชุด คือ PA,PB,PC,PD,PE,PF ตามลำดับ โดยที่ช่องสัญญาณแต่ละชุด จะประกอบไปด้วยสัญญาณของ I/O ที่เชื่อมต่อมาจากชิปสัญญาณของ MCU โดยตรงทั้งหมด โดยจุดเดียวที่ต้องกับสัญญาณภายนอกบอร์ดมีดังนี้

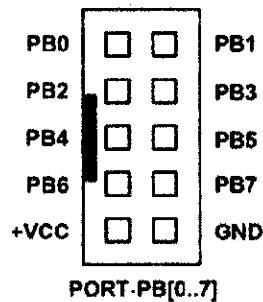
- ช่องแบล็คจ่ายไฟสำหรับเส้นสายจราจรของบอร์ด
- ช่อง PORTA มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PA0-PA7
- ช่อง PORTB มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PB0-PB7
- ช่อง PORTC มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PC0-PC7
- ช่อง PORTD มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PD0-PD7
- ช่อง PORTE มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PE0-PE7
- ช่อง PORTF มีขนาด 8 Bit ตั้งแต่ PF0-PF7
- ช่อง ET-CLCD สำหรับเพื่อการรับ LCD ชนิด Character Type
- ช่อง RS232 จำนวน 2 ช่อง โดยช่องที่ 1 กับสัญญาณ PE0(RXD0) และ PE1(TXD0) จำนวน 1 ช่อง ส่วนที่เหลืออีก 1 ช่อง จะต่อ กับสัญญาณ PD2(RXD1) และ PD3(TXD1) เพื่อให้ได้รับความสามารถของการติดต่อสื่อสาร RS232
- ช่อง ISP LOAD ใช้สำหรับดาวน์โหลด Hex File ให้กับ MCU

คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128

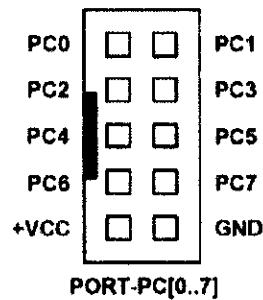
พอร์ต PA มีขาต่อ 8 บิต



พอร์ต PB มีขาต่อ 8 บิต

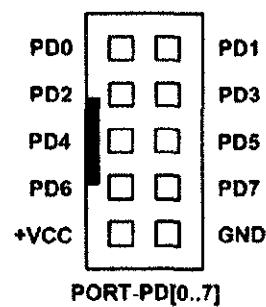


พอร์ต PC มีขาต่อ 8 บิต

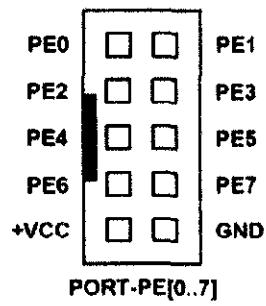


คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128

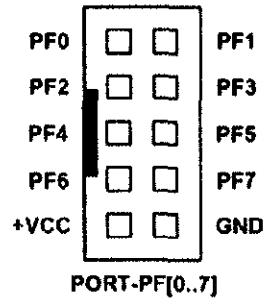
พอร์ต PD มีขาout 8 บิต

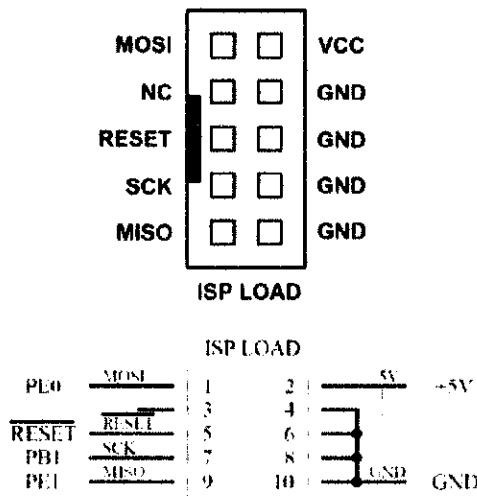


พอร์ต PE มีขาout 8 บิต

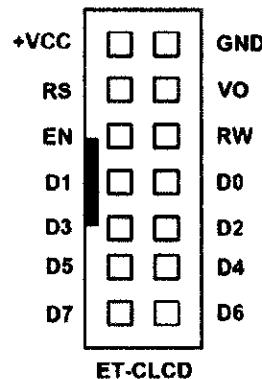


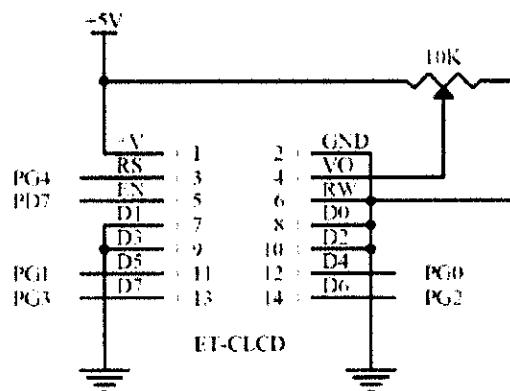
พอร์ต PF มีขาout 8 บิต



พอร์ต ISP LOAD**รูปแสดง วงจรส่วนที่เชื่อมต่อ กับ ISP LOAD**

พอร์ต ET-CLCD ให้กับ Character Type LCD โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ 4 บิต โดยสัญญาณที่ใช้ เชื่อมต่อ กับ LCD จะเป็นสัญญาณจากพาร์ต PG และ PD (PD7) โดยในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ จากชุดต่อของพอร์ต LCD ไปยังจอแสดงผล LCD นั้นให้ยึดเชือข้าวสัญญาณเป็นจุดข้างซ้าย โดยให้ต่อ สัญญาณที่มีชื่อตรงกันเข้าด้วยกันในครบทั้ง 14 เส้น

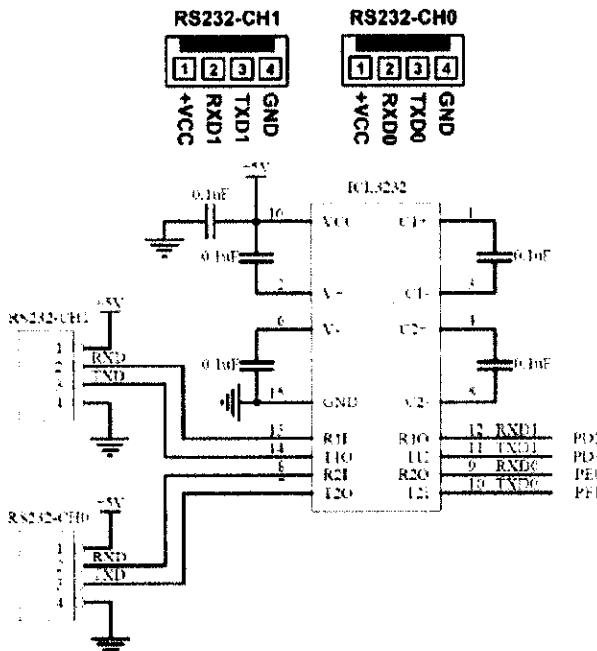




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GND	+VCC	VO	RS	RW	EN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7

แสดงการจัดเรียงขาสัญญาณของ Character LCD มาตรฐาน

พอร์ต RS232 จำนวน 2 ช่อง โดยที่ช่องต่อรับสัญญาณ PE0(RXD0) และ PE1(TXD0) จำนวน 1 ช่อง ส่วนที่ 2 ช่อง : ช่อง จะต่อรับสัญญาณ PD2(RXD1) และ PD3(TXD1)



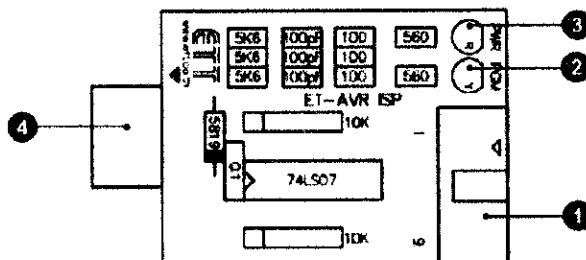
รูปแสดง วงจรส่วนที่เชื่อมต่อกับ RS232

คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128

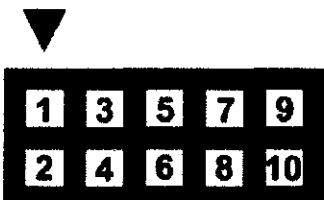
การดาวน์โหลด Hex File ให้กับ MCU

การดาวน์โหลด Hex File ให้กับ MCU นั้นจำเป็นจะต้องใช้ ET-AVR ISP หรือเครื่องโปรแกรมแบบ ISP ที่มี AVRISP ของ ATMEL เพื่อใช้ในการดาวน์โหลด Hex File ให้กับ MCU ตระกูล AVR อาทิ Atmel โดยใช้วิธีการแบบ Serial Programming ซึ่งการดาวน์โหลด Hex File ไม่สามารถใช้ ET-AVR ISP จะกระทำผ่านทางพอร์ต串行ของคอมพิวเตอร์ โดยที่จะต้องใช้งานควบคู่กับ ET-CAP10P ของอีที ฯ และ Software ที่ใช้ควบคู่กับ ET-AVR ISP ก็คือ PonyProg2000 ซึ่ง PonyProg2000 เป็นโปรแกรม Download ข้อมูลแบบ HEX File ให้กับ CPU ตระกูล AVR โดยใช้วิธีการแบบ Serial Programming ซึ่งสามารถใช้งานร่วมบอร์ดตระกูล AVR ของ อีที ฯ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องต่อสาย Serial ให้กับชุด AVR ทุกทุนของ อีที ฯ ที่มีความสามารถในการดาวน์โหลดตระกูล AVR ทุกทุนของ อีที ฯ

โครงสร้างของบอร์ด ET-AVR ISP



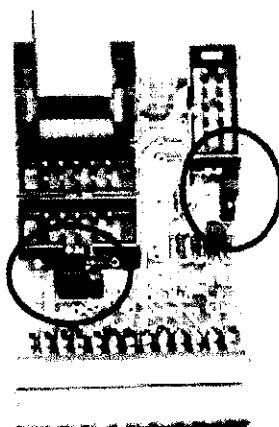
- หมายเลข 1 คือ พอยต์สำหรับเชื่อมต่อ กับ ET-CAP10P ของ อีที ฯ เพื่อโปรแกรม Hex File ให้กับ MCU
- หมายเลข 2 คือ LED PGM (สีเขียว) แสดงสถานะของการโปรแกรมหรือดาวน์โหลด Hex File ลง MCU
- หมายเลข 3 คือ LED PWR (สีแดง) แสดงสถานะของไฟลีบบอร์ด
- หมายเลข 4 คือ พอยต์สำหรับเชื่อมต่อ กับ Target ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม Hex File ให้กับบอร์ด ET-AVR STAMP ATmega64 โดยเส้นบอร์ด ET-AVR ISP เข้ากับพอร์ต ET-PSPI ซึ่งมีการจัดเรียงขาสัญญาณเดียวกัน



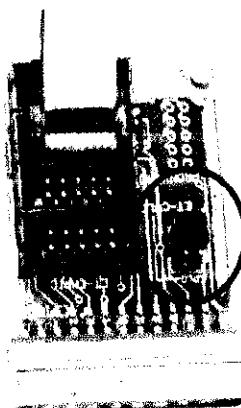
ตำแหน่งขา	ชื่อสัญญาณ
1	MOSI
2	VCC
3	ไม่ได้ใช้งาน
4,6,8,10	GND
5	RESET
7	SCK
9	MISO

การเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับโปรแกรม Hex File

การโปรแกรมได้ดั้ง (Hex File) ให้กับ AVR MCU ที่อยู่ใช้งานร่วมกับ ET-CAB10PIN และโปรแกรม PonyProg2000 โดยต่อ ET-CAP10PIN เข้ากับพอร์ต Parallel Port พร้อมทั้งสื้อก Jumper สำหรับใช้งานกับโปรแกรม PonyProg2000 เมื่อต้องดาวน์โหลด (Download) ที่ใช้กับ ET-PSPI Download ของบอร์ด พร้อมทั้งถ่ายไฟเข้าบอร์ดที่ต้องบอร์ด ถ้ามีการต่ออุปกรณ์ภายนอกที่พกดัก PB ให้ปลดออกก่อน โดยการเชื่อมต่อจะมีลักษณะดังรูปด้านไปนี้



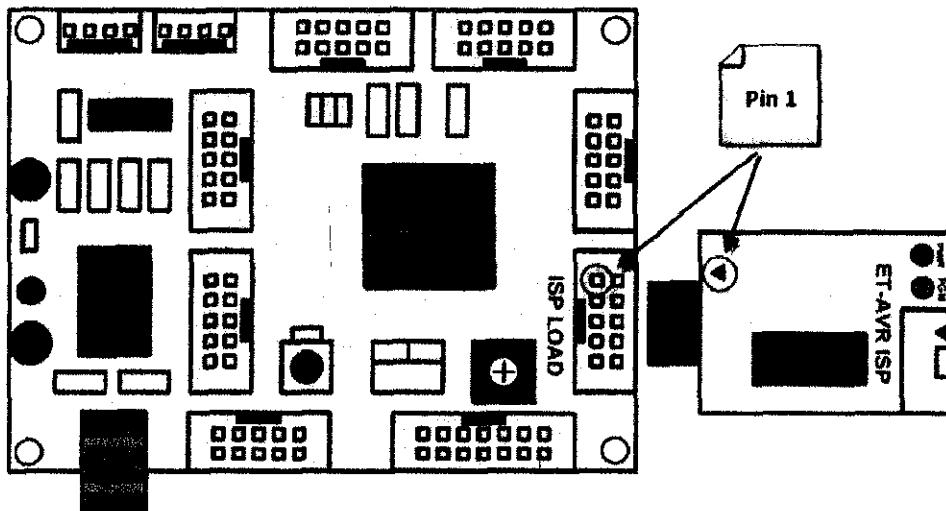
(a) ET-CAP10P V2.0



(b) ET-CAP10P V1.0

รูปแสดง การต่อ Jumper และการต่อสาย Download ของ ET-CAP10P ที่ใช้กับ AVR

คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128



ขั้นตอนการต่อ ET-AVR ISP เข้ากับ ET-BASE AVR ATmega64/128 โดยการต่อบอร์ดที่ต้องส่องเข้าด้วยกันนี้จะให้สังเกตที่ค่าແນา่งขา 1 จะต้องตรงกัน

1.12 Program ไฟ Board ET-BASE AVR ATmega64/128 ด้วยโปรแกรม PonyProg2000

โปรแกรม PonyProg2000 เป็นโปรแกรม Download รูปแบบ HEX File ให้กับ CPU ตระกูล AVR โดยใช้วิธีการ serial Serial Programming ซึ่งสามารถใช้งานกับบอร์ดตระกูล AVR ของ ETT ได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการใช้งานโปรแกรมโดยทั่วไปนั้น สามารถศึกษาได้จาก Help ของโปรแกรมได้เอง โดยในที่นี้จะแนะนำให้ทราบถึงวิธีการ Setup โปรแกรม PonyProg2000 .เพื่อใช้งานกับบอร์ดตระกูล AVR ของ ETT ซึ่งสามารถใช้งานได้กับบอร์ดตระกูล AVR ทุกรุ่นอย่างดีที่สุด

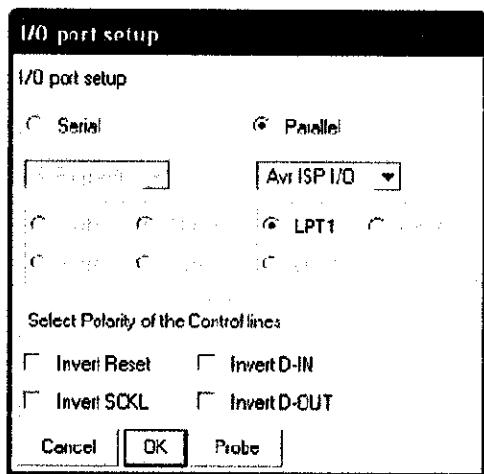
สำหรับการที่ใช้ CPU ตระกูล AVR แบบ ATmega64 นั้น จะมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่ง เนื่องจากโครงสร้างภายในของ ATmega64 นั้นจะมี Fuse Bit สำหรับกำหนดเงื่อนไขการทำงานของ CPU รวมอยู่ด้วยหน่วยบิต ซึ่ง Fuse Bit ต่างๆเหล่านี้ บางบิตจะมีผลต่อการ Download แบบ Serial Programming ด้วย เนื่องจากถ้าเลือกกำหนดคุณสมบัติของ Fuse Bit ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่สามารถสั่งโปรแกรม CPU ด้วยวิธีการ Serial Programming ได้ ฉะนั้น ยกเว้นจะเขียนโปรแกรม CPU ด้วยเครื่องโปรแกรมแบบ Parallel ไม่ได้คำนึงถูกต้องเสียก่อน

โดยในการสั่งโปรแกรม CPU ตระกูล AVR ที่ใช้งานกับบอร์ดของเรา ยังที่นั้น ถ้าใช้การโปรแกรมด้วยโปรแกรมชื่อ "PonyProg2000" จะต้องกำหนด Option ของโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานกับบอร์ดของเรา ยังที่นี้ ดังนี้

คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128

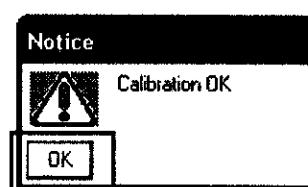
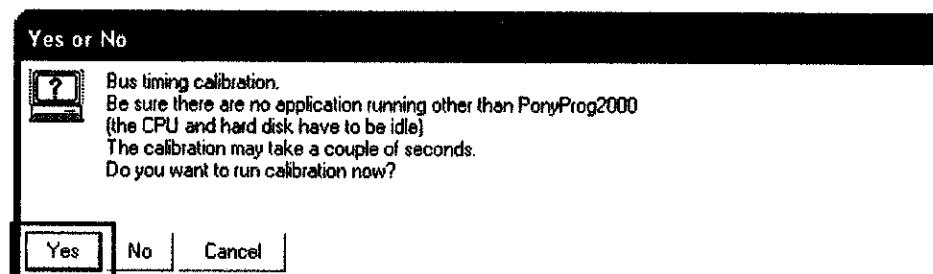


1. ดำเนินการ Setup → Interface Setup... เป็นดังนี้



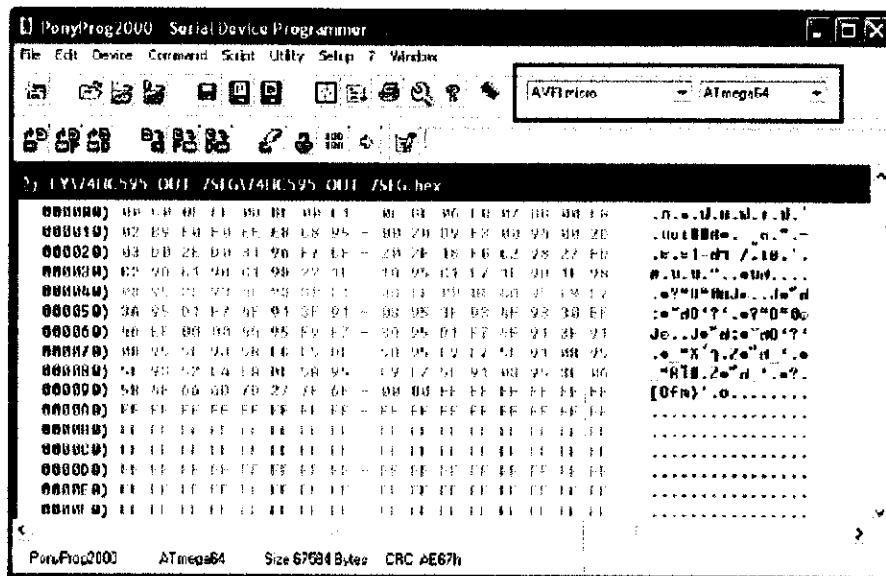
- ให้เลือก I/O Port เป็น Parallel และเลือกรูปแบบการโปรแกรมเป็น Avr ISP I/O
- ให้เลือก Printer Port ตามที่ต้องการ เช่น LPT1 ในกรณีที่ต้องการ Printer Port LPT1
- สอนขา Out Polarity Control Line ไม่ต้องเลือก
- กดการ Setup นี้ทำเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มใช้งาน ไม่ต้องกู้รุ่นในครั้งแรกเท่านั้น

2. สำหรับโปรแกรม PonyProg2000 ทำการคำนวณหาค่าความเร็วที่เหมาะสมส่วนของ CPU ให้ในกากบาทสัญญาณไปยังหน่วย CPU โดยเลือกจาก Setup → Calibration

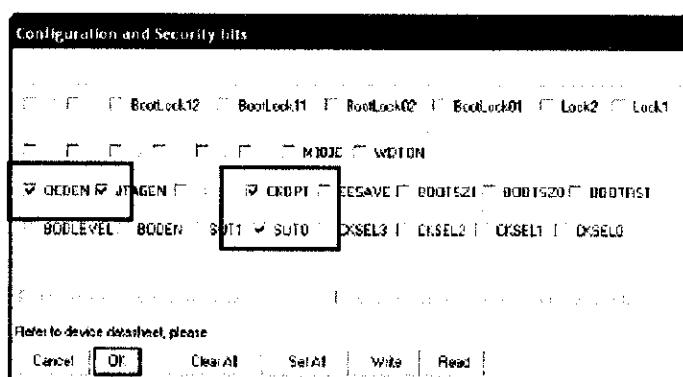


- การสร้าง Calibration จะกระทำการเพียงครั้งเดียวในขณะที่เราลงเครื่องเริ่มใช้งานในระบบครั้งแรกเท่านั้น

3. เลือกกำหนดเบอร์ CPU จากรหัส Device → AVR Micro → เลือก Atmega64



4. เลือกกำหนด Command → Security and Configuration Bits โดยถ้าเป็น AVR เมอร์ชินๆ สามารถกำหนดการทำงานของ Fuse Bit ได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของ Fuse Bit ที่มาให้จาก Data Sheet ของ CPU ที่ใช้ได้ เช่น แต่ในกรณีที่ใช้งานกับ Atmega64 นั้นต้องรู้เม็ดความจำในการเลือกกำหนด Fuse Bit ไม่ถูกต้องด้วย ซึ่งถ้ากำหนดผิดอาจส่งผลไม่เป็นสามารถสั่งโปรแกรม CPU ผ่านวิธีการ Serial Programming ได้ยาก โดยที่กำหนดเป็นดังนี้



ขั้นตอน 4 การเลือกกำหนด Fuse Bit เพื่อใช้กับ CPU เมอร์ชิน ATmega64

ความหมายของ Fuse Bit ต่างๆของ ATmega64

- ในกรณีที่เลือก [✓] ที่หน้า Fuse Bit ตัวใด หมายถึงการกำหนดให้ Fuse Bit นั้นๆ มีค่าเป็น "0" หรือการสั่งโปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ
- ในกรณีที่ไม่เลือก [✓] ที่หน้า Fuse Bit ตัวใด หมายถึงการกำหนดให้ Fuse Bit นั้นๆ มีค่าเป็น "1" หรือสั่งไม่โปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ

ความหมายของ Fuse Bit ของ ATmega64 ที่มีผลต่อ Serial Programming

- SPIEN เป็น Serial Programming Enable Bit ซึ่งจะต้องสั่งโปรแกรม Fuse Bit นี้ให้เสมอ เพื่อให้สามารถสั่ง Download โปรแกรมให้รับ CPU ด้วยวิธีการ On-System Serial Programming ได้ ซึ่งตามปกติแล้ว Fuse Bit นี้จะถูกสั่งโปรแกรมมาจากโรงงานอยู่แล้ว และไม่สามารถตั้งค่าใหม่หรือแก้ไข Fuse Bit นี้ได้ด้วยโหมด Serial Programming เมื่อต้องการเปลี่ยน CPU ไปโปรแกรมตัวเดียวแบบ Parallel Programming จะต้องไม่ลืมสั่ง โปรแกรม Fuse Bit นี้ให้ด้วยเสมอทุกครั้ง
- OCDEN และ JTAGEN ทั้งสองบิตนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการ Debug การทำงานของ MCU และโปรแกรมผ่านทาง JTAG Interface ซึ่งต้องร่วมกับ AVR JTAG Debugger ที่ต้องได้รับงานกิมจ้ามเป็นตัวกลางเลือกตั้งสองบิตนี้
- CKOPT เป็น Oscillator Option Bit สำหรับโปรแกรม Fuse Bit นี้จะเป็นการกำหนดให้ CPU ทำงานที่周波ความถี่ 16MHz เมื่อต้องได้รับโปรแกรม Fuse Bit นี้จะเป็นการกำหนดให้ CPU ทำงานที่周波ความถี่ 8MHz ซึ่งถ้าให้กับบอร์ดมาตรฐานของอีซิที จะใช้ XTAL เป็นแหล่งกำเนิดความถี่ ดังนั้นควรสั่งโปรแกรมค่า Fuse Bit นี้ไว้เพื่อให้ CPU สามารถทำงานได้ที่周波ความถี่ของ XTAL ตั้งแต่ 1.0MHz-16.0MHz
- CKSEL3...0 เป็น Select Clock Source Bit ใช้ร่วมกันสำหรับเลือกแหล่งกำเนิดและยัง ข้อความนี้ที่จะใช้รับ CPU ซึ่งในกรณีให้รับบอร์ดมาตรฐานของอีซิที ต้องเลือกเป็น External Crystal ที่ 1.0 MHz - 16.0 MHz ซึ่งถ้าเลือกเป็นอย่างอื่นจะทำให้การทำงาน ของโปรแกรมผิดพลาด และที่สำคัญถ้าเลือกแหล่งกำเนิดความถี่ผิด เช่น เลือกเป็น External Clock หรือ External RC Oscillator จะทำให้ CPU ไม่สามารถทำงานได้ เมื่อออกจากเมืองการต่อสายภายนอกให้ไว้ และจะนำไปไม่สามารถ สั่งโปรแกรม CPU ตัวนี้ด้วยวิธีการแบบ Serial Programming ได้อีก จะเกิดอะไร

หากเรา CPU ไม่ต้องค่า Fuse Bit เพื่อเลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาเป็น External Crystal ให้รูปดังนี้ดีจะดีกว่านี้

แหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของ AVR Atmega64	การกำหนด Fuse Bit ของ CKSEL[3...0]
(0=Program, 1=Un-Program)	
External Crystal/Ceramic Resonator	1111-1010
External Low Frequency Crystal	1001
External RC Oscillator	1000-0101
Calibrated Internal RC Oscillator	0100-0001
External Clock	0000

ตารางแสดง การเลือกแหล่งกำเนิดความถี่จาก Fuse Bit CKSEL [3...0]

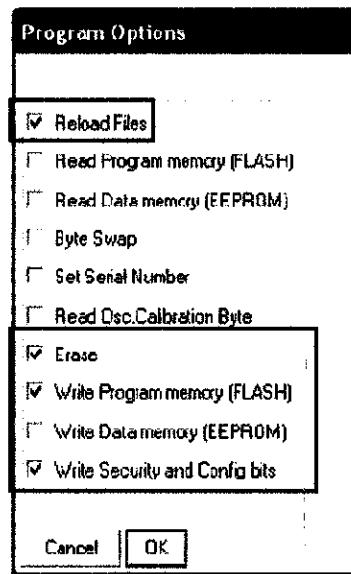
หมายเหตุ

- ค่า 1 หมายถึง การสั่งไปโปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย [~] หน้า Fuse Bit
- ค่า 0 หมายถึง การสั่งไปโปรแกรม Fuse Bit นั้นๆ โดยการใส่เครื่องหมาย [~] หน้าค่า Fuse Bit
- ควรสั่งไปrogramm Fuse Bit ของ CKOPT เพื่อให้ไปใช้งานที่ช้ากว่าความถี่ 1.0MHz-16.00MHz
- ห้ามสั่งไปrogramm Fuse Bit ของ CKSEL[3..0] เพราะจะทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าต้องการสั่ง ถ้าเลือกสั่งไปrogramm Fuse Bit ของ CKSEL[3..0] ให้มีค่าเป็น 0 ทั้งหมด ซึ่ง หลังจากไปrogramm PonyProg2000 ทำการเรียกค่า Fuse Bit เป็นทั้งหมด CPU เริ่มน้อยแล้ว จะทำให้ CPU ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดของ อินเตอร์วิช แต่จะไม่สามารถสั่งไปrogramm แก้ไขค่า Fuse Bit ในไฟทั้งหมด CPU ด้วยวิธีการแบบ Serial Programming ได้อีก เมื่อจาก CPU ไม่สามารถทำงานได้อีก เพราะว่าการสั่งไปrogramm Fuse Bit ของ CKSEL[3..0] ให้ เป็น 0 ทั้งหมด จะเป็นการสั่งให้ CPU ทำงานด้วยความถี่ของสัญญาณนาฬิกาจากภายนอก (External Clock) ซึ่งจะทำให้หัวจรดก้านบีดความถี่ของ External Crystal บดค หัวงาน โดย CPU จะขอรับสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และบอร์ด ของ อินเตอร์วิช จะใช้สัญญาณนาฬิกาจาก วงจร Crystal (External Crystal) (หัวนั้น ตั้งน้ำมือของ CPU ไม่สามารถเขียนตั้งหัวงานไปได้ ก็จะทำให้เราไม่สามารถสั่งไปrogramm แก้ไขค่า Fuse Bit ที่ถูกต้องให้กับ CPU ด้วยวิธีการแบบ Serial Programming ได้อีก ซึ่งจะต้องนำ CPU ตัว นั้น ไปทำการแก้ไขค่า Fuse Bit ด้วยเครื่องไปrogrammแบบ Parallel เสียก่อนจึงจะสามารถ นำมามาใช้งานกับวิธีการไปrogrammแบบ Serial Programming ได้เมื่อตอนเดิม
- สำหรับ Fuse Bit ของ Lock[2..1] สามารถกำหนดได้ตามต้องการ

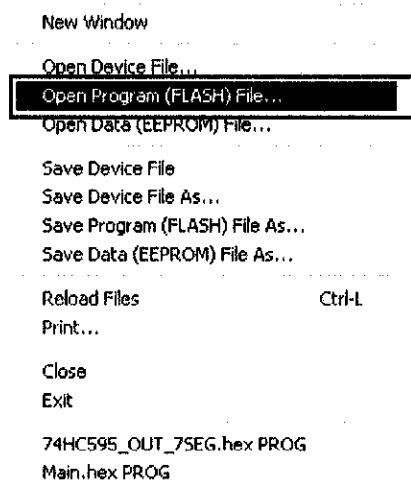
คู่มือการใช้งาน ET-BASE AVR ATmega64/128

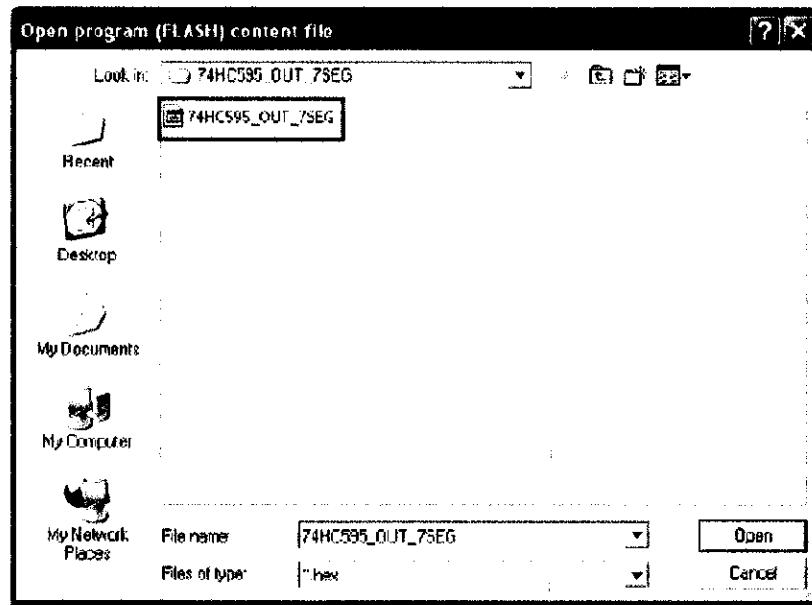


5. เลือกคำสั่ง Command → Program Option เป็นดังนี้

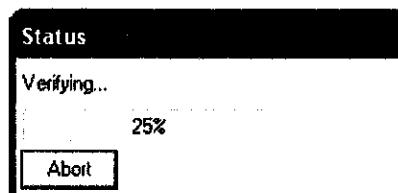


6. คลิกไฟล์สำหรับที่จะใช้โปรแกรมให้กับ CPU โดยเลือกจาก File → Open Program (FLASH)
File... → พิจารณาที่จะซื้อและต้องการ HEX File ที่จะนำไปrogramให้เรียบร้อย

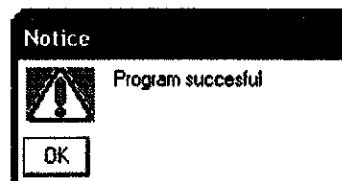




7. รังสีเมมที่นับไปร่างรูปข้อมูลให้กับ CPU โดยเลือก Command → Program จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการติดต่อสื่อสารกับหน่วยความจำชุดที่ 5 หรือ Load File → Erase → Write Program memory (FLASH) และ Write Security and Config Bits ตามลำดับ ซึ่งให้รอจนกว่าการทำงานของโปรแกรมเสร็จและบุกเบิก



↓



ใช้หน้าจอการโปรแกรมเครื่องเรียบไฟข้อมูล CPU จะเริ่มต้นท่องงานตามชั้นๆ กลับในไป ตามที่สั่ง Down load ให้ทันที

การตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้

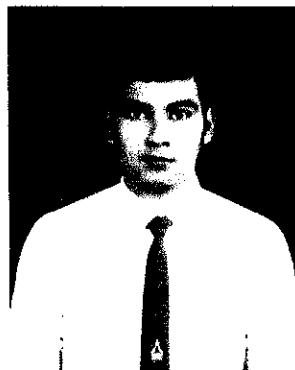
ถ้าเกิดการ Error ในขั้นตอนของກำไร้โปรแกรมให้ตรวจสอบดูหาดังนี้

- ยานคูมือการใช้งานบอร์ด และคูมือวิธีการ Download ในชุด AVR ตัวชุด PonyProg2000 ให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบการต่อสายของสายสัญญาณต่างๆ และ ในการ Download โปรแกรมโดยใช้ PonyProg2000 นั้น จะต้องใช้สายรวมกับชุด Cable Download รุ่น ET-CAP10PIN ของ ETT ตัวชุดนี้จะต้องมีการตัวหนา JUMPER ให้มี 1 ขาเท่านั้น (รายละเอียดหน้า 9)
- ควรตรวจสอบไฟ LED ที่ติดต่อ กับบอร์ด
- ควรตรวจสอบตัวต่อทางเข้าของโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลด PonyProg2000
- ควรลองเปลี่ยนนำสัญญาณจากพอร์ต PORT-PB ของ CPU ไปต่อไปกับอุปกรณ์ภายนอก ในขณะที่ Download หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตากับ LED หรือ นำสัญญาณจากพอร์ต PB ไปต่อให้กับวงจรซึ่นนำไปในขณะที่ Download ชื่อคล้าย
- ในควรต่อสายสัญญาณ RS232 นำมายังพอร์ต RS232-CH0 เพื่อจัดการโปรแกรมแบบ SPI ของ ATMEGA64 จะใช้ขาสัญญาณร่วมกับ RS232 (RXD0,TXD0)

ประวัติผู้จัดทำ



นางสาวภาณุทรา คำพิคุล เกิดเมื่อวันคุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลลดโขหอ อำเภอเมืองครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโทรคมนາคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



นายศรันย์ คัมภีรภัทร เกิดเมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลลดลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโทรคมนາคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

